ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υποβληθείσα στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

υπό του

Αθανασίου Παπαγεωργίου

Υπεύθυνος: Επ. Καθ. Χρήστος Αργυρούσης

Αθήνα, Φεβρουάριος 2012

Πρόλογος

Η εκπόνηση της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανόργανων Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ανάθεση του θέματος έγινε από τον Επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ Χρήστο Αργυρούση.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μου σε όσους με βοήθησαν και συνέβαλαν στην περάτωση της παρούσας εργασίας.

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και θερμά, τον επιβλέποντα της εργασίας μου, Επ. Καθ. Χρήστο Αργυρούση, που μου έδωσε την ευκαιρία να αγαπήσω και να καταπιαστώ με το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας. Ευχαριστώ για την εμφανή διάθεσή του να προσφέρει την επιστημονική, αλλά και προσωπική του βοήθεια και κυρίως για το αμέριστο ενδιαφέρον του.

Ευχαριστώ θα ήθελα να πω επίσης στον, υποψήφιο διδάκτορα στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανόργανων Υλικών του ΕΜΠ, Πέτρο Σακκά, που από την αρχή υπήρξε δίπλα μου, προσφέροντας πάντα με μεγάλη προθυμία τη βοήθεια, τις συμβουλές και κυρίως την ενθάρρυνση του.

Ακόμα, ευχαριστώ τα υπόλοιπα μέλη του εργαστηρίου και τους φίλους μου, που ήταν πρόθυμοι να προσφέρουν τη βοήθεια τους όπου και αν χρειάστηκε.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με βοήθησε και με στήριξε μέχρι τώρα σε κάθε μου βήμα.

Περιεχόμενα

Ποόλογος		2
Πεοιεχόμεν	να	3
Γοαφήματα	χ	5
Πίνακες		6
Εικόνες		7
Περίληψη		10
Abstract		11
1 Θεωρητ	τικό Μέρος	12
1.1 Εισ	σαγωγή στο φαινόμενο της διάχυσης	12
1.2 По	ροσεγγίσεις και είδη διάχυσης	13
1.3 Mr	ηχανισμοί Διάχυσης	14
1.3.1	Μηχανισμοί άμεσης ανταλλαγής (Direct interchange)	15
1.3.2	Ενδοπλεγματικοί μηχανισμοί	17
1.3.3	Μηχανισμοί κενών θέσεων	18
1.3.4 όφιο κό	Μηχανισμοί Σωλήνα διαταφαχής (Dislocation pipe diffusion), Διάχυσησ σκκων (Grain boundary diffusion) και Επιφανειακής διάχυσης	ς στο 20
1.4 Συ	νντελεστής Διάχυσης	20
1.5 Por	ή σωματιδίων (flux) – Εξισώσεις Fick	21
1.5.1	1ος Νόμος Fick	21
1.5.2	2ος Νόμος Fick	22
1.6 Μέ	έθοδος SIMS	23
1.6.1	Αρχή λειτουργίας	23

1.6.2 Πλεονεκτήματα2	5
1.6.3 Μειονεκτήμ <i>α</i> τα2	6
1.6.4 Σύγκριση με άλλες μεθόδους2	7
1.7 Πειφαματική διάταξη και διαδικασία αέφιας διάχυσης σε στεφεά κατάσταση2	8
2 Πειραματικό Μέρος3	1
2.1 Σχεδιασμός τραπεζιών με χρήση του προγράμματος Solidworks	1
2.2 Εγκατάσταση φούςνου και των αντιστοίχων γαγών του	5
2.3 Εγκατάσταση διπλού σταυξού (double cross) και αντιδραστήρα	7
2.4 Θερμοκρασιακά προφίλ φούρνου4	1
2.4.1 Εγκατάσταση και συνδεσμολογία θερμοστοιχείων-καλωδίων ποοέκταση (extension wires) για τον έλεγχο της θερμοκρασιακής απόκρισης τους μέσα θερμοκρασιακών προφίλ4	ις ω
2.4.2 Εγκατάσταση δειγματοφοφέα και βφαχίονα (manipulator) στον διπλό σταυφ και έλεγχος συμβατότητας διαφόφων καλωδίων πφοέκτασης (extension wires) μ θεφμοστοιχείο τύπου Β5	ό ιε 0
2.4.3 Θερμοκρασιακό προφίλ στους 1000 °C για τον φούρνο Nabertherm5	4
2.4.4 Τελικά θεφμοκρασιακά προφίλ για τον έλεγχο της θερμοκρασιακή απόκρισης του φούρνου5	⊊ 7
2.4.5 Συμπεφάσματα6	6
2.5 Εγκατάσταση αντλιών και εξαρτημάτων τεχνολογίας κενού6	6
2.5.1 Συνδεσμολογία περιστροφικής αντλίας6	6
2.5.2 Εγκατάσταση και συνδεσμολογία τουρμπομοριακής αντλίας7	0
2.5.3 Εγκατάσταση μετρητή πίεσης (transducer) και καταγραφικού ρυθμιστ (vacuum controller)7	ή '3
2.6 Πειφαματική διαδικασία παφαγωγής κενού7	'5
2.6.1 Διάγραμμα πίεσης-χρόνου για τάπα (Blind KF) στον διπλό σταυρό	7

	2.6.2	Διάγραμμα πίεσης-χρόνου για τάπα σε σωλήνα 6 mm (tube cover), που είναι
	εγκατεσ	στημενος στον διπλο σταυξο
	2.6.3	Διάγραμμα πίεσης-χρόνου για εγκατεστημένη φιάλη O_{18} (Oxygen bottle)82
	2.6.4	Συνολικό διάγραμμα σύγκρισης πίεσης-χρόνου85
	2.6.5	Συμπεράσματα
3	Εφαομα	γές - προτάσεις για μελλοντική έρευνα88
	3.1 Με <i>ι</i>	λέτη διάχυσης οξυγόνου σε πυριτικό ύττριο (yttrium silicate)88
	3.2 Ava	απροσαρμογή της πειραματικής διάταξης διάχυσης με χρήση ενός συστήματος
	ανάμειξηα	5 αερίων
4	Βιβλιογ	<i>ρ</i> αφί <i>α</i> 91
5	Παράρτ	ημ <i>α</i> 92
	5.1 Εγχ	ζειρίδιο χρήσης ουθμιστή φούονου92
	5.1.1	Εύρεση Τύπου Θερμοστοιχείου (TC)93
	5.1.2	Θερμοπρογραμματισμός Φούρνου94
	5.1.3	Χρήσιμες πληροφορίες96
	5.2 Πίν	ακες αναφοράς για θερμοστοιχεία97

Γραφήματα

Γράφημα 2: Θερμοκρασιακό προφίλ στους 1000 °C, για τον έλεγχο καλωδίων προέκτασης (extension wires) συνδεδεμένα με θερμοστοιχείο τύπου B (Long Pt18)......53

Πίνακες

Πίνακας 1: Μηχανισμοί διάχυσης	.15
Πίνακας 2: Αποτελέσματα πειραμάτων διαδικασίας παραγωγής κενού	.76
Πίνακας 3: Μέγιστες επιτρεπόμενες ιδιότητες του φούρνου	.92
Πίνακας 4: Οι Τύποι Θερμοστοιχείων και το αντίστοιχο Θερμοκρασιακό τους Εύρος	.93
Πίνακας 5: Συντομογραφίες του Front Panel του Ρυθμιστή	.94
Πίνακας 6: Πίνακας αναφοράς για θερμοστοιχεία τύπου Β	.98
Πίνακας 7: Πίνακας αναφοράς για θερμοστοιχεία τύπου Κ	100

Εικόνες

Εικόνα 1: Μηχανισμός ανταλλαγής (Exchange mechanism)	16
Εικόνα 2: Μηχανισμός δακτυλιδιού (Ring mechanism)	16
Εικόνα 3: Interstitial mechanism	17
Εικόνα 4: Interstitialcy mechanism	18
Εικόνα 5: Vacancy mechanism	19
Εικόνα 6: Βασική αρχή λειτουργίας μεθόδου SIMS	24
Εικόνα 7: Διάταξη κύφιων μεφών μεθόδου SIMS	25
Εικόνα 8: Πειραματική διάταξη διάχυσης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ανόργανα Υλικών του ΕΜΠ	υν 28
Εικόνα 9: Σχεδιαστική απεικόνιση του μεγάλου πλαισίου στήριξης της πειραματικ διάταξης	ής 32
Εικόνα 10: Σχεδιαστική απεικόνιση του μικοού πλαισίου στήριξης της πειραματικ διάταξης	ής 32
Εικόνα 11: Σχεδιαστική απεικόνιση του μικοού πλαισίου στήριξης της πειραματικ διάταξης (3D)	ής 33
Εικόνα 12: Προσχέδιο πειραματικής διάταξης για την επαλήθευση της διαστασιολόγησ της	ης 34
Εικόνα 13: Ράγες φούονου (Oven sliders)	35
Εικόνα 14: Φούρνος	37
Εικόνα 15: Βάση στήριξης διπλού σταυρού	38
Εικόνα 16: Βάση στήριξης διπλού σταυρού σε 3 διαστάσεις (3D)	39
Εικόνα 17: Κεραμικός αντιδραστήρας	40
Εικόνα 18: Εξαρτήματα για φλάντζες κενού (vacuum flange fittings)	41
Εικόνα 19 : Φούρνος-αντιδραστήρας- διπλός σταυρός	41
Εικόνα 20: Θερμοστοιχεία & καλώδια προέκτασης	43

Εικόνα 21: Ρυθμιστής φούǫνου (Controller)44
Εικόνα 22: Ηλεκτρική σύνδεση φούρνου-ρυθμιστή44
Εικόνα 23: Εγκατάσταση θερμοστοιχείου τύπου Κ45
Εικόνα 24: Οπή σε βάση αμιάντου και προστατευτικό μέταλλο
Εικόνα 25: Εγκατάσταση θερμοστοιχείου τύπου Β47
Εικόνα 26: Συνολική εγκατάσταση θεομοστοιχείων για προσδιορισμό θερμοκρασιακού προφίλ
Εικόνα 27: Απεικόνιση θεομοστοιχείου τύπου Κ μέσα στον φούονο με θεομομόνωση από μαλλί πυοιτικού αργιλίου (aluminum silicate wool)48
Εικόνα 28: Εγκατάσταση και συνδεσμολογία δειγματοφορέα & βραχίονα (manipulator) στον διπλό σταυρό
Εικόνα 29: Φούονος Nabertherm
Εικόνα 30: Αντικατάσταση του blue type K (συμβατό με θερμοστοιχεία τύπου K) με το Cu extension wire (συμβατό με θερμοστοιχεία τύπου B)58
Εικόνα 31: Κεφαμική βάση (μουλίτη) στήφιξης δειγματοφοφέα
Εικόνα 32: Ένωση δειγματοφορέα – χάλκινου καλωδίου προέκτασης (Cu extension wire) μέσω γρήγορων συνδέσεων, που συνδέονται με ηλεκτρική κόλληση (soldering)61
Εικόνα 33: Πειφαματική διάταξη πφοσδιοφισμού των τελικών θεφμοκφασιακών πφοφίλ του φούφνου, με σταθεφοποιημένο δειγματοφοφέα, και θεφμοστοιχείο τύπου Β (Long Pt18) που έχει τη δυνατότητα να σύφεται κατά μήκος του
Εικόνα 34: Ψύξη της μεταλλικής βάσης του κεφαμικού αντιδφαστήφα με τη χφήση θεφμοστάτη
Εικόνα 35: Διάταξη αντλιών67
Εικόνα 36: Σημεία λειτουργίας της περιστροφικής αντλίας67
Εικόνα 37: Εξαρτήματα στο σημείο αναρρόφησης της περιστροφικής αντλίας (suction connection fittings)
Εικόνα 38: Εξαρτήματα στο σημείο κατάθλιψης της περιστροφικής αντλίας (Pressure connection fittings)

Εικόνα 39: Συνδεσμολογία περιστροφικής αντλίας70
Εικόνα 40: Βάση τουρμπομοριακής αντλίας71
Εικόνα 41: Του ρμπομοριακή αντλία & CF σταυρός71
Εικόνα 42: Εγκατάσταση και συνδεσμολογία τουομπομοοιακής αντλίας
Εικόνα 43: Εγκατάσταση και συνδεσμολογία μετρητή πίεσης & καταγραφικού ρυθμιστή74
Εικόνα 44: Τάπα (Blind KF)77
Εικόνα 45: Τάπα σε σωλήνα διαμέτοου 6 mm (Tube cover)
Εικόνα 46: Εγκατάσταση φιάλης O_{18} (Oxygen bottle)83
Εικόνα 47: Συνδεσμολογία για πείραμα αέριας διάχυσης με τη χρήση φιαλών αερίου90

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ασχολήθηκε με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο της λειτουργίας μίας διάταξης για μελέτη φαινομένων αέριας διάχυσης σε στερεά κατάσταση. Αρχικά, σχεδιάστηκαν με χρήση προγράμματος σε Η/Υ δύο ισοϋψή, διαφορετικού μήκους τραπέζια, πάνω στα οποία πραγματοποιήθηκε, μετά την κατασκευή τους, η εγκατάσταση όλων των μερών της διάταξης. Οι περισσότερες συνδέσεις των τμημάτων της διάταξης, δηλαδή ο δειγματοφορέας, ο βραχίονας που τον κινεί, δύο μηχανικές αντλίες τεχνολογίας κενού, ο μετοητή πίεσης, ο ουθμιστής του φούρνου και ένα δοχείο αερίου προς διάχυση, διασυνδέονται μεταξύ τους αεροστεγώς μέσω ενός διπλού σταυρού αποτελούμενου από έξι όμοιους σωλήνες. Άλλα κύρια μέρη είναι, ο φούρνος με δυνατότητα μετακίνησης πάνω σε ράγες, ο κεραμικός αντιδραστήρας (σωλήνας αλούμινας) που περιβάλλει τον δειγματοφορέα και οι ρυθμιστές του μετρητή πίεσης και της αντλίας παραγωγής υψηλού κενού. Ο έλεγχος της λειτουργίας της διάταξης πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο, πάρθηκαν θερμοκρασιακά προφίλ του φούονου προκειμένου να ελεγχθεί η θερμοκρασιακή του απόκριση. Η διαδικασία αυτή περιείχε την μετακίνηση ενός θερμοστοιχείου, συνδεδεμένου με ένα ψηφιακό πολύμετρο, κατά μήκος του φούρνου, ο οποίος προγραμματιζόταν σε μία σταθερή θερμοκρασία. Κατά αυτόν τον τρόπο ελήφθησαν προφίλ θερμοκρασίας στους 400, 600, 800 και 1000 °C σύμφωνα με τα οποία προσδιορίστηκε ο άξονας της θερμικής ζώνης του φούρνου, οι αποκλίσεις των θερμοκρασιακών αποκρίσεων του ρυθμιστή με αυτές του θερμοστοιχείου, καθώς και το συμπέρασμα της εύρυθμης λειτουργίας του φούρνου σε διαδικασίες υψηλών θερμοκρασιών. Στο δεύτερο στάδιο, πραγματοποιήθηκε μια συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής κενού μέσω της οποίας ελέγχθηκε η λειτουργία των δύο αντλιών και εξετάστηκε η στεγανότητα και δυνατότητα κατακράτησης κενού και υποπιέσεων στο χώρο που περιβάλλει τον δειγματοφορέα. Μετά την διεξαγωγή πειραμάτων, καταστρώθηκαν διαγράμματα πίεσης συναρτήσει του χρόνου και υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα ποσοστά διαρροής. Τέλος, δίνονται προτάσεις μελλοντικής έρευνας βάσει των οποίων μπορεί να αξιοποιηθεί η παρούσα διάταξη σε μελέτες φαινομένων διάχυσης.

Abstract

This diploma thesis focused on the design, construction and functionality of an experimental setup for diffusion studies in solid state. To begin with, they were designed two tables, of same height but in different lengths, with the use of a computer program. All parts of this setup were placed on these tables. In particular, the most parts: a sample holder, a manipulator, two vacuum pumps, a pressure transducer, an oven temperature controller and an oxygen bottle for diffusion, are tightly interconnected to a double cross, consisting of six identical tubes. Other main components are: the oven, which can move on rails, the ceramic reactor (alumina tube) surrounding the sample holder, and the vacuum and turbopump controller. The setup was tested in two stages. On the first stage, in order to test the oven's temperature response, temperature profiles were taken. This process included a thermocouple, connected to a digital multimeter, moving along the oven which was programmed every time to a steady temperature. In this way, temperature profiles were taken in 400, 600, 800 $\kappa\alpha$ 1000 °C, according to which it was determined the oven's heating zone, the deviations in terms of measuring temperature between the oven controller and the thermocouple, and the oven's proper operation at high temperature processes. On the second stage, it was developed a specific vacuum generation process, firstly as a means of testing the pumps' operation and secondly in order to investigate the tightness and insulation in the space that surrounds the sample holder. After conducting experiments, they were developed diagrams of pressure versus time and calculated the corresponding leak rates. In conclusion, some proposals for research are given with a view to using this experimental setup for diffusion studies in the future.

1 Θεωρητικό Μέρος

1.1 Εισαγωγή στο φαινόμενο της διάχυσης

Η διάχυση είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία σε αφκετές διεφγασίες, που σχετίζονται με τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία, όπως η πυφοσυσσωμάτωση για την παφαγωγή κόννεων, ο σχεδιασμός χημικών αντιδφαστήφων, η κατάλυση, οι διαδικασίες υψηλών θεφμοκφασιών, η εφαφμογή κενού κ.α. Η διάχυση είναι μία χφονικά εξαφτώμενη διαδικασία από τυχαία κίνηση μοφίων πφοκαλώντας την ανακατανομή των ουσιών στο χώφο. Συνδέεται δηλαδή άμεσα με τη μεταφοφά μάζας που πφοκαλείται από ένα δυναμικό συγκέντφωσης. Πιο συγκεκφιμένα, διάχυση (ή παθητική μεταφοφά), χαφακτηφίζεται η τάση των μοφίων μιας ουσίας να διασπείφονται από πεφιοχές υψηλότεφης συγκέντφωσης παρος τις πεφιοχές χαμηλότεφης συγκέντφωσης. Η τάση αυτή εκδηλώνεται με αντίστοιχη μετακίνηση των μοφίων. Αυτό σημαίνει πως η μετακίνηση των μοφίων γίνεται και πφος τις δύο κατευθύνσεις, όμως γίνεται με μεγαλύτεφο φυθμό από τη πεφιοχή της υψηλότεφης συγκέντφωσης. Κάποια στιγμή οι συγκεντφώσεις εξισώνονται, κάτι το οποίο δεν εμποδίζει την μετακίνηση των μοφίων, η οποία συνεχίζεται, αυτή τη φοφά με σταθεφό φυθμό.

Επίσης, ως διάχυση οφίζεται το φαινόμενο της αυθόρμητης ανάμιξης δύο ή περισσοτέρων χημικών ουσιών, που βρίσκονται σε επαφή και που σχηματίζουν (με την πάροδο του χρόνου) μίγμα ή διάλυμα. Όταν έρχονται σε επαφή δύο αέρια διασπείρονται μεταξύ τους, γιατί τα κινούμενα μόρια του ενός αερίου αναμιγνύονται με τα μόρια του άλλου. Αυτό συμβαίνει και σε υγρά ή στερεά που διαλύονται με διάχυση. Τα ιόντα ή τα μόρια της διαλυμάνης ουσίας διαχέονται σιγά στα αντίστοιχα του διαλύτη, δημιουργώντας τελικά ένα διάλυμα με μια ομοιόμορφη συγκέντρωση. Παράδειγμα ενός είδους διάχυσης είναι η μοριακή διάχυση (molecular diffusion). Δηλαδή, το φαινόμενο που προκαλείται από τη διαφορά χημικού δυναμικού ανάμεσα σε δύο σημεία, εξελίσσεται με την τυχαία κίνηση μορίων ή ιόντων εξαιτίας της θερμικής τους ενέργειας, ενώ σε σταθερή θερμοκρασία και απουσία εξωτερικών δυνάμεων οδηγεί σε κατάσταση φυσικοχημικής ισοροπίας. Αντίστοιχα, στη τυρβώδη διάχυση, η μεταφορά μάζας οφείλεται στη τυχαία κίνηση των δινών (οι οποίες μεταφέρουν μάζα, θερμότητα και ορμή από περιοχή υψηλών σε περιοχή χαμηλών συγκεντρώσεων).

Σε ένα διφασικό σύστημα που δεν βρίσκεται σε ισορροπία παρατηρούνται αυθόρμητες μεταβολές στις συστάσεις των δύο φάσεων, εξαιτίας του φαινομένου της διάχυσης, που οδηγούν τελικά το σύστημα σε κατάσταση ισορροπίας. Μετά την επίτευξη της ισορροπίας δεν μπορούν να παρατηρηθούν μακροσκοπικά περαιτέρω μεταβολές. Στη κατάσταση ισορροπίας, η σύσταση της κάθε φάσης παραμένει σταθερή και ομοιόμορφη σε όλο της τον όγκο, παρόλο που οι συγκεντρώσεις των διαλυμένων συστατικών μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους από τη μια φάση στην άλλη. Αντίθετα, το χημικό δυναμικό κάθε συστατικού εν διαλύσει μέσα στις δύο φάσεις θα είναι ομοιόμορφο και σταθερό σε όλο τον όγκο του συστήματος που βρίσκεται σε ισορροπία. Το χημικό δυναμικό κάθε συστατικού εξαρτάται με διαφορετικό τρόπο από τη συγκέντρωση στην κάθε φάση και η επίτευξη της ομοιομορφίας του χημικού δυναμικού, για το κάθε συστατικό ξεχωριστά αλλά και για όλο τον όγκο του συστήματος, είναι η αιτία που οδηγεί στην παύση του φαινομένου της διάχυσης. Από τα παραπάνω, συνεπάγεται ότι **η κινητήρια δύναμη του φαινομένου της** διάχυσης είναι το χημικό δυναμικό (ή η ενεργότητα) και όχι η συγκέντρωση. Ωστόσο, σε πολυφασικά συστήματα, το φαινόμενο της διάχυσης εξετάζεται για κάθε φάση ξεχωριστά και η περιγραφή του φαινομένου θα γίνεται με όρους συγκέντρωσης. (αυτό συμβαίνει γιατί θεωρείται ότι κινητήρια δύναμη του φαινομένου είναι η διαφορά της συγκέντρωσης) (1).

1.2 Προσεγγίσεις και είδη διάχυσης

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για τη θεωρία της διάχυσης: η **ατομιστική** προσέγγιση (atomistic approach), όπου λαμβάνεται ρητά υπ' όψιν η ατομική φύση της διαχεόμενης ουσίας και ορίζεται ως η καθαρή μεταφορά των μορίων από μία περιοχή μεγαλύτερης συγκεντρώσεως σε μία άλλη μικρότερης με τυχαία μεταφορά των μορίων, και η **συνεχής προσέγγιση** (continuum approach), σύμφωνα με την οποία η διαχεόμενη ουσία εξετάζεται σαν ένα σταθερό, συνεχές μέσο και η ατομική φύση της διάχυσης δεν λαμβάνεται υπ' όψιν (2).

Μια πιο ολοκληρωμένη ιδέα του φαινομένου της διάχυσης δίνεται αν ληφθούν υπ' όψιν και οι κινήσεις των μορίων. Υπάρχουν εξισώσεις που συσχετίζουν μακροσκοπικές ποσότητες, όπως η ροή της διάχυσης με τις ατομικές ποσότητες, όπως η συχνότητα άλματος ενός ατόμου. Συχνά, αρκετές τέτοιες ποσότητες της διάχυσης σχετίζονται με την ίδια ατομική παράμετρο. Η μοριακή διάχυση επιτρέπει το συσχετισμό διαφόρων μακροσκοπικών ποσοτήτων με τρόπους που δεν είναι δυνατοί από την προσέγγιση της συνέχειας, ενώ χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες:

- Την tracer diffusion (ιχνηθέτη). Είναι η μείξη των σωματιδίων, η οποία πραγματοποιείται απουσία βαθμίδας συγκέντρωσης ή χημικού δυναμικού. Αυτή η διάχυση μπορεί να ανιχνευτεί με ιχνηθέτη και συνήθως λαμβάνεται ως ίδιου τύπου με την αυτοδιάχυση (self diffusion). Πραγματοποιείται σε συνθήκες ισορροπίας.
- 2. Την **chemical diffusion** (χημική). Αυτή πραγματοποιείται με την παρουσία βαθμίδας συγκέντρωσης (ή χημικού δυναμικού) και καταλήγει σε καθαρή μεταφορά μάζας.

Σε αυτή την κατηγορία διάχυσης, αυξάνεται η εντροπία του συστήματος, καταλήγοντας τελικά σε ισορροπία.

Άλλα είδη διάχυσης είναι: η διάχυση θεομότητας, η διάχυση οομής (πχ. ιξώδες), η ακουστική διάχυση κυμάτων, η ατομική διάχυση (πχ. πυοηνική ενέργεια), η κίνηση Brown (πχ. ένα σωματίδιο σε διαλύτη), η αυτοδιάχυση (αυθόρμητη διασπορά μάζας), η διάχυση κενών οπών (vacancy diffusion), η διάχυση αερίων σε πορώδη υλικά κατά Knudsen, η όσμωση και η επιφανειακή διάχυση (3).

1.3 Μηχανισμοί Διάχυσης

Κάθε θεωρία που περιγράφει το φαινόμενο της ατομικής διάχυσης πρέπει να ξεκινά λαμβάνοντας υπ' όψιν της τους μηχανισμούς της διάχυσης. Είναι απαραίτητη η γνώση του τρόπου με τον οποίο ένα συγκεκριμένο άτομο αλλάζει θέση στο χώρο. Στα αέρια όπου τα μόρια έχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, θεωρείται ότι κάθε μόριο κινείται σε ευθεία γραμμή μέχρι τη στιγμή που θα συγκρουσθεί με ένα άλλο μόριο (ή με τα τοιχώματα του δοχείου). Αυτή η σύγκρουση αλλάζει την ταχύτητα και την κατεύθυνση του μορίου, το οποίο συνεχίζει σε μία νέα κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει και να συγκρουσθεί με ένα ακόμα μόριο. Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει σε μία ικανοποιητική κινητική θεωρία διάχυσης για τα αέρια στην οποία ο συντελεστής διάχυσης συσχετίζεται με τη μέση ταχύτητα και το μέση ελεύθερη διαδρομή του μορίου. Στα υγρά οι συνθήκες είναι περισσότερο περίπλοκες. Ένα μόριο δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα μεταξύ των γειτονικών μορίων του. Η κίνησή του περιγράφεται ως μία ακανόνιστη κίνηση περίπαση άμορφων στερεών που δεν έχουν κανονική δομή, είναι πολύ δύσκολη. Η διάχυση σε άμορφα στερεά είναι δύσκολο να αναλυθεί.

Αντίθετα, στα κουσταλλικά στεφεά οι μηχανισμοί διάχυσης πεφιγφάφονται με απλούς όφους. Το διατεταγμένο κουσταλλικό πλέγμα (ordered crystal lattice) πεφιοφίζει τις πιθανές κινήσεις των ατόμων και επιτφέπει μία απλή πεφιγφαφή του τφόπου μετακίνησης κάθε μοφίου. Αυτό έφχεται σε αντίθεση με την κατάσταση στα αέφια, όπου γίνεται η υπόθεση μιας τελείως τυχαίας διάταξης στο χώφο και με την κατάσταση στα υγφά και στα άμοφφα στεφεά τα οποία δεν είναι ούτε πλήφως, αλλά ούτε και εντελώς τυχαία διατεταγμένα. Σε κάθε κφύσταλλο, υπάφχει τάξη-σειφά (array) θέσεων πλέγματος, δηλαδή ενεφγειακά κατάλληλων θέσεων για τα πλέγματα. Η βασική θεώφηση είναι ότι κάθε διαχεόμενο άτομο εκτελεί μια σειφά αλμάτων (jumps) ανάμεσα σε διάφοφες θέσεις πλέγματος (lattice sites). Αυτά τα άλματα γίνονται σε πεφισσότεφο ή λιγότεφο τυχαίες κατευθύνσεις και επιτφέπουν τη μετανάστευση (migration) μέσα στον κφύσταλλο. Επομένως, ανάλογα με τον τύπο του άλματος στις πλεγματικές θέσεις υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί διάχυσης, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

Άμεσης ανταλλαγής		Σημειακών αταξιών					
Ανταλλαγής (Exchange)	Δακτυλιδιού (Ring)	Ενδοπλεγματικός			Κενών θέσεων		
		Interstitial	Interstitialcy	Crowdion	Vacancy	Divacancy	Relaxation
Πίνακας 1: Μηχανισμοί διάχυσης							

Άλλοι μηχανισμοί διάχυσης που αφορούν τη διάχυση σε περιοχές όπου η δομή του κρυσταλλικού πλέγματος σπάει είναι, οι Μηχανισμοί σωλήνα διαταραχής (Dislocation pipe diffusion), Διάχυσης στο όριο κόκκων (Grain boundary diffusion), και Επιφανειακής διάχυσης (Surface diffusion) (2).

Οι πιο συνηθισμένοι από τους παραπάνω μηχανισμούς είναι οι **vacancy** και **interstitial**, οι οποίοι περιγράφονται σύντομα μαζί με τους υπόλοιπους παρακάτω.

1.3.1 Μηχανισμοί άμεσης ανταλλαγής (Direct interchange)

1.3.1.1 Μηχανισμός ανταλλαγής (Exchange mechanism)

Πιθανότατα ο πιο απλός μηχανισμός που μπορεί να υποτεθεί για το στοιχειώδες 'άλμα' είναι αυτός της άμεσης εναλλαγής δύο γειτονικών ατόμων. Ο μηχανισμός αυτός δεν εμφανίζεται σε κρυστάλλους με ισχυρή ατομική δομή καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις, το κάθε άτομο είναι περικυκλωμένο και εγκλωβισμένο στα γειτονικά του. Αντιθέτως, ο μηχανισμός αυτός μπορεί να εφαρμοστεί σε κρυστάλλους με πολύ χαλαρούς δεσμούς. Για να γίνει η αλλαγή θέσης μεταξύ των μορίων το άτομο θα χρειαστεί να συμπιεστεί (2). Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένας μηχανισμός ανταλλαγής ατόμων στο πλέγμα ενός κρυστάλλου:



Εικόνα 1: Μηχανισμός ανταλλαγής (Exchange mechanism)

1.3.1.2 Μηχανισμός δακτυλιδιού (Ring mechanism)

Ο μηχανισμός δακτυλίου είναι μια παφαλλαγή του μηχανισμού άμεσης ανταλλαγής. Σε αυτή την πεφίπτωση, ένας αφιθμός ατόμων που σχηματίζει έναν κύκλο κινείται ταυτόχφονα, με τέτοιο τφόπο ώστε ο κύκλος να πεφιστφέφεται με απόσταση ενός ατόμου κάθε φοφά. Η συμπίεση σε αυτό τον μηχανισμό είναι πολύ μικφότεφη σε σχέση με αυτή που απαιτείται στον μηχανισμό ανταλλαγής (2). Στην παφακάτω εικόνα φαίνεται ένας μηχανισμός δακτυλιδιού στο πλέγμα ενός κφυστάλλου:



Εικόνα 2: Μηχανισμός δακτυλιδιού (Ring mechanism)

1.3.2 Ενδοπλεγματικοί μηχανισμοί

Οι παρακάτω μηχανισμοί αναφέρονται σε τέλειους κρυστάλλους:

1.3.2.1 Interstitial mechanism

Όταν υπάρχουν ατέλειες όπως είναι τα ενδιάμεσα άτομα εφαρμόζονται μηχανισμοί που απαιτούν σημαντικά μικρότερη ενέργεια. Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι ο μηχανισμός ενδιάμεσου πλέγματος, επίσης γνωστός και ως άμεσος μηχανισμός ενδιάμεσου (direct interstitial mechanism). Σύμφωνα με αυτό τον μηχανισμό, ένα άτομο κινείται κατά μήκος του κρυστάλλου 'πηδώντας' απ' ευθείας από τη μία ενδιάμεση θέση στην άλλη. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διάχυσης ατόμων χαμηλής καθαρότητας, που εισέρχονται εύκολα σε ενδιάμεσες θέσεις και με το 'άλμα' τους δεν μετακινούν πολύ τα άτομα του διαλύτη από την κανονική τους θέση στο κρυσταλλικό πλέγμα (2). Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένας μηχανισμός ενδιάμεσου πλέγματος:



Εικόνα 3: Interstitial mechanism

1.3.2.2 Interstitialcy mechanism

Όταν το ενδιάμεσο άτομο είναι σχεδόν ίσο σε μέγεθος με τα άτομα του κουσταλλικού πλέγματος η διάχυση είναι πιο πιθανό να συμβεί με βάση τον έμμεσο μηχανισμού ενδιάμεσου. Εδώ η κίνηση των ατόμων δεν γίνεται απ' ευθείας από τη μία ενδιάμεση θέση στην άλλη, αλλά ως εξής: το άτομο της ενδιάμεσης θέσης μετακινείται σε μία θέση του κουσταλλικού πλέγματος 'σποώχνοντας' κάποιο άλλο, που βοισκόταν σε

εκείνη τη θέση και το οποίο οδηγείται σε μία γειτονική ενδιάμεση (2). Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένας έμμεσος μηχανισμός ενδιάμεσου:



Εικόνα 4: Interstitialcy mechanism

1.3.2.3 Crowdion mechanism

Ο μηχανισμός αυτός είναι ένας τρίτος τύπος ενδιάμεσου σχηματισμού. Εδώ το επιπρόσθετο άτομο προστίθεται σε μία σειρά ατόμων. Κάθε άτομο της σειράς μετακινείται από την θέση ισορροπίας του στο κρυσταλλικό πλέγμα κατά μήκος αυτής της σειράς αντικαθιστώντας το ένα το άλλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου έχουμε διάχυση αντικατάστασης, με περίπου ίδιο μέγεθος για όλα τα άτομα, κυρίαρχος μηχανισμός είναι ο vacancy mechanism ο οποίος και προτιμάται στη θέση των τριών αυτών μηχανισμών (interstitial, interstitialcy, crowdion) (2).

1.3.3 Μηχανισμοί κενών θέσεων

1.3.3.1 Vacancy mechanism

Στη θερμική ισορροπία, κάθε κρύσταλλος σε θερμοκρασίες πάνω από το απόλυτο μηδέν, περιέχει έναν συγκεκριμένο αριθμό κενών κρυσταλλικών θέσεων. Αυτές οι κενές θέσεις είναι οι πρώτες υποψήφιες σε περίπτωση διάχυσης. Το στοιχειώδες ατομικό 'άλμα' στο μηχανισμό κενών θέσεων είναι το άλμα ενός ατόμου σε μια γειτονική του θέση. Η θέση που κατείχε το συγκεκριμένο άτομο είναι τώρα κενή, έτσι ώστε στην πραγματικότητα τα άτομα να ανταλλάσσουν θέσεις. Το κάθε άτομο κινείται κατά μήκος του κρυστάλλου

κάνοντας μια σειρά από ανταλλαγές μεταξύ των κενών θέσεων που υπάρχουν σε μία κοντινή περιοχή (2). Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο εν λόγω μηχανισμός:



Εικόνα 5: Vacancy mechanism

1.3.3.2 **Divacancy mechanism**

Όταν υπάρχει ενέργεια σύνδεσης η οποία δημιουργεί παραπάνω από 2 κενές θέσεις στο κρυσταλλικό πλέγμα, τότε πρόκειται για τον Divacancy mechanism. Ωστόσο, ο μηχανισμός μίας κενής θέσης απαντάται πιο συχνά. Εξαιτίας των χαλαρών δεσμών και την επακόλουθη έλλειψη συμμετρίας, ο μηχανισμός διάχυσης 2 και άνω κενών θέσεων δεν υπακούει σε όλες τις εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για τον μηχανισμό κενών θέσεων (2).

1.3.3.3 Relaxation mechanism

Ο μηχανισμός αυτός είναι ένας τροποποιημένος μηχανισμός κενών θέσεων τύπου vacancy. Αν τα άτομα στην περιοχή μιας κενής θέσης χαλαρώνουν προς το εσωτερικό, σε τέτοιο βαθμό ώστε να χάνεται η κανονική δομή του κρυσταλλικού πλέγματος, η περιοχή που δημιουργείται, αναφέρεται ως 'relaxation site'. Τα άτομα σε αυτή την περιοχή μπορούν να διαχέονται με μία ακανόνιστη κίνηση 'σπρωξίματος' παρόμοια με την κίνηση εντός κάποιου υγρό (2).

1.3.4 Μηχανισμοί Σωλήνα διαταφαχής (Dislocation pipe diffusion), Διάχυσης στο όφιο κόκκων (Grain boundary diffusion) και Επιφανειακής διάχυσης

Οι τφεις αυτοί μηχανισμοί αναφέφονται σε διαχεόμενες πεφιοχές όπου η δομή του κφυσταλλικού πλέγματος σπάει. Πεφιλαμβάνουν ασυνέχειες στην επιφάνεια και τη δομή του κφυστάλλου. Αυτοί οι μηχανισμοί δεν είναι εύχφηστοι για διεξοδική κινητική ανάλυση. Καθώς ο αφιθμός των διαταφαχών, των κόκκων και των επιφανειών είναι ανεξάφτητος από τη θεφμοκφασία, η διάχυση με αυτούς τους μηχανισμούς αναμένεται να έχει μικφότεφη θεφμοκφασιακή εξάφτηση από τους μηχανισμούς που αφοφούν σημειακές αταξίες στο κφυσταλλικό πλέγμα (vacancies and interstitial atoms). Ακόμα σε αυτούς τους μηχανισμούς η συγκέντφωση των αταξιών αυξάνεται με την αύξηση της θεφμοκφασίας. Οι μηχανισμούς η συγκέντφωση των αταξιών αυξάνεται με την αύξηση της θεφμοκφασίας. Οι μηχανισμοί είναι σημαντικοί για τη μελέτη του φαινομένου της διάχυσης σε χαμηλές θεφμοκφασιών, ειδικά αν συγκφιθούν με τους υπόλοιπους μηχανισμούς που πφοαναφέφθηκαν (2).

1.4 Συντελεστής Διάχυσης

Ο συντελεστής διάχυσης (diffusion coefficient ή diffusivity) είναι το μέτρο της διάχυσης, ή αλλιώς ένας δείκτης που ορίζει την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται η μεταφορά των μορίων και εμφανίζεται στους νόμους του Fick. Εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι συγκεκριμένος για κάθε ένωση και συνθήκες. Η εξάρτηση του συντελεστή διάχυσης (D) από την θερμοκρασία, δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

$$D = D_0 \cdot e^{(-Ea/R \cdot T)} \qquad (1)$$

όπου **D**₀ είναι ο προεκθετικός παράγοντας Arrhenius σε μονάδες $(\frac{m^2}{\text{sec}})$, **E**_a είναι η ενέργεια ενεργοποίησης σε $(\frac{J}{mol})$, **R** η παγκόσμια σταθερά των αερίων, $R = 8.14 \frac{J}{mol \cdot K}$, και **T** η θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin (K).

Οι συντελεστές διάχυσης των δύο κύριων κατηγοριών που αναφέρθηκαν (tracer, chemical) είναι γενικά διαφορετικοί λόγω του ότι ο συντελεστής για την chemical diffusion είναι δυαδικός (binary) και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα εξαιτίας της συσχέτισης της κίνησης των μορίων μεταξύ διαφορετικών μέσων διάχυσης (3).

1.5 Ροή σωματιδίων (flux) – Εξισώσεις Fick

Η θεωρία της διάχυσης εκφράζεται με τους νόμους του Fick. Οι νόμοι περιγράφουν την τάση να διαμορφωθεί μια ομογενής κατανομή στο χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν επίσης και ροές ύλης που οφείλονται σε πεδία δυνάμεων, οι οποίες δεν περιγράφονται από αυτούς τους νόμους (2).

1.5.1 **1ος Νόμος Fick**

Η μαθηματική θεωρία της διάχυσης σε ισοτροπικές ουσίες δίνεται με βάση την υπόθεση ότι ο ρυθμός μεταφοράς (ροή) για τη διάχυση μιας ουσίας μέσω μιας επιφάνειας, που πραγματοποιείται από περιοχές μεγάλης σε περιοχές μικρής συγκέντρωσης, σχετίζεται με μία ποσότητα που είναι ανάλογη στη βαθμίδα της συγκέντρωσης. Για επίπεδη, μονοδιάστατη διάχυση (planar diffusion) ο συντελεστής διάχυσης, D, ορίζεται από τη παρακάτω εξίσωση:

$$J = -D \cdot \frac{\partial c}{\partial x} \qquad (1)$$

όπου **J** είναι η δοή σωματιδίων σε μονοδιάστατο επίπεδο (μόδια, άτομα, ιόντα κτλ) σε μονάδες $(\frac{mol}{m^2 \cdot \sec})$, **c** είναι η συγκέντρωση των ατόμων της ουσίας σε $(\frac{mol}{m^3})$ και **x** η απόστασε σε (m).

Το αφνητικό πφόσημο του συντελεστή διάχυσης στην εξίσωση (1) οφείλεται στο ότι η φοή συνήθως γίνεται στην κατεύθυνση μειούμενης συγκέντφωσης. Σε ένα απομονωμένο σύστημα, αυτό κάνει τη βαθμίδα συγκέντφωσης να εξαφανιστεί. Η εξίσωση (1) ονομάζεται **Πφώτος Νόμος του Fick** για επίπεδη διάχυση και είναι ανάλογος με την εξίσωση για τη φοή θεφμότητας, όπου η φοή θεφμότητας είναι ανάλογη της βαθμίδας της θεφμοκφασίας. Εφαφμόζεται σε πεφιπτώσεις όπου όλες οι φοές, οι δυνάμεις και οι βαθμίδες ασκούνται κατά μήκος μίας δεδομένης κατεύθυνσης.

Επιπρόσθετα, συνδυάζοντας το χημικό δυναμικό με τη συγκέντρωση, ο νόμος του Fick μπορεί να εκφραστεί με την ποσότητα του χημικού δυναμικού για μονοδιάστατη ροή:

$$c = \frac{c_i}{R \cdot T} \cdot \mu_i \qquad (2)$$

$$(1) \xrightarrow{(2)} J = -D \cdot \frac{\partial c}{\partial x} = -D \cdot \frac{\partial (\frac{c_i}{R \cdot T} \cdot \mu_i)}{\partial x} \Longrightarrow J = -\frac{D \cdot c_i}{R \cdot T} \cdot \frac{\partial \mu_i}{\partial x} \quad (3)$$

Όπου μ το χημικό δυναμικό σε μονάδες (Gibbs=Joule/mol) και i το είδος των μορίων. Από την παραπάνω σχέση (3) αποδεικνύεται γιατί, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, η βαθμίδα του χημικού δυναμικού είναι η αιτία που προκαλεί την ροή στη διάχυση (2).

1.5.2 **2ος Νόμος Fick**

Η **τρισδιάστατη εξίσωση της συνεχείας** δηλώνει ότι η διαφορά συγκέντρωσης σε κάθε όγκο ισούται με την καθαρή ροή (net flow) μέσα σε αυτόν τον όγκο:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\nabla \cdot J \qquad (4)$$

Για μονοδιάστατη φοή διάχυσης η εξίσωση (4) μετατρέπεται ως εξής:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} \qquad (5)$$

Αντικαθιστώντας την εξίσωση (1) του πρώτου νόμου του Fick στην (5) θα προκύψει η εξίσωση:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{\partial (D \cdot \frac{\partial c}{\partial x})}{\partial x} \qquad (6)$$

Η εξίσωση αυτή ονομάζεται δεύτερος νόμος του Fick. Στην περίπτωση που ο συντελεστής διάχυσης D είναι σταθερός (D=σταθ), δηλαδή, είναι ανεξάρτητος από το x, η εξίσωση (6) παίρνει την παρακάτω μορφή:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \cdot \frac{\partial^2 c}{\partial^2 x} \qquad (7)$$

Τέλος, σε περίπτωση μόνιμης κατάστασης ($\frac{\partial c}{\partial t} = 0$) η εξίσωση (7) μετατρέπεται στην εξίσωση Laplace:

$$\frac{\partial^2 c}{\partial^2 x} = \nabla^2 c = 0 \qquad (8)$$

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω εξισώσεις αντιστοιχούν σε συστήματα χημικώς ομογενοποιημένα (π.χ. αυτοδιάχυση-self diffusion). **Με αρχικές και** συνοριακές συνθήκες (initial and boundary conditions) οι λύσεις της εξίσωσης (7) του δευτέρου νόμου του Fick αποτελούν το προφίλ συγκέντρωσης (concentration or depth profile) και επιτρέπουν το προσδιορισμό του συντελεστή διάχυσης. Π.χ IEDP-SIMS (2).

1.6 Μέθοδος SIMS

1.6.1 Αρχή λειτουργίας

Ο 'βομβαφδισμός' ενός υλικού με μία κύφια δέσμη ιόντων υψηλής ενέφγειας (primary ion beam), 1-30 KeV, έχει ως αποτέλεσμα την εκτίναξη (ejection) ή το διαχωφισμό (sputtering) ατόμων από το υλικό. Αυτή είναι η βασική αφχή λειτουφγίας της φασματοσκοπίας μάζας δευτεφευόντων ιόντων (Secondary Ion Mass Spectrometry ή SIMS). Ένα μικφό ποσοστό από αυτά τα εκτινασσόμενα άτομα, φεύγουν είτε ως θετικά είτε ως αφνητικά φοφτισμένα ιόντα και αναφέφονται ως δευτεφεύοντα (secondary) ιόντα. Η συλλογή αυτών των διαχωφισμένων ιόντων και η ανάλυσή τους από μία μέθοδο φασματοσκοπίας μάζας δίνει πληφοφοφίες για τη σύσταση του δείγματος, με τα υπάφχοντα στοιχεία να αναγνωφίζονται διαμέσου της ατομικής τους μάζας πορος το αντίστοιχο φοφτίο. Η μέτφηση του αφιθμού αυτών των συλλεγόμενων δευτεφευόντων ιόντων μποφεί να δώσει ποσοτικά δεδομένα για τη σύσταση του προς εξέταση δείγματος. Επομένως, η μέθοδος SIMS λειτουργεί αναλύοντας το υλικό που έχει αφαιφεθεί από το

δείγμα, στο οποίο λόγω του βομβαςδισμού του από τη δέσμη ιόντων σχηματίζεται ένας κςατήςας. Για αυτό το λόγο η μέθοδος θεωςείται τοπικά καταστςοφική **(4).** Στην παςακάτω εικόνα φαίνεται μία τςισδιάστατη απεικόνιση του βομβαςδισμού της κύςιας δέσμης ιόντων (κόκκινο χςώμα) πάνω στο κςυσταλλικό πλέγμα ενός υλικού από το οποίο εκτινάσσονται θετικά και αςνητικά φοςτισμένα ιόντα:



Εικόνα 6: Βασική αρχή λειτουργίας μεθόδου SIMS

Ένα τυπικό όργανο για τη μέθοδο SIMS αποτελείται από τα παρακάτω κύρια μέρη:

- Μία πηγή (ion gun), η οποία παράγει την κύρια δέσμη ιόντων (primary beam), και θα προσφέρει την ενέργεια που είναι απαραίτητη για τον βομβαρδισμό του δείγματος.
- 2. Ένα στόχο ή δείγμα (sample), το οποίο θα πρέπει να είναι στερεό και να έχει σταθεροποιηθεί πρωτύτερα μέσα σε συνθήκες κενού.
- 3. Έναν αναλυτή μάζας (mass analyzer) για να απομονώνονται τα επιθυμητά ιόντα προς εξέταση βάσει του λόγου της ατομικής τους μάζας προς το αντίστοιχο φορτίο. Ο συνήθης αναλυτής μάζας που χρησιμοποιείται σε στατικά όργανα SIMS ονομάζεται 'time of flight'. Η λειτουργία του βασίζεται στο διαχωρισμό των συλλεγόμενων ιόντων σε ένα πεδίο, όπου δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις, με βάση την κινητική τους ενέργεια. Είναι ο μοναδικός τύπος αναλυτή που ανιχνεύει όλα τα δευτερεύοντα ιόντα ταυτόχρονα μετά την εκπομπή τους.

 Έναν ανιχνευτή ιόντων (detector) που καταγράφει το εύρος του σήματος των δευτερευόντων ιόντων. Ο ανιχνευτής ιόντων μπορεί να είναι ένας από τους εξής τύπους ανιχνευτών: 1. Photographic plate, 2. Faraday cup, 3. Electron multiplier, 4. CCD camera (5).

Τα παραπάνω μέρη απεικονίζονται σχηματικά στην παρακάτω εικόνα:



Εικόνα 7: Διάταξη κύριων μερών μεθόδου SIMS

1.6.2 Πλεονεκτήματα

Η μέθοδος SIMS παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα (6):

Έχει μεγάλο εύρος στοιχείων που μπορούν να εξεταστούν, από υδρογόνο και οξυγόνο μέχρι ουράνιο.

- Έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία. Τα περισσότερα στοιχεία μπορούν να ανιχνευτούν σε συγκεντρώσεις 1 ppm ή 1 ppb.
- 4 Οι αναλογίες των ισοτόπων (isotopic ratios) μπορούν να μετρηθούν συνήθως με ακρίβεια από 0,5-0,05 %.
- Μπορούν να ληφθούν δισδιάστατες και τρισδιάστατες εικόνες. Οι τρισδιάστατες εικόνες λαμβάνονται ύστερα από σάρωση της πρωτεύουσας δέσμης ιόντων και ανίχνευση του σήματος τους όσο το δείγμα διαβρώνεται σταδιακά λόγω του βομβαρδισμού του από αυτά.
- Ελάχιστη έως καθόλου προετοιμασία δείγματος.
- Πολύ μικοή επιφάνεια ανάλυσης (συνήθως περίπου 100x100μm²)
- Πολύ καλό δυναμικό εύρος (μέχρι 6 τάξεις μεγέθους)
- 🖊 Ακρίβεια της τάξης περίπου 5-10%

1.6.3 Μειονεκτήματα

Η μεθόδος SIMS ωστόσο παρουσιάζει και ορισμένα μειονεκτήματα, όπως τα εξής (6):

- Το υλικό που αποκολλάται από την επιφάνεια του δείγματος αποτελείται, όχι μόνο από μονοατομικά ιόντα, αλλά και από μοριακά είδη, τα οποία μπορούν να κυριαρχήσουν στο φάσμα μάζας, καθιστώντας την ανάλυση κάποιων στοιχείων αδύνατη.
- Η διαδικασία του διαχωρισμού είναι δυσνόητη. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο ποσοτικό μοντέλο που να μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την διαδικασία του ιονισμού των δευτερευόντων ιόντων. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η χρήση προτύπων από βιβλιοθήκη δεδομένων καθώς και εμπειρικών διορθώσεων.
- Έχει περιορισμένο εύρος διαμέτρου για την πρωτεύουσα δέσμη ιόντων (1-200 microns). Η ευαισθησία κάθε στοιχείου είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τη σύσταση και τον τύπο της ακτίνας της δέσμης. Κατά συνέπεια, η ευαισθησία μειώνεται όσο ελαττώνεται η διάμετρος αυτής, αφού όλο και λιγότερα ιόντα αποσπώνται από το δείγμα για ανάλυση.

- Είναι τοπικά καταστροφική μέθοδος.
- **4** Το δείγμα πρέπει να είναι στερεό και συμβατό με υψηλό κενό (ultra high vacuum)

1.6.4 Σύγκοιση με άλλες μεθόδους

Σε σύγκοιση με άλλες μεθόδους, όπως η BLE (Bombardment-induced Light Emission), που βασίζεται στην διέγεοση και εκπομπή φωτονίων και η ISS (Ion Scattering Spectroscopy), η οποία στηρίζεται στην μέτοηση της ενέργειας των εκτοξευόμενων σωματιδίων, η μέθοδος SIMS υπερτερεί σε ότι αφορά το εύρος των στοιχείων προς εξέταση καθώς και της συγκέντρωσής τους. Όμως υστερεί σημαντικά λόγω του ότι δεν έχει την δυνατότητα απευθείας απεικόνισης των αποτελεσμάτων της, καθώς και του ότι μετά τη χρήση της είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση και άλλης μεθόδου για την επεξεργασία και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων.

Η μέθοδος SIMS εφαρμόζεται καλύτερα για ανάλυση δειγμάτων χαμηλής συγκέντρωσης, μικρότερης του 1%. Έτσι, θεωρείται ότι επεκτείνει της δυνατότητες μιας άλλης μεθόδου που καλείται EMPA (Electron Probe Microanalysis). Για παράδειγμα, το υδρογόνο είναι ένα στοιχείο που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τις μεθόδους AES, XPS ή EPMA. Παρ' όλα αυτά, με την μέθοδο SIMS είναι δυνατός ο προσδιορισμός του. Όμως, η λεπτή επιφάνεια γύρω από ένα οξείδιο σε κάποιο μέταλλο δεν μπορεί να προσδιοριστεί απευθείας με αυτή τη μέθοδο, καθώς η ανάλυση μιας περιοχής δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί για την επιφάνεια και το οξείδιο που την περιβάλλει. Η SIMS εν κατακλείδι, είναι μία συμπληρωματική τεχνική σε πολλές περιπτώσεις καθώς δεν έχει την δυνατότητα να προσφέρει απευθείας μια εικόνα και έχει ευρεία εφαρμογή στην ανίχνευση ατελειών ή εμφυτευμάτων σε ημιαγωγούς και βιομηχανίες (7).

1.7 Πειραματική διάταξη και διαδικασία αέριας διάχυσης σε στερεά κατάσταση

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μία σύντομη-εισαγωγική περιγραφή των συστατικών μερών της διάταξης διάχυσης που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανόργανων Υλικών του ΕΜΠ, στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επίσης, θα περιγραφεί η διαδικασία μελέτης του φαινομένου αέριας διάχυσης σε στερεά κατάσταση.



Τα κύρια μέρη της εν λόγω διάταξης απεικονίζονται και στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 8: Πειφαματική διάταξη διάχυσης του Εφγαστηφίου Τεχνολογίας Ανόφγανων Υλικών του ΕΜΠ

Η παραπάνω διάταξη αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά μέρη:

- 1. Φούρνος
- 2. Ρυθμιστής φούρνου

- 3. Δειγματοφορέας
- 4. Διπλός σταυρός
- 5. Μετοητής πίεσης
- 6. Περιστροφική αντλία χαμηλού κενού
- 7. Τουρμπομοριακή αντλία υψηλού κενού

Το στεξεό δείγμα, συνήθως σε μοξφή 'πελλέτας' (σφαιξικού δισκίου), τοποθετείται στον δειγματοφοξέα, ο οποίος στεξεώνεται σε έναν βξαχίονα (manipulator) που διαθέτει μαγνήτη και μποξεί να τον κινεί. Το ενσωματωμένο θεξμοστοιχείο του δειγματοφοξέα συνδέεται ηλεκτζικά μέσω καλωδίων περόκτασης (extension wires) με τον ξυθμιστή του φούξονου, για να είναι δυνατή η παξακολούθηση της θεξμοκξασίας του δείγματος καθ' όλη τη διάξκεια της διεξαγωγής του πειξάματος. Στη συνέχεια ο δειγματοφοξέας και το δείγμα καλύπτονται από έναν κεξαμικό αντιδεξαστήξα, δηλαδή έναν σωλήνα αλούμινας με το ένα άκεξο του κλειστό μέσα στο οποίο εισέξχονται στην πεξιοχή του δείγματος. Στη συνέχεια το σύστημα αυτό του δείγματος και του αντιδεαστήξα εισέξχονται στον φούξονο, με τέτοιο τζόπο, ώστε το δείγμα να βεθεί στον άξονα της θεξμικής ζώνης του φούξονου. Ο αντιδεαστήξας ψύχεται μέσω ενός θεξιμοστάτη ώστε να μην αποκολληθεί ο σωλήνας αλούμινας καθώς αναπτύσσονται υψηλές θεξιμοκρασίες.

Όλες οι συνδέσεις των τμημάτων της διάταξης, δηλαδή ο δειγματοφοφέας, ο βφαχίονας (manipulator), οι αντλίες κενού, ο μετφητή πίεσης, ο φυθμιστής του φούφνου και ένα δοχείο αεφίου πφος διάχυση, διασυνδέονται μεταξύ τους αεφοστεγώς μέσω ενός διπλού σταυφού τύπου KF40. Ο πφώτος σωλήνας συνδέει το δείγμα με τις αντλίες κενού. Στο σημείο αυτό υπάφχει μία βαλβίδα αποκοπής (βάνα κενού) για την διακοπή της εφαφμογής κενού, όταν θα έχει επιτευχθεί σταθεφή υποπίεση. Ο δεύτεφος θα καταλήγει στον μετφητή πίεσης, ο οποίος δίνει πληφοφοφίες για την πίεση στο εσωτεφικό του φούφνου. Ο τφίτος σωλήνας θα καταλήγει στον φυθμιστή του φούφνου, όπου θα λαμβάνει το σήμα από το ενσωματωμένο θεφμοστοιχείο του δειγματοφοφέα για τη θεφμοκφασία του φούφνου στην πεφιοχή του δείγματος και θα φυθμίζει κατάλληλα τις αντιστάσεις του φούφνου για την επίτευξη της επιθυμητής θεφμοκφασίας. Τέλος ο τέταφτος θα καταλήγει στο νλικό που θα διαχυθεί στο πφος εξέταση δείγμα. Συνήθως το υλικό αυτό θα είναι αέφιο οξυγόνο, O_{18} .

Έτσι λοιπόν κατά τη διαδικασία αέφιας διάχυσης, πφέπει αφχικά να δημιουφγηθούν συνθήκες κενού στο χώφο που πεφιβάλλει το δείγμα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των 2 αντλιών, οι οποίες είναι συνδεδεμένες σε σειφά μέσω σωλήνων και της βάνας κενού με τον

διπλό σταυρό. Εφόσον ελεγχθεί ότι οι συνδέσεις των αντλιών και του σταυρού έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο συσφιχτεί καλά μέσω σφικτήρων και βιδών, εξασφαλίζοντας στεγανότητα και μόνωση στον εσωτερικό χώρο των μερών της διάταξης, τίθεται σε λειτουργία η περιστροφική αντλία χαμηλού κενού. Όταν η πίεση μειωθεί σε τάξεις των 10^{-2} - 10^{-3} mbar, ξεκινά να λειτουργεί και η τουρμπομοριακή αντλία υψηλού κενού με τη συμβολή της οποίας αναμένεται μεγάλη μείωση της πίεσης σε τάξεις των 10^{-5} - 10^{-8} mbar. Αφότου επιτευχθεί σταθερή υποπίεση, το δείγμα θερμαίνεται σύμφωνα με ένα θερμοκρασιακό πρόγραμμα μέχρι το πολύ τους 1200 °C που αποτελούν τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του συγκεκριμένου φούρνου, και λαμβάνονται συνεχώς τιμές της πίεσης και της θερμοκρασίας για έλεγχο τυχών απωλειών που θα φαίνονται από πιθανές αποκλίσεις στις τιμές της θερμοκρασίας ή της πίεσης. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και σταθεροποιηθεί η υποπίεση, η βάνα κλείνει και απομονώνεται ο εσωτερικός χώρος του σταυρού και του αντιδραστήρα που περιβάλλουν το δείγμα, δηλαδή παύει η λειτουργία των αντλιών. Τυχόν αποκλίσεις παρέχουν πληροφορίες για τυχόν απώλειες και για τη στεγανότητα και μόνωση της διάταξης. Στη συνέχεια ανοίγουμε την παροχή του αερίου που θέλουμε να διαχυθεί στο προς εξέταση δείγμα. Το αέριο αυτό συνήθως είναι O_{18} .

Γί αυτό το λόγο με την ολοκλήφωση του πειφάματος οικονομικοί λόγοι επιβάλλουν την ανάκτηση του εναπομείναντος O_{18} ή οποιοδήποτε άλλου ιχνοστοιχείου από την πεφιοχή του δείγματος. Έτσι, αυτή η φιάλη που το πεφιείχε αφχικά και εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο, ψύχεται τοποθετώντας την σε δοχείο υγφού αζώτου. Με τον τφόπο αυτό η πίεση της φιάλης μειώνεται, μέχρι να γίνει μικφότεφη από την πίεση στην πεφιοχή του δείγματος ότσι τις πφοϋποθέσεις (διαφοφά δυναμικού), ώστε το αέφιο να οδηγηθεί τελικά πίσω στη φιάλη. Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε είναι κατάλληλα διαμοφφωμένη, έτσι ώστε αντί για O_{18} να μποφεί να διαχέεται οποιοδήποτε αέφιο. Τέλος, για την αφαίφεση του δείγματος χφειάζεται ιδιαίτεφη προσοχή, για την αποφυγή σχηματισμού πφοσμίξεων στην επιφάνειά του. Έτσι, το δείγμα ψύχεται τοαδωστήφα. Μετά από αυτό το βήμα, το δείγμα θα είναι έτοιμο για να οδηγηθεί για πεφαιτέρω ανάλυση με τη μέθοδο SIMS που αναλύθηκε παφαπάνω.

Έχοντας κάνει μια εισαγωγή στη διάχυση και τους μηχανισμούς της, καθώς και στη πειραματική διαδικασία αέριας διάχυσης σε στερεά κατάσταση, ακολουθεί το πειραματικό μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Σε αυτό παρουσιάζεται η πορεία σχεδιασμού και κατασκευής μιας διάταξης διάχυσης και ο μετέπειτα έλεγχος της λειτουργικότητας και των παραμέτρων της.

2 Πειραματικό Μέρος

2.1 Σχεδιασμός τραπεζιών με χρήση του προγράμματος Solidworks

Το πρωταρχικό στάδιο της διπλωματικής εργασίας περιείχε τον ακριβή σχεδιασμό και την παραγγελία των τραπεζιών, πάνω στα οποία πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση της πειραματικής διάταξης.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό με σαφείς και ακριβείς λεπτομέρειες όσον αφορά την απεικόνιση και τις διαστάσεις, κρίθηκε απαραίτητη η συμβολή σχεδιαστικού προγράμματος σε 3 διαστάσεις (3D) με χρήση Η/Υ. Συγκεκριμένα, προτιμήθηκε το Solidworks.

Στο πλαίσιο αυτό, έπρεπε να ληφθούν υπόψη όλες οι διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) όλων των συστατικών μερών της διάταξης ώστε να προκύψουν οι τελικές διαστάσεις των τραπεζιών. Έτσι, αποφασίστηκε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία δύο τραπεζιών με ίδιο ύψος (975 mm) και ίδιο πλάτος (550 mm) αλλά διαφορετικού μήκους (1200 mm το μεγαλύτερο και 500 mm το μικρότερο). Οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες των δύο τραπεζιών, οι οδηγίες για τη συγκόλληση τους, και τα ακριβή μεγέθη προς κόψιμο των μεταλλικών τμημάτων αποτυπώνονται στις παρακάτω εικόνες:



Εικόνα 9: Σχεδιαστική απεικόνιση του μεγάλου πλαισίου στήριξης της πειραματικής διάταξης



Εικόνα 10: Σχεδιαστική απεικόνιση του μικρού πλαισίου στήριξης της πειραματικής διάταξης



Εικόνα 11: Σχεδιαστική απεικόνιση του μικοού πλαισίου στήριξης της πειραματικής διάταξης (3D)

Στη συνέχεια, ήταν απαφαίτητο να επαληθευθεί η διαστασιολόγηση που έγινε, και έτσι τοποθετήθηκαν με διαστατική ακφίβεια πάνω στα τφαπέζια, που σχεδιάστηκαν με το πφόγφαμμα Solidworks, τα βασικά και πιο ογκώδη μέφη της πειφαματικής εγκατάστασης υπό τη μοφφή οφθογώνιων σχημάτων όπως φαίνεται στο παφακάτω σχήμα:



Εικόν
 Η 12: Προσχέδιο πειραματικής διάταξης για την επαλήθευση της διαστασιολό
γησης της

Στο παφαπάνω σχήμα λοιπόν, έχουν τοποθετηθεί κολλητά τα δύο ισοϋψή τφαπέζια, τα οποία έχουν το καθένα από τφία επίπεδα (πάνω, μεσαίο και κάτω επίπεδο). Στο μεγαλύτεφο τφαπέζι τοποθετούνται στο πάνω επίπεδο, κατά σειφά από αφιστεφά ο φούφνος (πάνω σε φάγες), ο κεφαμικός αντιδφαστήφας, ο σταυφός και ο manipulator. Ενώ στο κάτω επίπεδο, τοποθετούνται ο φυθμιστής (controller) του φούφνου και ο θεφμοστάτης (ψυκτικό).

Στο μικρότερο τραπέζι, όπου θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή του αντλιοστασίου και βρίσκεται δεξιότερα, στο μεσαίο επίπεδο τοποθετείται η τουρμπομοριακή αντλία ενώ στο κάτω επίπεδο η περιστροφική αντλία.

Στο καθένα από τα επιμέφους μέφη της διάταξης, καθώς και στα εξαφτήματα και τη μεταξύ τους συνδεσμολογία, θα γίνει εκτενής ανάλυση στη συνέχεια της παφούσας εφγασίας.

2.2 Εγκατάσταση φούρνου και των αντιστοίχων ραγών του

Το επόμενο βήμα αφότου ολοκληρώθηκε το στήσιμο των τραπεζιών, ήταν η σταδιακή υλοποίηση του πλάνου 'χτισίματος' της πειραματικής διάταξης (Εικόνα 12). Έτσι, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε με την εγκατάσταση του φούρνου και το βίδωμα των ραγών πάνω στις οποίες θα έχει τη δυνατότητα αυτός να σύρεται.

Οι φάγες σχεδιάστηκαν επίσης με τη χφήση του πφογφάμματος τφιών διαστάσεων (3D) Solidworks, ειδικά για τις πφοδιαγφαφές του φούφνου που θα χφησιμοποιηθεί στη πειφαματική διάταξη. Οι σχεδιαστικές λεπτομέφειες και διαστάσεις των δύο φαγών φαίνονται στο παφακάτω σχήμα:



Εικόνα 13: Ράγες φούονου (Oven sliders)

Όπως γίνεται αντιληπτό και από το παφαπάνω σχέδιο, η κάθε μία από τις 2 φάγες έχει μήκος 800 mm και πάχος 7,5 mm, και αυτές εγκαθίστανται σε έξι όμοιες βάσεις στήφιξης, που η κάθε μία έχει μήκος 45 mm, πάχος 15 mm και δύο οπές διαμέτφου 8,5 mm και 4 mm αντίστοιχα.

Αρχικά λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν 6 βίδες γαλβανιζέ διαμέτρου 8 mm με τις αντίστοιχες ροδέλες και τα παξιμάδια τους προκειμένου να βιδωθούν οι 6 βάσεις στήριξης των 2 ραγών στην πάνω ξύλινη τάβλα του μεγαλύτερου τραπεζιού. Για τη διαδικασία αυτή, χρησιμοποιήθηκε τρυπάνι 8 mm. Ακόμα, εξυπακούεται ότι οι βάσεις στήριξης έπρεπε να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές που βρίσκονται αντικριστά να ισαπέχουν ανά δύο.

Αφότου βιδώθηκαν οι 6 βάσεις στήριξης των ραγών πάνω στο τραπέζι, ακολούθησε το βίδωμα των 2 ραγών πάνω στις βάσεις τους. Για το σκοπό αυτό έγινε χρήση 4 βιδών γαλβανιζέ διαμέτρου 3 mm η κάθε μία.

Τέλος, μετά την εγκατάσταση των φαγών τοποθετήθηκε πάνω σε αυτές ο φούφνος, ο οποίος σύφεται εύκολα επάνω στις φάγες καθώς διαθέτει 4 ενσωματωμένες μεταλλικές φόδες. Όλα τα παφαπάνω μποφούν να διαπιστωθούν και από τις παφακάτω όψεις του φούφνου στην παφακάτω εικόνα:



Πλάγια όψη


Πίσω όψη



Ποόοψη

Εικόνα 14: Φούρνος

2.3 Εγκατάσταση διπλού σταυρού (double cross) και αντιδραστήρα

Ο διπλός σταυφός αποτελεί έναν πάφα πολύ σημαντικό συνδετικό κφίκο για την πειφαματική εγκατάσταση της αέφιας διάχυσης που διαμοφφώνεται, καθώς κάθε μία από τις 6 σωληνωτές εξόδους του χφησιμεύει για κάποια διαφοφετική λειτουφγία.

Η πλήρης συνδεσμολογία και τα εξαρτήματα που σχετίζονται άμεσα με το σταυρό θα αναλυθούν λεπτομερώς παρακάτω. Σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται η διαδικασία εγκατάστασης του στο πάνω επίπεδο του μεγαλύτερο τραπεζιού δίπλα από τον φούρνο, καθώς και η σύνδεση του με ένα κεραμικό αντιδραστήρα αλούμινας.

Αρχικά, ήταν απαραίτητος ο σχεδιασμός μίας βάσης στήριξης του σταυρού, ο οποίος βρισκόταν ήδη στην κατοχή του ΕΤΑΥ (Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανόργανων Υλικών). Έτσι, χρησιμοποιήθηκε πάλι το πρόγραμμα τριών διαστάσεων (3D) Solidworks, ώστε να γίνει η παραγγελία της βάσης με δοσμένες ακριβείς τεχνικές λεπτομέρειες που θα εξυπηρετούν την κατασκευή του σταυρού. Αυτές αποτυπώνονται στην παρακάτω εικόνα:



Εικόνα 15: Βάση στήριξης διπλού σταυρού

Όπως φαίνεται με ακρίβεια και στο παραπάνω σχήμα, η βάση στήριξης αποτελείται από μία μεταλλική τετραγωνική (16x16 cm²) βάση πάχους 1,5 cm η οποία έχει 4 κυκλικές οπές διαμέτρου 10,2 mm και 4 ελλειπτικές οπές μήκους 11,350 mm. Στις κυκλικές οπές βιδώνονται 4 βέργες στήριξης πάχους 1 cm οι οποίες έχουν ύψος 30 cm. Στις βέργες τοποθετούνται 4 όμοια μεταλλικά στηρίγματα μήκους 10 cm πλάτους 1,5 cm και ύψους 2,5 cm διαμέσω των 2 οπών (11 mm) που έχει το καθένα. Ακόμα, χρησιμοποιούνται άλλα 2 όμοια μεταλλικά στηρίγματα διαφορετικά από τα προηγούμενα με ίδιο μήκος, ύψος και διάμετρο οπών. Για τη σταθεροποίηση όλων αυτών των στηριγμάτων χρησιμοποιούνται παξιμάδια εσωτερικής διαμέτρου 8 mm. Πιο ανάγλυφα μπορεί κανείς να διακρίνει όλα τα παραπάνω στην παρακάτω τρισδιάστατη εικόνα:



Εικόνα 16: Βάση στήριξης διπλού σταυρού σε 3 διαστάσεις (3D)

Στην πράξη, έπρεπε να καθοριστεί η απόσταση φούρνου και σταυρού με γνώμονα τα παρεμβαλλόμενα μέρη της διάταξης. Δηλαδή τον κεραμικό αντιδραστήρα μήκους 25 cm και τον προσαρμογέα συστολής 40 KF σε 30 CF. Ο αντάπτορας ενώνει τον αντιδραστήρα με τον σταυρό με 6 βίδες διαμέτρου 6 mm βιδωμένες με 3 παξιμάδια Pfeiffer στις CF πλευρές του προσαρμογέα και του αντιδραστήρα. Ανάμεσα στον αντάπτορα και τον αντιδραστήρα παρεμβάλλεται ένα χάλκινο δαχτυλίδι (copper ring) ώστε να μη διαβρωθούν τα μεταλλικά τους μέρη. Τελικά, ο κεραμικός αντιδραστήρας μαζί με τα προαναφερθέντα μέρη απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα:



Ποοσαομογέας συστολής 40 KF σε 30 CF

0

Χάλκινο δαχτυλίδι Μ36



Εικόνα 17: Κεραμικός αντιδραστήρας

Έπειτα, έπρεπε να στερεωθεί και να κεντραριστεί ο σταυρός με τη βοήθεια των μεταλλικών στηριγμάτων της βάσης στήριξης με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αντιδραστήρας να μην εφάπτεται με τα τοιχώματα του εσωτερικού του φούρνου καθώς ο τελευταίος σύρεται πάνω στις ράγες του. Κατά αυτόν τον τρόπο, βιδώθηκε η μεταλλική βάση του σταυρού στο πάνω επίπεδο του τραπεζιού σε απόσταση 5 cm από τις ράγες με τη χρήση 4 βιδών γαλβανιζέ διαμέτρου 8 mm. Οι βίδες αυτές τοποθετήθηκαν στις 4 ελλειπτικές οπές της βάσης και διαπέρασαν την ξύλινη επιφάνεια του τραπεζιού, αφότου στο τελευταίο ανοίχτηκαν 4 οπές με τη βοήθεια τρυπανιού 8 mm. Στη συνέχεια, βιδώθηκαν οι βέργες στήριξης στις κυκλικές οπές της βάσης, οι οποίες διαπερνούν την επιφάνεια του τραπεζιού μέσω οπών που ανοίχτηκαν με ποτηροτρύπανο 25 mm, τοποθετήθηκε ο σταυρός, ενώ τα 6 μεταλλικά στηρίγματα του σταυρού σταθεροποιήθηκαν πάνω στις βέργες με τη χρήση 12 παξιμαδιών. Για όλη τη βάση στήριξης του σταυρού, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 24 παξιμάδια γαλβανιζέ διαμέτρου 8 mm.

Στη συνέχεια, ο σταυφός ενώθηκε με την KF πλευφά του αντιδφαστήφα με τη βοήθεια 2 πολύ σημαντικών εξαφτημάτων που χφησιμοποιούνται και γενικότεφα κατά κόφον σε τέτοιου είδους κατασκευές. Το πφώτο είναι ένα δαχτυλίδι (seal centering ring), το οποίο αποτελείται εσωτεφικά από ανοξείδωτο χάλυβα και πεφιβάλλεται από viton (συνθετικό από λάστιχο και ελαστομεφές) και τοποθετείται ανάμεσα στον αντιδφαστήφα και το σταυφό για να αποφευχθεί η διάβφωση των μετάλλων. Το δεύτεφο είναι ένα μεταλλικός σφικτήφας (Clamp wing nut), ο οποίος 'αγκαλιάζει' τον σταυφό μαζί με τον αντιδφαστήφα ώστε να στεφεώνονται και να κλείνουν αεφοστεγώς.



Εικόνα 18: Εξαρτήματα για φλάντζες κενού (vacuum flange fittings)

Η συνολική εικόνα της εγκατάστασης του αντιδραστήρα στον σταυρό διαμορφώνεται στην παρακάτω εικόνα:



Εικόνα 19 : Φούρνος-αντιδραστήρας- διπλός σταυρός

2.4 Θερμοκρασιακά προφίλ φούρνου

2.4.1 Εγκατάσταση και συνδεσμολογία θερμοστοιχείων-καλωδίων προέκτασης (extension wires) για τον έλεγχο της θερμοκρασιακής απόκρισης τους μέσω θερμοκρασιακών προφίλ

Έχοντας εγκαταστήσει τον φούρνο πάνω στις ράγες του, κρίθηκε απαραίτητος ο έλεγχος της λειτουργίας του, καθώς και η εύρεση της θερμοκρασιακής περιοχής του με την μεγαλύτερη σταθερότητα και αξιοπιστία. Για να επιτευχθεί αυτό, ακολουθήθηκε μία συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν επιμέρους θερμοστοιχεία διαφόρων τύπων (Πίνακας 3, Παράρτημα), ούτως ώστε μέσω των θερμοκρασιακών προφίλ (διαγραμμάτων θερμοκρασίας-απόστασης) που πάρθηκαν, να γίνει παράλληλα με τον έλεγχο της λειτουργίας του φούρνου και η εκλογή των πιο αξιόπιστων θερμοστοιχείων.

Ξεκινώντας από την αρχή, προκειμένου να ελεγχθεί η ομαλή λειτουργία του φούρνου κατά τον θερμοπρογραμματισμό του, χρησιμοποιήθηκαν τα εξής θερμοστοιχεία: ένα κεραμικό τύπου Κ, ένα ψηφιακό τύπου Κ, και 2 κεραμικά διαφορετικού μήκους τύπου Β (Pt. Rh 6% - Pt. Rh 30% ή Pt. 18).

Όλα τα παφαπάνω θεφμοστοιχεία συνδέονται με φυθμιστές (controllers) και ψηφιακά πολύμετφα (multimeters) μέσω καλωδίων πφοέκτασης (extension wires). Τα εν λόγω καλώδια φτιάχνονται έτσι ώστε να είναι συμβατά με συγκεκφιμένου τύπου θεφμοστοιχεία. Έτσι για παφάδειγμα, οι ακφοδέκτες ενός θεφμοστοιχείου τύπου Β συνδέονται με τους αντιστοίχους ενός B-type extension wire. Τα θεφμοστοιχεία αυτά και οι σύντομες ονομασίες που τους δίνονται, καθώς και τα καλώδια πφοέκτασης σε συνδυασμό με αυτά απεικονίζονται παφακάτω:







Ψηφιακό τύπου Κ (Digital type K)



Θερμοστοιχεία (Thermocouples or TC)



Blue type K



Yellow type K



Type B



Cu(χάλκινο) extension wire

Καλώδια ποοέκτασης (Extension wires)



TC Type K & Blue type K extension wire



TC Long Pt18 & Type B extension wire

Εικόνα 20: Θερμοστοιχεία & καλώδια προέκτασης

Μπαίνοντας λοιπόν στη διαδικασία θερμοπρογραμματισμού του φούρνου, τοποθετείται το κεραμικό θερμοστοιχείο τύπου Κ στο κέντρο του από δεξιά. Δηλαδή, στα 17 cm, αφού ο φούρνος έχει συνολικό μήκος 34 cm.Το θερμοστοιχείο αυτό είναι συνδεδεμένο με το blue type K extension wire, του οποίου οι ακροδέκτες καταλήγουν και συνδέονται σε πόλους εντός του ρυθμιστή (controller) του φούρνου, ο οποίος τοποθετείται στο κάτω επίπεδο του μεγάλου τραπεζιού. Από τον controller προγραμματίζονται οι θερμοκρασίες, η χρονική διάρκεια, ο χρόνος σταθεροποίησης σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία κτλ (Manual Controller Φούρνου SHIMADEN FP21/Παράρτημα). Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο controller του φούρνου και το blue type K extension wire:



Εικόνα 21: Ρυθμιστής φούοννου (Controller)

Ο controller συνδέεται μέσω ενός γκρι καλωδίου με τον φούρνο. Οι 2 ακροδέκτες του γκρι καλωδίου βιδώνονται στους πόλους του φούρνου ώστε σύμφωνα με τις εντολές που δίνονται στον controller να δίνεται ρεύμα στον φούρνο:





Εικόνα 22: Ηλεκτοική σύνδεση φούονου-ουθμιστή

Στη συνέχεια, το θεομοστοιχείο τύπου Κ προκειμένου να μείνει σταθερό στο κέντρο του φούρνου στερεώνεται σε έναν 'πιαστήρα', ο οποίος βιδώνεται σε μία σιδερένια βέργα που έχει συγκολληθεί σε μία μεταλλική βάση. Χρησιμοποιούνται 2 κροκοδειλάκια για να

σταθεροποιήσουν τους ακροδέκτες του μπλε τύπου K extension wire που ενώνονται με τους πόλους του κεραμικού θερμοστοιχείου τύπου K:



Πιαστήρας



Κοοκοδειλάκι



Εικόνα 23: Εγκατάσταση θερμοστοιχείου τύπου Κ

Μετά την εγκατάσταση του θεφμοστοιχείου τύπου Κ έχει επιτευχθεί η δυνατότητα θεφμοπφογφαμματισμού του φούφνου από τον controller. Όμως, για να ελεγχθούν οι εκάστοτε θεφμοκφασίες που οφίζονται, χφησιμοποιείται παφάλληλα και ένα δεύτεφο θεφμοστοιχείο το οποίο σύφεται εντός του φούφνου καταδεικνύοντας τις επιμέφους θεφμοκφασίες ανά εκατοστό.

Το θερμοστοιχείο αυτό διαπερνά μία οπή που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του φούρνου. Η εν λόγω οπή, δημιουργήθηκε τρυπώντας μια βάση κυκλικής διατομής από αμίαντο που έχει βιδωθεί στο φούρνο, με σκοπό να εμποδίζει τη διάχυση θερμότητας στο περιβάλλον. Στην παρακάτω εικόνα είναι φανερά τα παραπάνω, καθώς και ένα προστατευτικό μέταλλο που βιδώνεται πάνω από τους πόλους του φούρνου:



Εικόνα 24: Οπή σε βάση αμιάντου και προστατευτικό μέταλλο

Τρία θερμοστοιχεία έχουν τη δυνατότητα να διαπεράσουν τη συγκεκριμένη οπή: το ηλεκτρονικό τύπου Κ, και τα 2 κεραμικά διαφορετικού μήκους τύπου Β (Pt. Rh 6% - Pt. Rh 30% ή Pt. 18). Σε αυτήν την πειραματική διάταξη δίνεται έμφαση στα θερμοστοιχεία τύπου Β καθώς θεωρητικά παρουσιάζουν μεγαλύτερη θερμική αντοχή και αξιοπιστία από τα αντίστοιχα τύπου Κ σε διαδικασίες υψηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο, αυτό θα ελεγχθεί και στη συνέχεια.

Συνεπώς, τα θεφμοστοιχεία Long Pt18 και Short Pt18 συνδέονται με το B-type extension wire, του οποίου οι ακφοδέκτες καταλήγουν και συνδέονται στους πόλους ενός ψηφιακού πολυμέτφου (Keithley multimeter), το οποίο εγκαθίσταται στο μεσαίο επίπεδο του μεγάλου τφαπεζιού και μετφάει διαφοφά δυναμικού σε mV (millivolts) σε καθεστώς συνεχούς φεύματος (DC). Αυτή η διαφοφά δυναμικού αντιστοιχίζεται σε μία θεφμοκφασία μέσω ειδικών πινάκων αναφοφάς για θεφμοστοιχεία συγκεκφιμένου τύπου (Πίνακας 5 και 6/Παφάφτημα).

Το θεφμοστοιχείο Long Pt18 ή το Short Pt18 στηρίζονται πάνω σε 2 σφικτήρες οι οποίοι τοποθετούνται σε 2 βέργες στήριξης που είναι βιδωμένες πάνω σε μία μεταλλική βάση. Τα εγκατεστημένα στοιχεία που αφορούν ένα θερμοστοιχείο που εισέρχεται από την πίσω πλευρά του φούρνου παρίστανται παρακάτω:





Ψηφιακό πολύμετοο (Keithley multimeter)





Εικόνα 25: Εγκατάσταση θερμοστοιχείου τύπου Β

Μία συνολική εικόνα της προαναφερθείσας εγκατάστασης των 2 θερμοστοιχείων, που είναι απαραίτητα για τον θερμοπρογραμματισμό και έλεγχο της λειτουργιάς του φούρνου φαίνεται και παρακάτω:



Εικόνα 26: Συνολική εγκατάσταση θερμοστοιχείων για προσδιορισμό θερμοκρασιακού προφίλ

Με βάση λοιπόν τη παραπάνω διάταξη, ο φούρνος προγραμματίζεται να ανέλθει και να σταθεροποιηθεί κατά σειρά στους 300 °C, 800 °C και 1000 °C. Η θέρμανση επιτελείται με βήμα 5 °C/min, και ο controller δείχνει ότι καταναλώνεται ρεύμα 50%, 70% και 90% αντίστοιχα, για να πραγματοποιηθεί η άνοδος στις παραπάνω θερμοκρασίες.

Το θερμοστοιχείο τύπου Κ είναι μονίμως στερεωμένο στο κέντρο του φούρνου, ενώ τα θερμοστοιχεία τύπου Β (και το ψηφιακό τύπου Κ) σύρονται ανά εκατοστό από τη μία άκρη του φούρνου στην άλλη. Αξιοσημείωτο είναι το μαλλί από πυριτικό αργίλιο (aluminum silicate wool) που λειτουργεί ως θερμομονωτικό και τοποθετείται γύρω από το θερμοστοιχείο τύπου Κ ώστε να μη διαχέεται θερμότητα στο περιβάλλον. Στις παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζεται η τοποθέτηση αυτών των θερμοστοιχείων κατά την θέρμανση του φούρνου:







Εικόνα 27: Απεικόνιση θερμοστοιχείου τύπου Κ μέσα στον φούρνο με θερμομόνωση από μαλλί πυριτικού αργιλίου (aluminum silicate wool)

Επομένως, σε κάθε σταθεφή θεφμοκρασία, που δείχνει το στερεωμένο θεφμοστοιχείο, και εμφανίζεται στο front panel του controller, καταγράφονται 34 μετρήσεις (όσες και το μήκος του φούρνου) από τα θεφμοστοιχεία που σύρονται κατά μήκος του. Έτσι, διαμορφώνονται με τη βοήθεια του προγράμματος Origin διαγράμματα της θεφμοκρασίας συναρτήσει της απόστασης (θεφμοκρασιακά προφίλ), τα οποίο δείχνουν τι θεφμοκρασίες που έχει πραγματικά ο φούρνος συγκριτικά με εκείνες που προγραμματίζεται να πιάσει. (Σημειώνεται ότι το σημείο μηδέν στον άξονα x αντιστοιχεί στη δεξιά πλευρά του φούρνου, όντας αυτό σε πλάγιο προφίλ):



Γράφημα 1: Θερμοκρασιακά προφίλ στους 300, 800, 1000 °C, για τον έλεγχο των θερμοστοιχείων τύπου Β και Κ

Στους 300 °C, στην πεφιοχή 12 έως 16 cm διαμοφφώνεται μία σταθεφή θεφμοκφασιακή ζώνη με μέση θεφμοκφασία 286 °C σύμφωνα με το Short Pt18 θεφμοστοιχείο (μαύφη καμπύλη) και 296 °C με το ψηφιακό τύπου Κ (κόκκινη καμπύλη). Πφοκύπτει το συμπέφασμα δηλαδή, ότι αφενός η θεφμοκφασιακή απόκφιση του φούφνου εμφανίζει αποκλίσεις, και αφετέφου ότι υπάφχει μία μέση απόκλιση 10 °C μεταξύ των 2 θεφμοστοιχείων.

Αυτή η απόκλιση δικαιολογείται, διότι τα θεομοστοιχεία τύπου B (Short και Long Pt18) είναι πιο σταθεφά και αξιόπιστα σε υψηλές θεομοκφασίες (>600 °C). Αντίθετα, τα θεομοστοιχεία τύπου K είναι πεφισσότεφο αξιόπιστα σε χαμηλές θεομοκφασίες και σε υψηλές εμφανίζουν οφισμένες φοφές αστάθεια. Επομένως, θεωφείται στους 300 °C, καλύτεφη η κόκκινη καμπύλη, η οποία εμφανίζει μέγιστη τιμή 298 °C στα 14 και 15 cm εντός του φούφνου.

Στους 800 °C, διαπιστώνεται στην περιοχή 13 έως 17 cm μία θερμοκρασιακή σταθερότητα στις 2 καμπύλες του παραπάνω γραφήματος. Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι η μέση θερμοκρασία για το Short Pt18 θερμοστοιχείο (τιρκουάζ καμπύλη) είναι ίση με την αντίστοιχη για το Long Pt18 (μπλε καμπύλη), δηλαδή 791 °C. Ακόμα, όπως και στους 300 °C, στα 14 και 15 cm καταγράφονται μέγιστες θερμοκρασίες 793 °C.

Άφα, εφόσον υπάφχει τέλεια σύγκλιση των μετφήσεων για τα 2 θεφμοστοιχεία, η πφαγματική θεφμοκφασία του φούφνου στη θεφμοκφασιακή ζώνη είναι μικφότεφη από 800 °C και συμπίπτει με εκείνες των θεφμοστοιχείων τύπου Β.

Στους 1000 °C, εντός της περιοχής 12 με 16 cm στον φούρνο, οι 2 απεικονιζόμενες καμπύλες του παραπάνω γραφήματος παρουσιάζουν μία πιο σταθερή θερμοκρασιακή ζώνη. Η μέση θερμοκρασία αυτής που αντιστοιχεί στο Long Pt18 θερμοστοιχείο (ροζ καμπύλη) είναι 994 °C, ενώ 996 °C είναι η αντίστοιχη μέση θερμοκρασία που καταγράφει το Short Pt18 θερμοστοιχείο (χρυσή καμπύλη). Επιπλέον, το μέγιστο της ροζ καμπύλης ανέρχεται στους 997 °C στα 14 cm, ενώ της χρυσής στους 999 °C επίσης στα 14 cm. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα, προκύπτει μία μέση απόκλιση 2 °C ανάμεσα στις ενδείξεις των 2 θερμοστοιχείων.

Η απόκλιση αυτή μπορεί να οφείλεται είτε σε σφάλμα ενός εκ των δύο, είτε σε πραγματική διαφορά θερμοκρασίας τη δεδομένη χρονική στιγμή λόγω διάχυσης θερμότητας στο περιβάλλον. Ωστόσο, είναι μικρή και άρα όχι ανησυχητική.

Αποτιμώντας συνολικά τα αποτελέσματα του Γραφήματος, επιβεβαιώνεται η καλή αξιοπιστία και αποδοτικότητα των θερμοστοιχείων τύπου Β στις υψηλές θερμοκρασίες (800, 1000 °C), καθώς και η αντίστοιχη φερεγγυότητα των θερμοστοιχείων τύπου Κ σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (300 °C). Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι στα 14 cm μετρώντας από τη δεξιά πλευρά του φούρνου παρουσιάζεται πάντα μέγιστη θερμοκρασία. Πράγμα το οποίο αποτελεί πολύ σημαντικό πόρισμα για τη μετέπειτα ανάλυση που θα γίνει.

2.4.2 Εγκατάσταση δειγματοφοφέα και βφαχίονα (manipulator) στον διπλό σταυφό και έλεγχος συμβατότητας διαφόφων καλωδίων πφοέκτασης (extension wires) με θεφμοστοιχείο τύπου B

Στη συγκεκοιμένη πειραματική διάταξη, θα επιλεγεί ένα από τα παραπάνω θερμοστοιχεία που θα σύρεται κατά μήκος του φούρνου καταδεικνύοντας τις επιμέρους θερμοκρασίες ανά εκατοστό. Όμως, δε θα χρησιμοποιηθεί το κεραμικό θερμοστοιχείο τύπου Κ, που επιλέχθηκε προηγουμένως να στερεωθεί στο κέντρο του φούρνου, για τον έλεγχο της λειτουργιάς του και των θερμοστοιχείων, αλλά ένας κεραμικός δειγματοφορέας, μήκους 31 cm, με ενσωματωμένο θερμοστοιχείο τύπου B (Pt. Rh 6% - Pt. Rh 30% ή Pt. 18).

Ο δειγματοφοφέας είναι απαφαίτητος, καθώς διαθέτει χώφο για την τοποθέτηση του δείγματος και είναι πιο αποδοτικός και αξιόπιστος σε διαδικασίες υψηλών θεφμοκφασιών λόγω του θεφμοστοιχείου του τύπου Β. Τα 2 σύφματα του θεφμοστοιχείου αυτού, που πφοεκτείνονται εκτός του δειγματοφοφέα, είναι επικαλυμμένα με κφάμα πλατίνας (Σημείο τήξης: 1772 °C) ώστε να μην φθείφονται σε μεγάλες θεφμοκφασίες. Ο δειγματοφοφέας θα στεφεωθεί σε έναν βφαχίονα φύθμισης θέσεως (manipulator) μήκους 69 cm, που εγκαθίσταται στον σταυφό.

Ο manipulator διαθέτει έναν ενσωματωμένο μαγνήτη, ώστε σύgοντας τον κατά μήκος της μεταλλικής επιφάνειας, να επιφέgει τις όποιες επιθυμητές μετατοπίσεις στον δειγματοφοgέα, που στεgεώνεται σε αυτόν. Στην παgακάτω εικόνα, φαίνονται όλα τα εξαgτήματα που απαιτούνται ώστε να πgaγματοποιηθεί η εγκατάσταση του manipulator στον σταυgό. Δηλαδή, ένας πgoσagμογέας συστολής 40 KF σε 30 CF, που βιδώνεται μέσω ενός σετ 6 βιδών Pfeiffer M6, ενά χάλκινο δαχτυλίδι, το οποίο τοποθετείται ανάμεσα στις CF επιφάνειες του πgoσagμογέα και του manipulator, και ένα δαχτυλίδι NW40 από viton και ανοξείδωτο χάλυβα, που τοποθετείται ανάμεσα στις KF επιφάνειες του πgοσagμογέα και του σταυgού, οι οποίες στεgεώνονται με έναν σφικτήgα NW40.



Δειγματοφορέας



Ποοσαομογέας συστολής 40 KF σε 30 CF

Βοαχίονας (Manipulator)





Χάλκινο δαχτυλίδι (Copper ring)

Σετ βιδών (Pfeiffer bolt set)





Σφικτήρας NW40

Δαχτυλίδι από ανοξείδωτο χάλυβα και viton (Seal centering ring)



Εικόνα 28: Εγκατάσταση και συνδεσμολογία δειγματοφορέα & βραχίονα (manipulator) στον διπλό σταυρό

Έχοντας εγκαταστήσει λοιπόν τον δειγματοφορέα στον manipulator, γίνεται η διαπίστωση ότι οι ακροδέκτες του θερμοστοιχείου του πρώτου, πρέπει να συνδεθούν μέσω ηλεκτρικών συνδέσεων με τον controller του φούρνου. Επομένως, επειδή πρόκειται για θερμοστοιχείο τύπου B και ο controller διαθέτει ένα blue type K extension wire πρέπει να γίνει έλεγχος για το κατά πόσον μία τέτοια σύνδεση δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, θα παρθεί ένα θερμοκρασιακό προφίλ στους 1000 °C με σταθερό πάλι θερμοστοιχείο το κεραμικό τύπου K συνδεδεμένο με το blue type K extension wire στον controller. Μάλιστα, αυτή τη φορά το σταθερό θερμοστοιχείο θα τοποθετηθεί στα 14 cm του φούρνου μετρώντας από τη δεξιά του πλευρά, αφού συμφωνά με το προηγούμενο πείραμα, σε εκείνο το σημείο επιτυγχάνει πάντα μέγιστη θερμοκρασία. Ωστόσο, θα σύρεται κατά μήκος το τύπου B, Long Pt18 θερμοστοιχείο, με τη διαφορά ότι εκτός από το B-type extension wire που συνδέθηκε στις προηγούμενες μετρήσεις με αυτό, θα ελεγχθεί η θερμοκρασιακή απόκριση του συγκεκριμένου θερμοστοιχείου συνδέοντας το

και με τα yellow type K και Cu (χάλκινο) extension wires. Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται το θερμοκρασιακό προφίλ στους 1000 °C:



Γράφημα 2: Θερμοκρασιακό προφίλ στους 1000 °C, για τον έλεγχο καλωδίων προέκτασης (extension wires) συνδεδεμένα με θερμοστοιχείο τύπου B (Long Pt18)

Σύμφωνα με αυτό το γράφημα για τους 1000 °C, είναι ευδιάκριτο ότι στην περιοχή 13 έως 15 cm εντός του φούρνου σχηματίζεται μία σταθερή θερμοκρασιακή ζώνη για όλες τις εικονιζόμενες καμπύλες.

Για τη σύνδεση με το yellow type K extension wire, η μέση θεομοκοασία σε αυτή τη πεοιοχή, ανέρχεται στους 1005 °C (μαύρη καμπύλη). Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι ενδείξεις στο ψηφιακό πολύμετρο Keithley, όπου συνδέθηκε το extension wire, δε σταθεροποιούνταν.

Για τις συνδέσεις είτε με το B-type είτε με το Cu (χάλκινο) extension wire, η μέση θεομοκοασία της ποοαναφερθείσας σταθερής θεομοκοασιακής ζώνης, είναι κοινή και ισούται με 986 °C (μπλε και κόκκινη καμπύλη). Επιπρόσθετα, οι τιμές που καταγράφονταν στο πολύμετρο ήταν σταθερές.

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι, εφόσον το θερμοστοιχείο Long Pt18 συνδεδεμένο με το yellow type K extension wire, έδειξε μία μέση θερμοκρασία κατά 19 °C μεγαλύτερη από αυτή που κατέγραψε όντας συνδεδεμένο με τα άλλα 2 extension wires, η σύνδεση ενός θερμοστοιχείου τύπου Β με καλώδιο προέκτασης τύπου Κ είναι αναξιόπιστη και δίνει ανακριβή αποτελέσματα. Κάτι που το ενισχύει το γεγονός ότι οι τιμές του πολυμέτρου έπαιζαν, σε αντίθεση με τη περίπτωση της σύνδεσης του θερμοστοιχείου με τα άλλα extension wires.

Επιπλέον, είναι πολύ ικανοποιητικό ότι το Cu extension wire δίνει τα ίδια αποτελέσματα με το αντίστοιχο B-type. Αυτό σημαίνει ότι ένα καλώδιο ποοέκτασης που αποτελείται από σύομα χαλκού μποοεί να συνδεθεί με θεομοστοιχείο τύπου B με την ίδια αποδοτικότητα ενός καλωδίου τύπου B.

Τελικά, ο φούφνος έπιασε μέση θεφμοκφασία κατά 14 °C λιγότεφη από αυτήν των 1000 °C για την οποία πφογφαμματίστηκε, και σε επανάληψη του ίδιου πειφάματος 24 h μετά. Το γεγονός αυτό, δεν ικανοποίησε και έθεσε πφοβληματισμούς για το αν το θεφμοστοιχείο Long Pt18 δείχνει πφαγματική θεφμοκφασία ή αν όντως ο φούφνος έπιασε 986 °C στη σταθεφή θεφμοκφασιακή του ζώνη.

2.4.3 Θερμοκρασιακό προφίλ στους 1000 °C για τον φούρνο Nabertherm

Προκειμένου να απαντηθεί με σιγουριά το παραπάνω ερώτημα και να γίνει οριστικά η εκλογή των θερμοστοιχείων και των extension wires, που θα χρησιμοποιηθούν στη πειραματική διάταξη, αποφασίστηκε να γίνει ο έλεγχος τους εκ νέου στους 1000 °C, αλλά σε άλλον φούρνο του Εργαστηρίου.

Ο φούονος που επιλέχθηκε έχει μήκος 36 cm, δικό του ενσωματωμένο θεομοστοιχείο και ονομάζεται Nabertherm:



Εικόνα 29: Φούονος Nabertherm

Επιλέγονται λοιπόν κατά σειφά οι εξής συνδυασμοί θεφμοστοιχείων-extension wires: το κεφαμικό τύπου Κ με το yellow type K extension wire, το Long Pt18 με το B-type και με το Cu (χάλκινο) extension wire, το θεφμοστοιχείο του δειγματοφοφέα με το Cu extension wire και το ψηφιακό τύπου Κ θεφμοστοιχείο. Αφού το μήκος του φούφνου είναι 36 cm και θεωφητικά στο κέντφο του πιάνει τις μεγαλύτεφες θεφμοκφασίες, τα παφαπάνω θεφμοστοιχεία σύφονται κατά μήκος της πεφιοχής 15 έως 21 cm του φούφνου Nabertherm. Έτσι, για τις παφαπάνω τιμές των αποστάσεων καταστφώνεται το θεφμοκφασιακό πφοφίλ του φούφνου στους 1000 °C:



Γράφημα 3: Θερμοκρασιακό προφίλ στους 1000 °C στο φούρνο Nabertherm, για τον τελικό έλεγχο των συνδυασμών των υποψήφιων θερμοστοιχείων & καλωδίων προέκτασης

Με μία πρώτη ματιά στο παραπάνω γράφημα, φαίνεται ξεκάθαρα η καλύτερη θερμοκρασιακή απόκριση των θερμοστοιχείων τύπου Β στις υψηλές θερμοκρασίες συγκριτικά με τα αντίστοιχα τύπου Κ. Οι 3 καμπύλες που αντιστοιχούν στα πρώτα, διαγράφονται στην ίδια θερμοκρασιακή ζώνη, ενώ οι 2 καμπύλες που αναφέρονται στα δεύτερα βρίσκονται σε 2 διαφορετικές και ασύμβατες θερμοκρασιακές περιοχές.

Πιο συγκεκοιμένα, το κεραμικό τύπου Κ θερμοστοιχείο ενωμένο με το yellow type K extension wire (μαύρη καμπύλη), παρουσιάζει μέση θερμοκρασία 944 °C στην περιοχή 15 εως 21 cm και μέγιστο τους 950 °C. Το ψηφιακό τύπου Κ θερμοστοιχείο (ροζ καμπύλη), καταγράφει μέση θερμοκρασία τους 956 °C και μέγιστη τιμή τους 962 °C.

Όσον αφορά τα θερμοστοιχεία τύπου B, το Long Pt18 συνδεδεμένο με το B-type extension wire (κόκκινη καμπύλη), παρουσιάζει μέση θερμοκρασία τους 968 °C και μετράει

μέγιστο τους 970 °C. Επίσης, το Long Pt18 ενωμένο με το Cu (χάλκινο) extension wire (μπλε καμπύλη) καταγράφει μέση θερμοκρασία 973 °C και μέγιστη τιμή τους 974 °C. Τέλος, το θερμοστοιχείο του δειγματοφορέα συνδεδεμένο με το Cu extension wire (τιρκουαζ καμπύλη), αποτιμά μέση θερμοκρασία τους 971 °C και παρουσιάζει μέγιστο τους 972 °C.

Συμπερασματικά, το Long Pt18 και ο δειγματοφορέας καταγράφουν, με μέση απόκλιση 5 °C, ότι ο φούρνος Nabertherm έχει μέση θερμοκρασία στην θερμοκρασιακή του ζώνη (15-21 cm) γύρω στους 970 °C. Επομένως, προκύπτει ότι, εφόσον επιβεβαιώνεται πολλές φορές από τα θερμοστοιχεία τύπου B, ο συγκεκριμένος φούρνος όντως πιάνει θερμοκρασία περίπου 30 °C μικρότερη από την επιθυμητή. Άρα, τελικά τα θερμοστοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι πράγματι αξιόπιστα, ενώ οι φούρνοι που ελέγχθηκαν, ορισμένες φορές δεν επιτυγχάνουν τη βέλτιστη απόδοση.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, στη διάταξη του πειράματος για τον φούρνο, που έχει εγκατασταθεί στις ράγες, θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της θερμικής του απόδοσης αλλά και για τις ανάγκες της πειραματικής διαδικασίας, τα εξής θερμοστοιχεία: του δειγματοφορέα και το Long Pt18.

2.4.4 Τελικά θεομοκοασιακά ποοφίλ για τον έλεγχο της θεομοκοασιακής απόκοισης του φούονου

Το θεφμοστοιχείο Long Pt18 θα συνδεθεί με το B-type extension wire και θα εισέρχεται από την οπή αμιάντου, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του φούρνου, ώστε να σύρεται κατά μήκος του φούρνου καταγράφοντας τις επιμέρους θερμοκρασίες ανά εκατοστό. Ο δειγματοφορέας θα συνδεθεί με το Cu extension wire μέσω γρήγορων συνδέσεων, που θα ενωθούν με τους ακροδέκτες του θερμοστοιχείου του δειγματοφορέα και μεταξύ τους μέχρι να φτάσουν στο Cu extension wire, με ηλεκτρικές κολλήσεις (soldering).

Το πρωταρχικό βήμα για να επιτευχθεί η σύνδεση του δειγματοφορέα με Cu extension wire, ήταν να εξέλθει το blue type K extension wire από τον controller του φούρνου και να αντικατασταθεί με το πρώτο. Έτσι, ξεβιδώθηκε ο controller από την μπροστινή του πλευρά και έπειτα αποσυνδέθηκαν οι 2 ακροδέκτες του μπλε καλωδίου, οι οποίοι ήταν βιδωμένοι στο panel. Από τη στιγμή που εξήλθε το μπλε καλώδιο, τοποθετήθηκε στην ίδια θέση και βιδώθηκαν οι ακροδέκτες του, το Cu extension wire χρώματος λευκού. Η διαδικασία αντικατάστασης των καλωδίων που μόλις περιγράφηκε αποτυπώνεται στην παρακάτω εικόνα (Σημειώνεται ότι ρυθμίστηκε άμεσα ο controller να διαβάζει ότι είναι συνδεδεμένος με θερμοστοιχείο τύπου B):





Εικόνα 30: Αντικατάσταση του blue type K (συμβατό με θερμοστοιχεία τύπου K) με το Cu extension wire (συμβατό με θερμοστοιχεία τύπου B)

Στη συνέχεια, ήταν πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, αφότου ο δειγματοφορέας εγκατασταθεί στον manipulator, δε θα εφάπτεται με τον κεραμική επιφάνεια αλούμινας του αντιδραστήρα που θα τον περιβάλλει. Αν τυχόν συμβαίνει αυτό, μπορεί να επηρεάσει την απόκριση του θερμοστοιχείου του δειγματοφορέα, για παράδειγμα να μην σταθεροποιούνται οι ενδείξεις του, αλλά συντρέχει και ο κίνδυνος να καταστραφεί το δείγμα (yttrium silicate), που θα τοποθετηθεί στο δειγματοφορέας εκτός του αντιδραστήρα με τη βοήθεια του μαγνήτη του manipulator.

Παρατηρήθηκε λοιπόν, ότι ο δειγματοφορέας πάχους 1,7 cm εφαπτόταν με το κάτω μέρος του εσωτερικού του αντιδραστήρα εξωτερικής διαμέτρου 2,9 cm. Αποφεύχθηκε αυτό με τη χρησιμοποίηση μίας κεραμικής βάσης στήριξης από μουλίτη, που τοποθετήθηκε στο εσωτερικό του σταυρού, προκειμένου να ανυψώσει τον manipulator και κατά συνέπεια τον δειγματοφορέα:



Εικόνα 31: Κεφαμική βάση (μουλίτη) στήφιξης δειγματοφοφέα

Έτσι λοιπόν, ο αντιδραστήρας τοποθετήθηκε σε ύψος 18 cm από τη βάση του τραπεζιού, ενώ ο δειγματοφορέας σε ύψος 18,6 cm, μέσα στο εσωτερικό του πρώτου. Εφόσον η διάμετρος του αντιδραστήρα μείον το πάχος του δειγματοφορέα είναι: 2,9-1,7=1,2 cm, ο δειγματοφορέας έχει 0,6 cm κενό εκατέρωθεν της πάνω και κάτω πλευράς του αντιδραστήρα, και εγκαθίσταται σε 2 cm απόσταση από το τέλος του. Πρέπει να σημειωθεί ότι προκειμένου να αποφευχθεί η φθορά της βάσης μουλίτη, δε θα σύρεται ο manipulator. Επομένως, όταν θα πρέπει να παρθεί το δείγμα θα σύρεται ο φούρνος προς τα πίσω και θα αποσυνδέεται προσεκτικά ο αντιδραστήρας από τον σταυρό.

Εν συνεχεία, ακολουθήθηκε η διαδικασία συνένωσης και ηλεκτοικής κόλλησης των γρήγορων συνδέσεων, που θα χρησιμοποιηθούν ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ του δειγματοφορέα και του Cu extension wire, ώστε μέσω των φαινομένων ηλεκτρικής αγωγής να δίνεται ρεύμα από τον controller στον δειγματοφορέα, και ο τελευταίος να καταγράφει τη θερμοκρασία εντός του φούρνου.

Η ηλεκτοική κόλληση (soldering) επιτελείται στα εξής βήματα: 1. Θερμαίνονται οι ακοοδέκτες που ποόκειται να κολληθούν με ένα κολλητήρι (soldering iron), 2. Έρχονται σε επαφή το καλάι (solder), το οποίο έχει ποιν θερμανθεί με το soldering iron, με το ένα εκ του ζευγαριού των ακοοδεκτών, 3. Το λιωμένο καλάι μαζί με τον ακοοδέκτη κοατούνται ενωμένα μαζί με τον άλλον ακοοδέκτη μέχρι να κολλήσουν, 4. Γίνεται η κόλληση ενός λάστιχου πάνω στο ζευγάρι των ακοοδεκτών, με τη βοήθεια ενός θερμοσυστελόμενου σεσουάρ. Στην ποοκειμένη περίπτωση, οι ακοοδέκτες του θεομοστοιχείου του δειγματοφορέα κολλιούνται με 2 αρσενικούς ακοοδέκτες επικαλυμμένους με χρυσό. Έπειτα, στους τελευταίους συνδέονται οι θηλυκοί ακοοδέκτες 2 γρήγορων συνδέσεων, που εισέρχονται εντός του σταυρού, ώστε οι αρσενικοί ακοοδέκτες της κατάληξης τους, να κολληθούν εκ νέου στους αντίστοιχους ενός αντάπτορα. Ο τελευταίος, συνδέεται με τον σταυρό μέσω ενός προσαρμογέα συστολής NW40 σε NW16 με τη χρήση των αντιστοίχου μεγέθους σφικτήρων και δαχτυλιδιών. Στην κάτω πλευρά του αντάπτορα όπως έχει συνδεθεί στον σταυρό, εξέρχονται 4 γρήγορες συνδέσεις με απολήξεις 4 αρσενικούς ακορδέκτες. Έτσι, γίνεται μία ακόμα ηλεκτρική κόλληση γρήγορων συνδέσεων στους 2 από αυτούς (τους ακορδέκτες του κόκκινου και του μαύρου σύρματος), ώστε με τη χρήση μεταλλικών 'μπανανών' να επιτευχθεί η τελική ένωση των γρήγορων συνδέσεων με το Cu extension wire, το οποίο έχει εγκατασταθεί στον controller του φούρνου. Τα πιο σημαντικά μέρη της διαδικασίας που περιγράφηκε, φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:



Soldering iron



Καλάι (Solder)



Κόλληση δειγματοφορέα





Θηλυκός ακ**οοδέκτης** γοήγοοης σύνδεσης

Κόλληση πάνω πλευράς αντάπτορα



Κόλληση κάτω πλευράς αντάπτορα



Εικόνα 32: Ένωση δειγματοφορέα – χάλκινου καλωδίου προέκτασης (Cu extension wire) μέσω γρήγορων συνδέσεων, που συνδέονται με ηλεκτρική κόλληση (soldering)

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, η πειραματική διάταξη είναι έτοιμη ώστε να παρθούν τα τελικά θερμοκρασιακά προφίλ στο φούρνο. Σε αυτή τη διάταξη που απεικονίζεται παρακάτω, ο δειγματοφορέας διατηρείται σταθερός στα 14 cm μέσα στον φούρνο και το θερμοστοιχείο τύπου B Long Pt18 σύρεται κατά μήκος του και καταγράφει θερμοκρασία με τη βοήθεια του B-type extension wire, του οποίου οι ακροδέκτες συνδέονται στους πόλους του ψηφιακού πολυμέτρου Keithley. Έτσι, προσδιορίζονται τα θερμοκρασιακά προφίλ του φούρνου στους 400, 600, 800 και 1000 °C.



Εικόνα 33: Πειφαματική διάταξη προσδιοφισμού των τελικών θεφμοκφασιακών πφοφίλ του φούφνου, με σταθεφοποιημένο δειγματοφοφέα, και θεφμοστοιχείο τύπου Β (Long Pt18) που έχει τη δυνατότητα να σύφεται κατά μήκος του



Γοάφημα 4: Θεομοκοασιακά ποοφίλ στους 400, 600, 800, 1000 °C για τον έλεγχο της θεομοκοασιακής απόκοισης του φούονου

Σκιαγραφώντας το σύνολο του παραπάνω γραφήματος με μία πρώτη ματιά, είναι προφανές ότι σε κάθε σταθερή θερμοκρασία που ρυθμίζεται ο φούρνος, σχηματίζεται μία σταθερή θερμοκρασιακή ζώνη μεταξύ 13 και 15 cm βάσει των τιμών που αποκρίνεται το θερμοστοιχείο Long Pt18, το οποίο προσδιορίζει τα θερμοκρασιακά προφίλ κατά μήκος του φούρνου.

Στους 400 °C (μαύρη καμπύλη), η μέση θερμοκρασία που καταγράφεται στη προαναφερθείσα θερμοκρασιακή ζώνη, ανέρχεται στους 395 °C. Συγκεκριμένα, το

θεφμοστοιχείο μετράει 395 °C στα 13, 14 και 15 cm του φούρνου. Άρα, η μέση συμπίπτει με τη μέγιστη θερμοκρασία που πιάνει ο φούρνος.

Στους 600 °C (κόκκινη καμπύλη), το θεομοστοιχείο μετράει μέση θεομοκρασία τους 595 °C στη σταθερή θεομοκρασιακή περιοχή του φούρνου. Και όπως και πριν, η μέση θεομοκρασία είναι ίδια με την μέγιστη.

Στους 800 °C (μπλε καμπύλη), η μέση θερμοκρασία της σταθερής θερμοκρασιακής ζώνης είναι 794 °C βάσει των αποκρίσεων του θερμοστοιχείου. Εδώ, η καμπύλη πιάνει μέγιστο τους 795 °C στα 14 cm εντός του φούρνου.

Στους 1000 °C (τιρκουάζ καμπύλη), ο φούρνος έχει μέση θερμοκρασία στη θερμοκρασιακή του ζώνη, τους 994 °C. Και μέγιστη τιμή τους 995 °C στα 14 cm.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε συνθήκες πειραματικής διαδικασίας ο δειγματοφορέας θα περιβάλλεται από τον κεραμικό αντιδραστήρα, διότι μετά την θέρμανση των δειγμάτων θα πρέπει να δημιουργούνται άμεσα συνθήκες πιέσεων υψηλού κενού από τις αντλίες χαμηλού (περιστροφική) και υψηλού (τουρμπομοριακή) κενού. Άρα, όλο το σύστημα που περιβάλλει το δείγμα: αντιδραστήρας, σταυρός, βάνα κενού, μετρητής πίεσης, manipulator, αντάπτορας, τάπα (blind) ή σωλήνες 6 mm, θα πρέπει να είναι καλά σφραγισμένο με τη χρήση σφικτήρων, ώστε να μην εισέρχεται ατμοσφαιρικός αέρας (Τα συστατικά μέρη που είναι σχετικά με την πειραματική διαδικασία άντλησης κενού αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο)

Επομένως, τα δείγματα θεομαίνονται στις επιμέρους θεομοκρασίες και περιβάλλονται από τον κεραμικό αντιδραστήρα. Προκειμένου λοιπόν, να μην ξεκολλήσει και σπάσει το κεραμικό περίβλημα αλούμινας από τη βάση ανοξείδωτου χάλυβα του αντιδραστήρα, πρέπει να ψύχεται η βάση αυτή με τη βοήθεια ενός θερμοστάτη (ψυκτικού). Αυτό επιτυγχάνεται αν συνδεθεί ο θερμοστάτης μέσω λάστιχου πάχους 12 mm με τις συνδέσεις νερού ψύξης (water cooling connections) του αντιδραστήρα.



Δείκτης κυκλοφορίας νερού ψύξης



Σύνδεση των συνδέσεων νεφού ψύξης του αντιδφαστήφα με λάστιχα που καταλήγουν στον θεφμοστάτη



Θεομοστάτης (Ψυκτικό)

Ρυθμιστής θεομοστάτη

Εικόνα 34: Ψύξη της μεταλλικής βάσης του κεφαμικού αντιδφαστήφα με τη χφήση θεφμοστάτη

2.4.5 Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, η θερμοκρασιακή απόκριση του φούρνου κρίνεται ικανοποιητική, διότι εμφανίζει μία μέση απόκλιση 5 °C για τους 400 και 600 °C, και 6 °C για τους 800 και 1000 °C. Άρα, αυτές οι αποκλίσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά που θα θερμαίνονται δείγματα στην παρούσα πειραματική διάταξη, ώστε αν είναι απαραίτητη η θερμοκρασιακή ακρίβεια, να ρυθμίζεται ο controller του φούρνου κατά 5 °C περίπου πιο πάνω από την επιθυμητή θερμοκρασία. Για παράδειγμα, αν η επιθυμητή είναι 1000 °C, ο controller μπορεί να ρυθμιστεί στους 1005 °C.

Επιπρόσθετα, επιβεβαιώθηκε το σημείο στο οποίο ο φούρνος παρουσιάζει πάντοτε μέγιστες τιμές, δηλαδή στα 14 cm μετρώντας από τη δεξιά πλευρά του, που εισέρχεται ο δειγματοφορέας. Επομένως, ήταν σωστή η τοποθέτηση του δειγματοφορέα, ο οποίος εγκαταστάθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε η άκρη του ενσωματωμένου θερμοστοιχείου του να βρίσκεται στα 14 cm.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να διασφαλιστούν οι συνθήκες που απαιτούνται για διαδικασίες υψηλών θερμοκρασιών στο φούρνο.

2.5 Εγκατάσταση αντλιών και εξαρτημάτων τεχνολογίας κενού

2.5.1 Συνδεσμολογία περιστροφικής αντλίας

Το αντλιοστάσιο θα εδραιωθεί στο μικρότερο σε μήκος τραπέζι. Στο μεσαίο επίπεδο του θα τοποθετηθεί η τουρμπομοριακή αντλία και στο κάτω επίπεδο η περιστροφική αντλία. Στην παρακάτω εικόνα δίνεται η χωρική διάταξη των αντλιών με βάση την οποία θα διαμορφωθεί η συνδεσμολογία τους:



Εικόνα 35: Διάταξη αντλιών

Η λειτουργία της περιστροφικής αντλίας βασίζεται σε δύο σημεία. Το σημείο κατάθλιψης (pressure connection) και το σημείο αναρρόφησης (suction connection):



Σημείο κατάθλιψης



Σημείο αναρρόφησης

Εικόνα 36: Σημεία λειτουργίας της περιστροφικής αντλίας

Δίπλα στο σημείο κατάθλιψης από αφιστεφά υπάφχει η ένδειξη 'oil fill' απ' όπου τοποθετείται στην αντλία λάδι για λίπανση και πφοστασία από τη διάβφωση. Στο σημείο αναφφόφησης τοποθετείται ένα δαχτυλίδι NW10 με ενσωματωμένη σήτα για μεγαλύτεφη πφοστασία από τα υπολείμματα. Πάνω από το σημείο αναφφόφησης, βφίσκεται η ένδειξη 'gas ballast valve', και πφόκειται για μία βαλβίδα που αν μείνει ανοιχτή αυξάνει την θεφμοκφασία λειτουφγίας κενού της αντλίας. Στην συγκεκφιμένη διάταξη, η 'gas ballast valve' θα είναι διαφκώς κλειστή, όπως και απεικονίζεται.

Ξεκινώντας τη συνδεσμολογία της περιστροφικής αντλίας από το σημείο αναρρόφησης (suction connection), πάνω στο δαχτυλίδι με τη σήτα τοποθετείται ένας

προσαρμογέας NW10 σε NW16, ώστε να συνδεθεί πάνω σε αυτόν μία ρυθμιστική βάνα NW16 σε NW16. Έπειτα, πάνω στην βάνα τοποθετήθηκε ένας ακόμα προσαρμογέας NW16 σε NW10, αλλά με αντίθετη φορά από την προηγούμενη, ώστε να επιτυγχάνεται συστολή σε διάμετρο 10 mm και να τοποθετηθεί πάνω σ' αυτόν ένας εύκαμπτος σωλήνας μήκους 30 cm NW10 σε NW10, ο οποίος με τη σειρά του αποτελεί συνδετικό κρίκο της περιστροφικής με την τουρμπομοριακή αντλία.





Προσαρμογέας NW10 σε NW16





Βάνα NW16 σε NW16



Εύκαμπτος σωλήνας (Flexible tube NW10 σε NW10)

Εικόνα 37: Εξαρτήματα στο σημείο αναρρόφησης της περιστροφικής αντλίας (suction connection fittings)

Ασφαλώς, χρησιμοποιούνται δαχτυλίδια (seal centering rings) ανάμεσα στις μεταλλικές επιφάνειες και μεταλλικοί σφικτήρες (clamp wing nuts) ώστε να στερεώνονται και να κλείνουν αεροστεγώς όλα τα εξαρτήματα της διάταξης. Για τη εν λόγω συνδεσμολογία, χρησιμοποιήθηκαν 3 σφικτήρες NW16, 2 σφικτήρες NW25, 2 δαχτυλίδια NW10, και 2 δαχτυλίδια NW16.

Στο σημείο κατάθλιψης, τοποθετείται ένας προσαρμογέας συστολής από ανοξείδωτο χάλυβα NW10 σε NW7, όπου στην επιφάνεια του διαμέτρου 10 mm τοποθετείται ένα δαχτυλίδι από viton (συνθετικό από λάστιχο και ελαστομερές) διαμέτρου 25 mm. Τα παραπάνω εξαρτήματα στερεώνονται με ένα σφικτήρα NW16 και στο πάνω μέφος (NW7) του προσαφμογέα τοποθετείται ένα λάστιχο μήκους 73 cm και πάχους 13 cm, το οποίο καταλήγει σε ένα μπουκάλι για την υποδοχή των όποιων πιθανών υπολειμμάτων:



Δαχτυλίδι από Viton, NW25





Ποοσαομογέας συστολής NW10 σε NW7

Λάστιχο συλλογής υπολειμμάτων

Εικόνα 38: Εξαρτήματα στο σημείο κατάθλιψης της περιστροφικής αντλίας (Pressure connection fittings)

69

Μία συνολική εικόνα των σημείων αναρρόφησης και κατάθλιψης αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα:



Εικόνα 39: Συνδεσμολογία περιστροφικής αντλίας

2.5.2 Εγκατάσταση και συνδεσμολογία του μπομοριακής αντλίας

Η τουρμπομοριακή αντλία τοποθετείται στο μεσαίο επίπεδο του μικρότερου σε μήκους τραπεζιού, στο οποίο εγκαθίσταται ξύλινη επιφάνεια μισού μήκους σε σχέση με του τραπεζιού, ώστε να γίνεται η σύνδεση των δύο αντλιών με τον εύκαμπτο σωλήνα.

Για την εγκατάσταση της τουομπομοοιακής αντλίας χρειάστηκε πρωταρχικά να βιδωθεί στο τραπέζι μία βάση από ανοξείδωτο χάλυβα 10 x 10 cm² και πάχους 1,2 cm. Η αντλία βιδώνεται πάνω στη βάση αυτή με τη χρήση 2 βιδών διαμέτρου 4 mm. Ανάμεσα στη βάση και την ξύλινη επιφάνεια του τραπεζιού, τοποθετείται μία διπλή στρώση από αντικραδασμικό λάστιχο 10 x 10 cm² και πάχους 3 mm, ώστε να απορροφάει τυχόν κραδασμούς κατά την λειτουργία και δόνηση της τουρμπομοριακής αντλίας. Η βάση και οι ανοξείδωτες βίδες διαμέτρου 8 mm που χρησιμοποιήθηκαν για το βίδωμα της φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:





Εικόνα 40: Βάση τουρμπομοριακής αντλίας

Στη συνέχεια, δίνεται μία συγκριτική εικόνα παρακάτω όπου αριστερά φαίνεται το μοντέλο της τουρμπομοριακής αντλίας TMU 064 όπως παραλήφθηκε χωρίς τον CF σταυρό, και στο κέντρο και στα δεξιά της εικόνας ο CF σταυρός και ο συνδυασμός των δύο:



Εικόνα 41: Τουομπομοοιακή αντλία & CF σταυοός

Το κάτω μέφος του CF σταυφού έχει εσωτεφική διάμετφο 66 mm, όσο δηλαδή και το πάνω μέφος της τουφμπομοφιακής αντλίας, στο οποίο βιδώθηκε ο σταυφός με τη χφήση 6 βιδών διαμέτφου 7 mm. Ανάμεσα τους παφεμβλήθηκε ένα χάλκινο δαχτυλίδι διαμέτφου 60 mm. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πάνω μέφος της αντλίας υπάφχει σήτα, ώστε να πφοστατεύεται αυτή από υπολείμματα που μποφεί να δημιουφγηθούν κατά τη χφήση της.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες 3 CF σωληνωτές πλευρές του σταυρού. Στις 2 οριζόντιες τοποθετούνται τάπες (blinds) ενώ η πάνω συνδέεται με ένα προσαρμογέα συστολής 30 CF σε 40 KF. Για την εγκατάσταση αυτή έγινε χρήση 18 βιδών διαμέτρου 6 mm με τις αντίστοιχες ροδέλες και τα παξιμάδια τους, καθώς και 3 χάλκινων δαχτυλιδιών.

Ο προσαρμογέας συστολής συνδέεται με έναν εύκαμπτο σωλήνα NW40 σε NW40 μήκους 45 cm, ο οποίος ενώνεται με μία βάνα κενού, η οποία ενσωματώνεται στον σταυρό. Για αυτή τη συνδεσμολογία απαιτούνται 2 σφικτήρες NW40 και 2 δαχτυλίδια NW40 από viσεn και ανοξείδωτο χάλυβα. Τέλος, προκειμένου να λειτουργήσει η τουρμπομοριακή αντλία χρειάζεται έναν ρυθμιστή (controller), ο οποίος ενώνεται μέσω ενός καλωδίου (vacuum cable) με την αντλία. Ακόμα, ενσωματώνονται στην αντλία δύο συνδέσεις για το νερό ψύξης (water cooling connections), οι οποίες συνδέονται με θερμοστάτη ή βάνα βρύσης για περιπτώσεις πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνονται τα βασικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για την εγκατάσταση και τη συνδεσμολογία της τουρμποριακής αντλίας:





Τάπα (Blind CF)



Βίδα Μ18





Βάνα κενού & εύκαμπτος σωλήνας





Καλώδιο σύνδεσης αντλίας-ουθμιστή (Vacuum cable)



Ρυθμιστής (Turbopump

controller)

Συνδέσεις νεφού ψύξης (Water cooling connections)


Εικόνα 42: Εγκατάσταση και συνδεσμολογία τουρμπομοριακής αντλίας

2.5.3 Εγκατάσταση μετοητή πίεσης (transducer) και καταγοαφικού ουθμιστή (vacuum controller)

Αρχικά, προτού εξεταστεί η διαδικασία παραγωγής κενού από τις 2 εγκατεστημένες μηχανικές αντλίες, που περιγράφηκαν λεπτομερώς παραπάνω, ήταν απαραίτητη η εγκατάσταση ενός μετρητή πίεσης (transducer), και του αντιστοίχου καταγραφικού ρυθμιστή του (vacuum controller).

Ο μετρητής πίεσης συνδέεται από την κάτω του πλευρά με τον σταυρό μέσω ενός προσαρμογέα συστολής NW16 σε NW40. Ενώ στην πάνω του πλευρά γίνεται σύνδεση με ένα καλώδιο το οποίο ενώνεται με την πίσω πλευρά του καταγραφικού ρυθμιστή. Για αυτή τη συνδεσμολογία, απαιτούνται 2 σφικτήρες NW40 και NW16 και 2 δαχτυλίδια NW40 και NW16 από viton και ανοξείδωτο χάλυβα. Ο καταγραφικός ρυθμιστής του μετρητή πίεσης εγκαθίσταται δίπλα στον ρυθμιστή της τουρμπομοριακής αντλίας στο μεσαίο επίπεδο του μεγάλου τραπεζιού. Οι τιμές πίεσης που διαβάζει καταγράφονται σε μονάδες mbar.

Τα εξαρτήματα, η διάταξη και η συνδεσμολογία των προαναφερθέντων, απεικονίζονται παρακάτω:



Μετοητής πίεσης (Transducer)



Ποοσαρμογέας συστολής NW16 σε NW40



Πίσω όψη ηλεκτρικών συνδέσεων

Εικόνα 43: Εγκατάσταση και συνδεσμολογία μετρητή πίεσης & καταγραφικού ρυθμιστή



Καταγραφικός ουθμιστής (vacuum controller)



Συνδεσμολογία μετοητή πίεσης



Διάταξη ουθμιστών

2.6 Πειραματική διαδικασία παραγωγής κενού

Με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας και απόδοσης των 2 αντλιών, αλλά και της στεγανότητας των μερών της πειραματικής διάταξης, που έχουν συνδεθεί με την περιστροφική, την τουρμπομοριακή αντλία και τον διπλό σταυρό, ακολουθείται μία συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία άντλησης κενού. Αυτή συνοψίζεται στα εξής βήματα:

- Συσφίγγονται πολύ καλά με τη χρήση σφικτήρων και βιδών όλα τα συστατικά μέρη της συνδεσμολογίας των αντλιών και του σταυρού, ώστε να κλείσουν αεροστεγώς και να μην εισέρχεται (όσο είναι αυτό δυνατόν) ατμοσφαιρικός αέρας μέσα στη διάταξη. Τα μέρη αυτά είναι: ο αντιδραστήρας, ο μετρητής πίεσης (transducer), η βάνα κενού, ο βραχίονας (manipulator), οι αντάπτορες, οι προσαρμογείς συστολής, οι εύκαμπτοι σωλήνες, η βάνα της περιστροφικής αντλίας, οι τάπες (blinds CF) και ο CF σταυρός της τουρμπομοριακής αντλίας, και η τάπα (Blind KF) ή εναλλακτικά η τάπα σωλήνα 6 mm που θα τοποθετηθεί στο πάνω μέρος του σταυρού.
- 2. Τίθεται σε λειτουργία η περιστροφική αντλία έχοντας ανοιχτές τις βάνες της διάταξης. Δηλαδή, η βάνα που συνδέεται με την περιστροφική αντλία έχει διεύθυνση παράλληλη με το λάστιχο συλλογής υπολειμμάτων, όπως εικονίζεται και παραπάνω. Και η βάνα κενού στρέφεται αριστερόστροφα. Έτσι, επιτυγχάνεται η παραγωγή συνθηκών κενού σε όλο το μήκος και ύψος των μερών της διάταξης από το σημείο αναρρόφησης (suction connection) της περιστροφικής αντλίας μέχρι το εσωτερικό του σταυρού και του αντιδραστήρα, ο οποίος περιβάλλει τον δειγματοφορέα και άρα το δείγμα.
- 3. Αναμένεται ένα χρονικό διάστημα ούτως ώστε η περιστροφική αντλία να δημιουργήσει υποπιέσεις της τάξης των $10^{-2} 10^{-3}$ mbar. Οι επιμέρους πιέσεις μετρώνται από τον μετρητή πίεσης (transducer) και καταγράφονται από τον αντίστοιχο καταγραφικό ρυθμιστή του (vacuum controller), ο οποίος ρυθμίζεται να δείχνει μονάδες mbar.
- 4. Ξεκινάει και η λειτουργία της τουρμπομοριακής αντλίας από τον ρυθμιστή της (turbopump controller). Εφόσον τα προηγούμενα βήματα έχουν γίνει σωστά, μέσα σε ένα χρονικό 10-15 min δημιουργούνται συνθήκες πιέσεων υψηλού κενού της τάξης των $10^{-4} 10^{-5}$ mbar.
- 5. Αφότου σταθεφοποιηθεί η ένδειξη του καταγφαφικού φυθμιστή σε μία τιμή πίεσης, κλείνει η βάνα κενού τελείως στφίβοντας την δεξιόστφοφα. Κατά αυτό τον τφόπο

απομονώνονται οι συνθήκες κενού στο εσωτεφικό του σταυφού και του αντιδφαστήφα. Ωστόσο, έχοντας εκμηδενίσει την επίδφαση των αντλιών στο συγκεκφιμένο χώφο, η πίεση αφχίζει και αυξάνεται.

6. Σε αυτό το σημείο και για τα επόμενα 30-40 min, καταγράφονται οι τιμές της πίεσης που αυξάνονται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να καταστρωθεί το διάγραμμα πίεσης-χρόνου και να υπολογισθεί το ποσοστό διαρροής (leak rate) που εμφανίζει η διάταξη μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Κατά αυτόν τον τρόπο, ελέγχεται ο χρόνος μέσα στον οποίο διατηρούνται συνθήκες κενού μέσα στο χώρο όπου βρίσκεται το δείγμα και εξάγονται αναλόγως τα συμπεράσματα.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των τριών πειραμάτων που διεξήχθησαν, τα οποία και θα συζητηθούν στις υποενότητες που ακολουθούν:

ΠΕΙΡΑΜΑ	1	2	3
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	Τάπα (Blind KF)	Τάπα σωλήνα (tube cover)	Φιάλη O_{18} (Oxygen bottle)
ТОҮРМПОМОРІАКН АNOIXTH	10^{-5} mbar	10 ⁻⁵ mbar	10 ⁻⁴ mbar
ΤΟΥΡΜΠΟΜΟΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ	$10^{-3} - 10^{-2} mbar$	10^{-1} - 10^{0} mbar	$10^{-3} - 10^{-2} mbar$
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ	$0,0022 \ \frac{mbar}{min}$	$0,07 \frac{mbar}{min}$	$0,0033 \frac{mbar}{min}$
Πίνακας 2: Α	ποτελέσματα πειοαμάτ	ων διαδικασίας παραγ	ωγής κενού

2.6.1 Διάγραμμα πίεσης-χρόνου για τάπα (Blind KF) στον διπλό σταυρό

Στο πρώτο πείραμα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η παραπάνω διαδικασία άντλησης κενού, τοποθετήθηκε μία τάπα (Blind KF) στο πάνω μέρος του σταυρού όπως απεικονίζεται κάτωθι:



Εικόνα 44: Τάπα (Blind KF)

Πριν ξεκινήσει να λειτουργεί η περιστροφική αντλία, η πίεση που κατέγραψε ο ρυθμιστής του μετρητή πίεσης ήταν λίγο υποατμοσφαιρική, και συγκεκριμένα στα 987,1 mbar \prec 1013 mbar \cong 1 atm. Γεγονός όμως, που δεν επηρέαζε πουθενά στη λειτουργικότητα της διάταξης.

Αφότου τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη αντλία, μετά το πέρας 2 h καταγράφηκε πίεση $5,03 \cdot 10^{-2}$ mbar και σε κείνο το σημείο ενεργοποιήθηκε και η τουρμπομοριακή αντλία από τον ρυθμιστή της. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν αφηνόταν περισσότερο χρονικό διάστημα να λειτουργεί μόνη της η περιστροφική αντλία, η πίεση θα μειωνόταν περισσότερο με πολύ χαμηλούς ρυθμούς και πιθανόν να έφτανε μετά από ώρες σε μεγέθη της τάξης των 10^{-3} mbar. Ωστόσο, δε θα υπήρχε κάποια χρησιμότητα να γίνει αυτό, καθώς είναι ασφαλής η λειτουργία της τουρμπομοριακής αντλίας σε συνθήκες κενού $\leq 10^{-2}$ mbar. Σε πιέσεις μεγαλύτερες από την τελευταία απαγορεύεται να τεθεί σε λειτουργία η τουρμπομοριακή

Από τη στιγμή που άρχισε να δημιουργεί χαμηλές πιέσεις υψηλού κενού η τουρμπομοριακή αντλία, είναι αξιοσημείωτο ότι μέσα σε λιγότερα από 2 min καταγράφηκαν μεγέθη της τάξης των 10^{-4} *mbar*, έπειτα σε 5 min πιέσεις των 10^{-5} *mbar*, ενώ ακριβώς $1 \cdot 10^{-5}$ *mbar* σε 15 min.

Εν συνεχεία και σύμφωνα με τα βήματα 5 και 6, καταγράφηκαν με βήμα 10 sec για τα πρώτα 11 min, βήμα 30 sec μέχρι τα 30 min και βήμα 1 min μέχρι τα 43 min, οι επιμέρους πιέσεις που αύξαναν συνεχώς.

Η διακύμανση της πίεσης συναφτήσει του χφόνου μετά το άνοιγμα της τουφμπομοφιακής αντλίας και μετά το κλείσιμο της βάνας κενού, αποτυπώνεται στο παφακάτω διάγφαμμα:



Γοάφημα 5: Διάγοαμμα πίεσης-χοόνου μετά το άνοιγμα της τουομπομοοιακής αντλίας (Α) και μετά το κλείσιμο της (Β), για τάπα (Blind KF) στον διπλό σταυοό

Όπως φαίνεται από το παφαπάνω γφάφημα, μεταξύ των σημείων Α και Β (3-15 min) της λειτουργίας της τουφμπομοφιακής αντλίας η πίεση μειώνεται κατακόφυφα από $4,2\cdot10^{-4}$ mbar στα 10^{-5} mbar. Μετά το 15 min (B), όπου κλείνει τελείως η βάνα κενού του σταυφού και τίθεται η τουφμπομοφιακή εκτός λειτουργίας, η πίεση αυξάνεται εκθετικά μέσα στον απομονωμένο χώφο του σταυφού και του αντιδφαστήφα (15-55 min) και ανέρχεται στα $8.8\cdot10^{-2}$ mbar στο τέλος της διαδικασίας λήψης μετρήσεων (55 min).

Ένας τρόπος υπολογισμού της ποσότητας ατμοσφαιρικού αέρα σε μονάδες πίεσης ανά χρόνο είναι το ποσοστό διαρροής (leak rate). Αυτό εκφράζεται ως το πηλίκο της τελικής μέτρησης μείον της αρχικής διά τον συνολικό χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη ως σημείο μηδέν τη στιγμή που έκλεισε η βάνα κενού. Επομένως, το ποσοστό διαρροής για το πρώτο

 $\pi \varepsilon i \varphi \alpha \mu \alpha \varepsilon i \nu \alpha \iota: leak rate = \frac{(P \tau \varepsilon \lambda - P \alpha \rho \chi)}{t} = \frac{8.8 \cdot 10^{-2} - 10^{-5}}{40} \frac{mbar}{min} = 0.0022 \frac{mbar}{min}.$

Αποτιμώντας τα παφαπάνω αποτελέσματα, η συνολική διαδικασία άντλησης κενού ήταν ιδιαίτεφα ικανοποιητική. Και αυτό διότι, αφενός επιτεύχθηκαν συνθήκες υψηλού κενού σε διάστημα λίγων λεπτών με τη λειτουφγία της τουφμπομοφιακής αντλίας, και αφετέφου μετά την απενεφγοποίηση της, διατηφήθηκαν αυτές οι συνθήκες σε τάξεις των

10⁻³ *mbar* στα πρώτα 7 λεπτά ενώ παρέμεινα σε τάξεις των 10⁻² *mbar* για το διάστημα 7-40 min. Αποτέλεσμα που έδειξε την καλή λειτουργικότητα της διάταξης των αντλιών, καθώς και την υψηλή στεγανότητα που μπορούν να παρέχουν τα εξαρτήματα τεχνολογίας υψηλού κενού εφόσον συνδεθούν γερά με τη χρήση μεταλλικών βιδών και σφικτήρων.

2.6.2 Διάγραμμα πίεσης-χρόνου για τάπα σε σωλήνα 6 mm (tube cover), που είναι εγκατεστημένος στον διπλό σταυρό

Στο δεύτερο πείραμα που πραγματοποιήθηκε, τοποθετήθηκε ένας εύκαμπτος σωλήνας 6 mm στο πάνω μέρος του διπλού σταυρού και σφραγίστηκε με μία βιδωτή τάπα, όπως απεικονίζεται παρακάτω:



Εικόνα 45: Τάπα σε σωλήνα διαμέτρου 6 mm (Tube cover)

Η λογική αυτού του πειράματος πέραν της επαναληψιμότητας των μετρήσεων ήταν και ο έλεγχος της δημιουργίας πιέσεων κενού στο εσωτερικού του κεραμικού αντιδραστήρα, με τη χρήση συνδέσεων που θα χρησιμοποιηθούν και στη συνέχεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η διάταξη της εγκατάστασης. Αυτό θα δειχθεί ωστόσο αργότερα με την ανάλυση του τρίτου πειράματος.

Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται η συνολική διακύμανση των τιμών πίεσης συναρτήσει του χρόνου του δευτέρου πειράματος από την αρχή ως το τέλος της διαδικασίας παραγωγής κενού:



Γοάφημα 6: Διάγοαμμα πίεσης-χοόνου για τάπα σε σωλήνα 6 mm (Tube cover), που είναι εγκατεστημένος στον διπλό σταυοό. Α-Β: Επιλεγμένο χοονικό διάστημα λειτουογίας της πεοιστοοφικής αντλίας, Γ: Τουομπομοοιακή αντλία σε λειτουογία, Δ: Τέλος λειτουογίας της τουομπομοοιακής

Ξεκινώντας την καταγραφή των μετρήσεων, σημειώνεται η πτώση της πίεσης συναρτήσει του χρόνου έχοντας θέσει σε λειτουργία την περιστροφική αντλία (rotary pump). Όπως γίνεται αντιληπτό και παραπάνω, από τα πρώτα λεπτά οι πιέσεις

κατέρχονται σε τάξεις των 10^{-1} mbar (βλ. διάστημα A-B), ενώ μετά τα 40 min σημειώνονται τάξεις των 10^{-2} mbar. Έπειτα από διάστημα 95 min, καταγράφεται υποπίεση 7,31·10⁻² mbar, η οποία είναι αρκετή ώστε να ξεκινήσει η τουρμπομοριακή αντλία (turbopump) χωρίς κίνδυνο.

Στο διάστημα της ταυτόχοονης λειτουργίας των 2 αντλιών 95-125 min (βλ. διάστημα Γ-Δ) πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ καταγράφηκε κατά ανάλογο τρόπο η διακύμανση της πίεσης με το χρόνο όπως με το πρώτο πείραμα, οι επιμέρους πιέσεις δεν σταθεροποιούνταν στο πάνελ του καταγραφικού ρυθμιστή. Και αυτός ήταν ο λόγος που αφέθηκε να λειτουργεί διπλάσιο χρόνο η τουρμπομοριακή αντλία σε σχέση με την προηγούμενη φορά (30 min έναντι 15 min). Πιο αναλυτικά, μετά το πέρας 2 λεπτών λειτουργίας της τουρμπομοριακής αντλίας, στα 97 min καταγράφεται πίεση χαμηλού κενού $5 \cdot 10^{-4}$ mbar (Σημείο Γ), ενώ από τα 102 έως τα 125 min οι πιέσεις κυμαίνονται στη τάξη των 10^{-5} mbar.

Μετά το κλείσιμο της βάνας κενού και την παφάλληλη παύση της λειτουργιάς των αντλιών (Σημείο Δ), γίνεται ευδιάκριτη και από το παραπάνω γράφημα η γραμμική άνοδος της πίεσης με τον χρόνο στον απομονωμένο χώρο που διαμορφώνει ο διπλός σταυρός με τον αντιδραστήρα, ο οποίος περιβάλλει τον δειγματοφορέα. Καταγράφηκαν τιμές πιέσεων για 30 min. Είναι αξιοσημείωτο ότι εντός μόλις 2 λεπτών (127 min) η πίεση είχε ανέβει κατακόρυφα από 10^{-5} mbar στις τάξεις των 10^{-1} mbar, ενώ στα 140 min η πίεση ανήλθε στο 1 mbar και η τελική μέτρηση στα 155 min στα 2 mbar.

Aκόμα, το ποσοστό διαρορής για το δεύτερο πείραμα είναι:
leak rate =
$$\frac{(P \tau \epsilon \lambda - P \alpha \rho \chi)}{t} = \frac{2.05 - 10^{-5}}{30} \frac{mbar}{min} = 0.07 \frac{mbar}{min}$$
.

Συμπεφαίνοντας από τα αποτελέσματα του παφαπάνω γφαφήματος όσον αφοφά το δεύτεφο πείφαμα, πφοκύπτει η παφατήφηση ότι η διάταξη δε κατόφθωσε να διατηφήσει συνθήκες κενού για πάνω από 2 λεπτά. Ενώ στο πφώτο πείφαμα με την τοποθέτηση της τάπας (Blind KF) διατηφήθηκαν πιέσεις της τάξης των 10⁻² mbar μέχφι και το 40 min. Πφάγμα που αποδίδεται ξεκάθαφα στο μεγάλο ποσοστό διαφφοής (leak rate) ατμοσφαιφικού αέφα εντός της διάταξης, αποκλείοντας βάσει λογικής το ενδεχόμενο η μόλις μεφικών κυβικών εκατοστών πφοέκταση σε όγκο του συνόλου της διάταξης, εντός της οποίας επιχειφείται η δημιουφγία και διατήφηση κενού, να επέφεφε τόσο σημαντικές αλλαγές μεταξύ των 2 πειφαμάτων. Αυτό το πόφισμα θα επιβεβαιωθεί και στη συνέχεια από το τρίτο και τελευταίο πείραμα και την επερχόμενη συζήτηση των τελικών συγκριτικών αποτελεσμάτων.

2.6.3 Διάγραμμα πίεσης-χρόνου για εγκατεστημένη φιάλη O_{18} (Oxygen bottle)

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η πειραματική διάταξη, κρίθηκε σκόπιμη η εγκατάσταση μιας φιάλης που περιέχει αέριο οξυγόνο μοριακού βάρους 18, O_{18} , η οποία θα συνδέεται μέσω σωληνώσεων με τον διπλό σταυρό ώστε να μπορεί να διαχυθεί οξυγόνο σε δείγματα που θα φέρει ο δειγματοφορέας σε μελλοντικές έρευνες.

Όπως απεικονίζεται παφαστατικά και στις παφακάτω εικόνες, πφαγματοποιήθηκαν οφισμένες αλλαγές στη διάταξη. Πιο συγκεκφιμένα, στη φιάλη οξυγόνου βιδώθηκε μια βάνα που θα φυθμίζει την παφοχή του αεφίου. Στην πίσω πλευφά της βάνας βιδώθηκε μία μεταλλική επιφάνεια, η οποία με τη σειφά της βιδώθηκε στην ξύλινη επιφάνεια του μεσαίου επίπεδου του μεγάλου τφαπεζιού. Κατά αυτόν τον τφόπο εγκαταστάθηκε η φιάλη επιτυχώς. Και η σύνδεση της με τον σταυφό επιτεύχθηκε με την ένωση σωληνώσεων εσωτεφικής διαμέτφου 6 mm. Δηλαδή, ένα μικφό σωληνάκι που σχηματίζει γωνία 90 μοιφών ώστε πάνω του να συνδεθεί με ένα σφικτήφα τύπου wing nut NW16 ένας εύκαμπτος σωλήνας μήκους πεφίπου 1 m, ο οποίος θα καταλήγει σε ένα πφοσαφμογέα συστολής ,διαμέτφου NW12 σε NW17, που αποτελεί το συνδετικό κφίκο του σταυφού και του σωλήνα. Για την τελευταία σύνδεση χφησιμοποιούνται 2 σφικτήφες τύπου wing nut NW16 και NW40. Τέλος, όπως φαίνεται και κάτωθι ο μετφητής πίεσης (transducer) μεταφέφεται στο πάνω μέφος του σταυφού ώστε να γίνουν αυτές οι αλλαγές.







Φιάλη Ο₁₈ με βάνα βιδωμένη σε μεταλλική επιφάνεια

Μεταλλική επιφάνεια βιδωμένη στο μεσαίο επίπεδο του μεγάλου τραπεζιού

Μετοητής πίεσης (transducer) στο πάνω μέρος του σταυρού







Εικόνα 46: Εγκατάσταση φιάλης O_{18} (Oxygen bottle)

Το τρίτο πείραμα λοιπόν, είναι η ίδια διαδικασία άντλησης κενού και κατάστρωση των αντιστοίχων διαγραμμάτων πίεσης-χρόνου με τη διαφορά ότι έχει διευρυνθεί ο χώρος λόγω των συνδέσεων της φιάλης οξυγόνου που προστέθηκε.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας παραγωγής κενού φαίνονται στα παρακάτω διάγραμμα, όπου παρουσιάζεται η συνολική διακύμανση της μεταβολής της πίεσης με το χρόνο από τη στιγμή που ξεκίνησε η λειτουργία της πρώτης αντλίας μέχρι και 30 min αφότου είχαν κλείσει και οι 2 αντλίες, που ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης μετρήσεων:



Γφάφημα 7: Διάγφαμμα πίεσης-χφόνου με κλειστή βάνα φιάλης O_{18} . Α: Πεφιστφοφική Αντλία σε λειτουφγία, Β: Τουφμπομοφιακή αντλία σε λειτουφγία, Γ: Σημείο, Δ: Κλείσιμο τουφμπομοφιακής, Ε: Σημείο, Ζ: Τέλος μετφήσεων

Από τη στιγμή που τέθηκε σε λειτουργία η περιστροφική αντλία, η πίεση μειώνεται δραματικά και μετά από 2 min βρίσκεται σε τάξεις των 10^{-1} mbar μέχρι και τα πρώτα 20 min (Σημείο Α). Εν συνεχεία μέχρι και τα 60 min (Διάστημα Α-Β) η πίεση ελαττώνεται με πιο αργούς ρυθμούς, αλλά σε τάξεις των 10^{-2} mbar.

Στα $4 \cdot 10^{-2}$ mbar (Σημείο Β) τίθεται σε λειτουργία και η τουρμπομοριακή αντλία. Η πίεση τότε αρχίζει και μειώνεται με ιλιγγιώδη φυθμό (Διάστημα Β-Γ) και σε μόλις 2 min πιάνει τα $9 \cdot 10^{-4}$ mbar (Σημείο Γ). Ακολούθως, από τα 62 min μέχρι και τα 80 min (Διάστημα Γ-Δ) η πίεση κατέρχεται με αργούς ρυθμούς σε τάξεις των 10^{-4} mbar. Έπειτα, η λειτουργία των 2 αντλιών διακόπτεται και ταυτόχρονα κλείνει η βάνα κενού, ώστε να απομονωθούν οι συνθήκες υψηλού κενού στο χώρο που περιβάλλει αποκλειστικά ο σταυρός και ο αντιδραστήρας, στα $1 \cdot 10^{-4}$ mbar (Σημείο Δ).

Μετά το κλείσιμο της βάνας, στα πρώτα 3 min διατηρούνται συνθήκες κενού της τάξεως των 10^{-3} mbar, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι στο υπόλοιπο εναπομείναν διάστημα λήψης μετρήσεων μεταξύ 83 και 113 min (Διάστημα E-Z) οι μεταβολές της αυξανόμενης πίεσης με το χρόνο κυμαίνονται σε τάξεις των 10^{-2} mbar.

To γεγονός αυτό είναι πολύ θετικό αφού διατηφούνται συνθήκες κενού. Το θετικό αποτέλεσμα του τφίτου πειφάματος επιβεβαιώνεται και από το ποσοστό διαφφοής που υπολογίζεται ως εξής: leak rate = $\frac{(P \tau \epsilon \lambda - P \alpha \rho \chi)}{t} = \frac{9.88 \cdot 10^{-2} - 10^{-4}}{40} \frac{mbar}{min} = 0.0033 \frac{mbar}{min}.$

2.6.4 Συνολικό-συγκριτικό διάγραμμα πίεσης-χρόνου

Με στόχο να γίνει μια σύνοψη των αποτελεσμάτων των τριών πειραμάτων, στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι 3 αντίστοιχες καμπύλες μεταβολής της πίεσης με το χρόνο. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο πείραμα όπου χρησιμοποιήθηκε η τάπα τύπου Blind KF40, η αντίστοιχη καμπύλη είναι σε μαύρο χρώμα. Ομοίως για το δεύτερο (τάπα σωλήνα) και τρίτο (φιάλη O_{18}) πείραμα, οι καμπύλες απεικονίζονται με κόκκινο και μπλε χρώμα αντιστοίχως. Είναι εμφανή 2 σημεία κλειδιά, το Α που σηματοδοτεί το άνοιγμα της τουρμπομοριακής αντλίας, και το Β που αναφέρεται στο κλείσιμο της βάνας κενού καθώς και των 2 αντλιών.



Γράφημα 8: Συνολικό-συγκριτικό διάγραμμα πίεσης-χρόνου με βάση τις διαφορετικές συνδέσεις: Τάπα (Blind KF-μαύρο), Τάπα σωλήνα (Tube cover-κόκκινο) και Φιάλη O_{18} (Oxygen bottle-μπλε)

Αρχικά, παρατηρώντας την πάνω αριστερά εικόνα η οποία αποτελεί ένα 'ζουμ' (από τάξεις 10^{-2} mbar σε 10^{-4} mbar) του παραπάνω γραφήματος και αναφέρεται στο διάστημα λειτουργίας της τουρμπομοριακής αντλίας (Διάστημα Α-Β), είναι εμφανής η μεγαλύτερη μείωση της πίεσης της κόκκινης και της μαύρης καμπύλης συγκριτικά με αυτή της μπλε. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται από την προσθήκη σωλήνων και εξαρτημάτων στο τρίτο πείραμα ώστε να εγκατασταθεί η φιάλη οξυγόνου. Κατά αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε και ο όγκος της διάταξης και έτσι καταστάθηκε πιο δύσκολο για την τουρμπομοριακή αντλία να δημιουργήσει συνθήκες υψηλού κενού. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη με τις τάπες που είχαν τοποθετηθεί στο πρώτο και δεύτερο πείραμα.

Στη συνέχεια, μετά το κλείσιμο της βάνας κενού και των 2 αντλιών (Σημείο Β), φαίνονται οι διακυμάνσεις των 3 καμπυλών στο γράφημα καθώς και το αντίστοιχο 'ζουμ' του στη πάνω δεξιά εικόνα μετά το σημείο Β. Είναι προφανής, όπως τονίστηκε και παραπάνω, η γρήγορη και μεγάλη αύξηση της πίεσης στη περίπτωση του δευτέρου πειράματος και οφείλεται στο μεγάλο ποσοστό διαρροής αέρα λόγω κακής σύσφιξης των σφικτήρων και των βιδών που κλείνουν αεροστεγώς τα μέρη της διάταξης.

Ωστόσο, είναι ευδιάκοιτη και η παρόμοια αύξηση της πίεσης από την μαύρη και μπλε καμπύλη, που αντιστοιχούν στο πρώτο και τρίτο πείραμα. Αμφότερες αυτές οι καμπύλες κυμαίνονται σε τάξεις των 10^{-2} mbar στο μεγαλύτερο διάστημα λήψης των μετρήσεων, ενώ η μπλε ανέρχεται πιο γρήγορα σε λίγο μεγαλύτερες τιμές. Επομένως, προκύπτει ότι έχοντας εγκαταστήσει την φιάλη οξυγόνου με τα συνδετικά της μέρη, οι συνθήκες κενού διατηρούνται σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα έναντι αυτών του πρώτου πειράματος. Κάτι που επίσης είναι εύλογο όπως φαίνεται και από το μεγαλύτερο ποσοστό διαρροής του τρίτου πειράματος (0,0033 $\frac{mbar}{min}$ έναντι 0,0022 $\frac{mbar}{min}$), που αποδίδεται στον επιπρόσθετο όγκο που εγκαταστάθηκε λόγω της φιάλης.

2.6.5 Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, μετά το πέρας των πειραμάτων διαδικασίας άντλησης κενού προκύπτει ότι η περιστροφική και η τουρμπομοριακή αντλία λειτουργούν αρκετά ικανοποιητικά. Επίσης, ο χώρος που οριοθετούν ο αντιδραστήρας με τον σταυρό και τα συνδετικά μέρη του τελευταίου, περιβάλλοντας τον δειγματοφορέα, διατηρεί συνθήκες κενού τάξεως των 10^{-2} *mbar* για χρονικό διάστημα 30-40 min με μικρό ποσοστό διαρροής (leak rate).

3 Εφαρμογές - προτάσεις για μελλοντική έρευνα

3.1 Μελέτη διάχυσης οξυγόνου σε πυριτικό ύττριο (yttrium silicate)

Ένα υλικό το οποίο θα μπορούσε να μελετηθεί με τη χρήση της διάταξης αέριας διάχυσης που κατασκευάστηκε είναι, το μονοκρυσταλλικό πυριτικό ύττριο (yttrium silicate), το οποίο απαντάται στις εξής μοριακές δομές: 1. Y_2SiO_5 , 2. $\gamma - Y_2SiO_7$ ή ως διπυριτικό 3. $Y_2Si_2O_7$ ή ως πολυκρυσταλλικό μίγμα των παραπάνω σε διάφορες μορφές.

Το πυριτικό ύττριο είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται σαν πρόσθετο επίστρωμα σε ανθρακοπυριτικές επιστρώσεις (SiC coatings) με στόχο την προστασία αυτών από την οξείδωση. Τα ανθρακονήματα (C/C-SiC) χρησιμοποιούνται ευρέως ως επιστρώματα στις κατασκευές λόγω των υψηλών μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων τους, με αντοχές που μπορεί να ξεπερνούν τους 2000 °C. Όμως σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 400 °C παρουσιάζουν πολύ μικρές αντοχές στην οξείδωση ώστε δημιουργούνται ρωγμές στην επιφάνεια τους. Έτσι συνήθως επικαλύπτονται με διάφορα υλικά τα οποία βελτιώνουν τις αντοχές των ανθρακοπυριτίων ενάντια στην οξείδωση και τη διάβρωση (8).

Η χρήση λοιπόν αυτή του πυριτικού υττρίου οφείλεται στις καλές χημικές και μηχανικές ιδιότητες του όπως ο χαμηλός συντελεστής Young (περίπου 20 GPa (9)), ο χαμηλός συντελεστής θερμικής διαστολής, τα μικρά ποσοστά εξάτμισης και διαπερατότητας, καθώς και η υψηλή αντοχή στη διάβρωση (10). Ειδικότερα, οι ενώσεις πυριτικού υττρίου παρουσιάζουν καλύτερη αντίσταση στην οξείδωση όταν συνδυάζονται με τις αντίστοιχες ανθρακοπυριτικές διότι έχουν περίπου ισοδύναμους συντελεστές θερμικής διαστολής (11).

Επομένως, είναι εφικτή βάσει των παφαπάνω η μελέτη τέτοιων υλικών στη διάταξη διάχυσης. Κάτι τέτοιο σε συνδυασμό με την επεξεφγασία τους σε μια διάταξη της μεθόδου SIMS, όπου θα εξαχθούν τα ανάλογα συμπεφάσματα για τους συντελεστές διάχυσης του οξυγόνου στο υλικό, θα οδηγήσει σε ανάλογες έφευνες για την αποτελεσματικότητα του υλικού απέναντι στην οξείδωση σε διαδικασίες υψηλών θεφμοκφασιών.

3.2 Αναπροσαρμογή της πειραματικής διάταξης διάχυσης με χρήση ενός συστήματος ανάμειξης αερίων

Στη συγκεκοιμένη πεοίπτωση, η διάταξη διάχυσης αναποοσαομόζεται και στο σημείο σύνδεσης των 2 αντλιών χρησιμοποιούνται 2 διαφορετικοί εύκαμπτοι σωλήνες. Ο ποώτος καταλήγει από την πεοιστοοφική αντλία χαμηλού κενού στην τουομπομοοιακή υψηλού κενού, όπου και τοποθετείται μία βαλβίδα αποκοπής (βάνα κενού) για την διακοπή εφαομογής κενού. Ο δεύτερος συνδέεται με τον διπλό σταυρό KF40 μέσω σωλήνων εσωτεοικής διαμέτρου 6 mm, στους οποίους είναι εγκατεστημένες μία βάνα εισαγωγής αερίου και μία βάνα εξαέρωσης. Η πρώτη χρησιμοποιεί ένα πλαστικό σωληνάκι που καταλήγει σε ένα σύστημα ανάμειξης αερίων, ενώ η δεύτερη χρησιμεύει στην επαναφορά του ατμοσφαιοικού αέρα εντός της περιοχής του δείγματος μετά το τέλος της διεξαγωγής πειράματος άντλησης κενού.

Αυτή η εναλλακτική χρήση της διάταξης διάχυσης αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς προκύπτει η δυνατότητα εισαγωγής άλλων αερίων πέραν του οξυγόνου και μάλιστα στις επιθυμητές συστάσεις. Αυτό συμβαίνει διότι στην άλλη άκρη από το πλαστικό σωληνάκι εισάγεται το επιθυμητό αέριο (πχ υδρογόνο H_2) μέσω ενός συστήματος, το οποίο ρυθμίζει τις ροές και τις συστάσεις διαφορετικών αερίων που περιέχονται σε φιάλες κάνοντας χρήση του προγράμματος MATLAB σε Η/Υ.

Η συνδεσμολογία και οι αλλαγές της διάταξης διάχυσης φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:







Α**ριστερά: Βάνα εισαγωγής** αερίου

Δεξιά: Βάνα εξαέρωσης



Βάνα κενού στην τουρμπομοριακή αντλία



Πλαστικό σωληνάκι στη βάνα εισαγωγής αερίου, το οποίο εισάγεται ως αποτέλεσμα ενός συστήματος ανάμειξης αερίων

Εικόνα 47: Συνδεσμολογία για πείραμα αέριας διάχυσης με τη χρήση φιαλών αερίου

4 Βιβλιογραφία

1. Crank, J. The mathematics of Diffusion. 2nd . s.l. : Oxford, 1975.

2. Manning, J. Diffusion Kinetics for Atoms in Crystals. s.l. : D.van Nostrand Company INC.

3. Philibert, J. Atom movements: Diffusion and mass transport in solids. s.l.: Les editions de physique, 1989.

4. Secondary Mass Spectrometry in the Earth Sciences: Gleaning the big picture from a small spot . **Mostafa, Fayek.** [$\epsilon \pi \iota \mu$.] Department of Geological Sciences. s.l.: University of Manitoba Winnipeg, Mineralogical Association of Canada Short Course Series, Tóµ. 41.

5. **Hoffmann, E.de** και **Stroobant, V.** *Mass Spectrometry: Principles and Applications* . Third . s.l. : John Wiley and Sons, Ltd, 2007.

6. Secondary ion Mass spectrometry . **Kenway-Jackson, C.** s.l. : Vacuum, 1984, Τόμ. 34, σσ. 479-480.

7. *A comparison of SIMS with other techniques based on ion-beam solid interactions.* **Werner, H W και Boudewijn, P R.** s.l. : Vacuum, 1984, Τόμ. 34, σσ. 83-101.

8. Yttrium silicate system for oxidation protection of C/C-Si-SiC composites: Electrophoretic deposition and oxygen self-diffusion measurements. **Argirusis, Chr, Damjanovic, T και Borchardt, G.** s.l. : J. Eur. Ceram. Soc, 2007, Tóµ. 27, σσ. 1303-1306.

9. Y2SiO5 as oxidation resistant coating for C/C composites. **Ogura, Y, Kondo, M και Morimoto, T.** [επιμ.] A. Poursartip a. Whistler Canada : Woodhead Publishing Limited , 14-18 August 1995. Proceed-ings of the Tenth International Conference on Composite Materials. Τόμ. IV.

10. **Buckley, J D** $\kappa \alpha \iota$ **Edie, D D.** *Carbon–Carbon Materials and Composites* . [$\epsilon \pi \iota \mu$.] Park Ridge. New Jersey, USA : Noyes Publications, 1993.

11. Yttrium silicate oxidation protective coating for SiC coated carbon/carbon composites . Jian-Feng, H, $\kappa \alpha i \sigma \upsilon v$. 2006, Ceramics Internationa, Tóµ. 32, $\sigma \sigma$. 417-421.

5 Παράρτημα

5.1 Εγχειρίδιο χρήσης ρυθμιστή φούρνου

Mοντέλο Controller: Shimaden FP21-1V-00000

Εταιφεία Παφαγωγής: THERMAWATT Ο.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΙ

Διεύθυνση: Πυργιωτίσσης 10 – Περιστέρι

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5753587, 210 5742781

Μέγιστες επιτρεπόμενες ιδιότητες του φούρνου											
Τάση	220 V										
Θερμοκρασία	1200 °C										
Ισχύς	1 KW										
Ένταση φεύματος	4,55 A										

Πίνακας 3: Μέγιστες επιτρεπόμενες ιδιότητες του φούρνου

Thermocouple Type	Range (°C)
S	0 - 1700
K1	-100 - 400
K2	0 - 800
K3	0 – 1200
Е	0 - 700
J	0 - 600
Т	-199,99 – 200

Ν	0 – 1300
PL	0 – 1800
PR	0 – 1800
WR	0 – 2300
U	-199,99 – 200
L	0 - 600
В	0 – 1800
R	0 - 1700

Πίνακας 4: Οι Τύποι Θερμοστοιχείων και το αντίστοιχο Θερμοκρασιακό τους Εύρος

5.1.1 Εύρεση Τύπου Θερμοστοιχείου (TC)

Βήμα 1: Πατάμε το πλήκτοο **FUNC** x 5 φορές, που βρίσκεται στο Front Panel του Controller. Έτσι ώστε εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "6) INITIAL DATA".

Βήμα 2: Πατάμε το πλήκτο
ο FILE x 1 φορά ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη "PV FILTER: 0".

Βήμα 3: Πατάμε το πλήκτοο ITEM x 2 φορές ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη "OUT=V, T1=NON".

Βήμα 4: Πατάμε το πλήκτοο FILE x 2 φορές και φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα "TC RANGE: []". Τέλος, επιλέγουμε τον τύπο του θερμοστοιχείου χρησιμοποιώντας είτε το κάτω είτε το πάνω βελάκι και πατάμε ENTER. (βλ. Πίνακας 2).

5.1.2 Θερμοπρογραμματισμός Φούρνου

Αρχικά είναι σημαντικό να διασαφηνίσουμε τις έννοιες που αποτυπώνονται συντομογραφικά στο Front Panel του Controller:

FUNC=FUNCTION
P=PTN=PATTERN
S=STP=STEP
AT=AUTO TUNING
MAN=MANUALLY
PV=PRESENT VALUE
SV=SET VALUE
RST=REST
HLD=HOLD
AL=ALARM
ADV=ADVANCE

Πίνακας 5: Συντομογραφίες του Front Panel του Ρυθμιστή

Για το Στήσιμο του Προγράμματος ακολουθούμε την εξής σειρά βημάτων:

Βήμα 1: Πατάμε το πλήκτοο **FUNC** x 2 φορές, που βρίσκεται στο Front Panel του Controller. Έτσι ώστε εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "FUNC 3) Program data Pattern No: [1 έως 9]". Έπειτα επιλέγουμε τι αριθμό προγράμματος επιθυμούμε να ακολουθήσουμε και πατάμε **ENTER**(το '= 'γίνεται ':' και σημαίνει ότι η τιμή που βάλαμε καταχωρήθηκε). Πχ: No= 1 **ENTER** No: 1.

Βήμα 2: Πατάμε το πλήκτοο FILE x 1 φορά ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη "P1 Start SV: ...°C", που είναι η αρχική θερμοκρασία του φούρνου, συνήθως επιλέγουμε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, περίπου 25 °C. Σημειώνεται ότι το πάνω και κάτω βελάκι αυξομειώνουν τους αφιθμούς από 0 έως 9, ενώ πφοκειμένου να μεταπηδήσουμε από ψηφίο σε ψηφίο, πχ: από το 2 στο 5 αν πφόκειται για τους 25 °C χφησιμοποιούμε το σύμβολο που βρίσκεται ανάμεσα στα πλήκτφα των πάνω και κάτω βελών. Επίσης, πφοκειμένου να αυξομειωθεί ο αφιθμός των ψηφίων μιας τιμής, πχ από το 9 στα 10, χφησιμοποιούνται και πάλι τα βελάκια. Επιλέγουμε λοιπόν την αφχική θεφμοκφασία και πατάμε **ENTER**.

Βήμα 3: Πατάμε το πλήκτοο FILE x 2 φορές ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη "P1 PTN END:...". Σε αυτό το σημείο τοποθετούμε τον αριθμό των βημάτων(STP) μέσα στον οποίο θα τελειώσει ο θερμικός προγραμματισμός του φούρνου και πατάμε ENTER. Πχ: 9.

Βήμα 4: Πατάμε το πλήκτοο FILE x 2 φορές ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη "P1 SV=... °C, S1 Time=...h...m". Σε αυτό το σημείο τοποθετούμε αφενός τη θερμοκρασία που επιθυμούμε να φτάσει ο φούρνος και αφετέρου σε πόση ώρα θα πραγματοποιηθεί αυτή η άνοδος. Πχ: SV: 500 °C, S1 Time: 1h20m. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πατάμε 2 φορές ENTER.

Βήμα 5: Πατάμε το πλήκτοο **ITEM** x 1 φορά ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη "S2 Time=...h...m", όπου ουθμίζουμε σε πόσο χρονικό διάστημα επιθυμούμε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία που βάλαμε στο Βήμα 4. Πατάμε **ENTER**.

Η διαδικασία που ακολουθούμε στη συνέχεια είναι ανάλογη των Βημάτων 4 και 5, ώστε πατώντας διαδοχικά **ITEM** μεταφερόμαστε στα επόμενα STEPS(S) και ρυθμίζουμε αναλόγως τη θερμοκρασία και το χρόνο στον οποίον θα φτάσει σε αυτήν(πχ:S3), και το χρόνο στον οποίο θα σταθεροποιηθεί σε αυτήν(πχ:S4). Δηλαδή S3, S4,....S9.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα στα παραπάνω βήματα είναι απαραίτητο ο φούρνος να επιστρέψει ομαλά στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Δηλαδή σε έναν αντίστοιχο χρόνο με αυτόν που τον προγραμματίσαμε να πιάσει μια υψηλή θερμοκρασία. Ενδείκνυται για παράδειγμα ένας ρυθμός 5 °C/min.

Για να αρχίσει η **Λειτουργία του Προγράμματος** πρέπει οι αντιστάσεις να βρίσκονται στο **ON** (ο διακόπτης προς τα πάνω) και έπειτα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1: Πατάμε το πλήκτοο **FUNC** x 1 φορά, που βρίσκεται στο Front Panel του Controller. Έτσι ώστε εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "FUNC 2) EXEC KEY: [KEY]". Έπειτα, πατάμε το πλήκτρο **FILE** x 1 φορά ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη "Start PTN No:..". Σε αυτό το σημείο καταχωρούμε τον αριθμό του προγράμματος που επιθυμούμε να τρέξει ο Controller. Πχ: No=1 **ENTER** No:1. **Βήμα 2:** Πατώντας το πλήκτοο **FUNC** όσες φορές απαιτείται επιστρέφουμε κυκλικά στην ένδειξη "FUNC 2) EXEC KEY: [KEY]". Χρησιμοποιώντας το πάνω είτε το κάτω βελάκι βρίσκουμε την ένδειξη **[RUN]** και την καταχωρούμε πατώντας **ENTER.** Από αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει να τρέχει το πρόγραμμα που καταχωρήσαμε.

5.1.3 Χοήσιμες πληροφορίες

1) Κατά τη διάφκεια του προγράμματος ενδέχεται να χρειαστεί να σταματήσουμε σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία για παραπάνω χρονικό διάστημα απ' ότι ρυθμίσαμε. Αυτό επιτυγχάνεται καταχωρώντας στο μενού "FUNC 2) EXEC KEY: [KEY]" την ένδειξη [HLD]. Από τη στιγμή που θα θελήσουμε να συνεχίσει κανονικά η λειτουργία του προγράμματος μας πατάμε ξανά την ένδειξη [HLD] με ENTER και το HOLD απενεργοποιείται. Κάτι που μπορούμε να διακρίνουμε αφού η κόκκινη ένδειξη HLD στο panel σβήνει.

2) Ακόμα, αν θελήσουμε να περάσουμε στο επόμενο βήμα(STP) πιο σύντομα από τον απαιτούμενο χρόνο καταχωρούμε στο μενού "FUNC 2) EXEC KEY: [KEY]" την ένδειξη [ADV] πατώντας ENTER. Έτσι για παράδειγμα στις φωτεινές ενδείξεις του panel παρατηρούμε πχ την αλλαγή από S2 σε S3.

3) Άλλη μία προαιρετική καταχώρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι από το "FUNC 2) EXEC KEY: [KEY]" η επιλογή **[AT].** Κατά αυτό τον τρόπο, με το AUTO TUNING, εξασφαλίζουμε την ομαλή άνοδο/κάθοδο της θερμοκρασίας στο πρόγραμμα αφού αυτή ελέγχεται από τον PID ρυθμιστή.

4) Επίσης, αν για οποιοδήποτε λόγο δούμε στο front panel να αναβοσβήνει κόκκινη ένδειξη **AL1** ή **AL2**, αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιήθηκε η προειδοποίηση κινδύνου(ALARM) και άρα πρέπει να διακόψουμε άμεσα τη λειτουργία του προγράμματος.

5) Η άμεση διακοπή της λειτουργίας του προγράμματος επιτυγχάνεται αν καταχωρήσουμε στο μενού "FUNC 2) EXEC KEY: [KEY]" την ένδειξη **[RST]** πατώντας **ENTER**. Κατά αυτό τον τρόπο δεν πέφτει η θερμοκρασία εντός του φούρνου ελεγχόμενα όπως συνίσταται, ωστόσο το **[RST]** μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κίνδυνο.

6) Πατώντας το πλήκτοο FUNC όσες φορές απαιτείται επιστρέφουμε κυκλικά στην ένδειξη "FUNC 1)". Σε αυτή τη λειτουργία μπορούμε να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε πόσο % ρεύμα δίνει ο Controller προκειμένου να αυξήσει/μειώσει ή και διατηρήσει μία ορισμένη θερμοκρασία εντός του φούρνου. Συνακόλουθα, πατώντας το πλήκτρο FILE x 1 φορά διακρίνουμε τον χρόνο που απομένει ώστε να ολοκληρωθεί το τρέχων βήμα(STP) του προγράμματος. Τέλος, από εκείνο το σημείο, για να δούμε σε ποιο βήμα βρισκόμαστε πατάμε το πλήκτρο ITEM x 1 φορά ώστε δείχνει πχ: P1, S1.

5.2 Πίνακες αναφοράς για θερμοστοιχεία





Thermoelectric Voltage in Millivolts

*C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*C	1 °C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*C
1200	6.786	6.797	6.807	6.818	6.828	6.838	6.849	6.859	6.869	6.880	6.890	1200	1550	10.679	10.691	10,703	10.714	10,726	10.738	10,749	10.761	10.773	10.784	10.796	1550
1210	6.890	6.901	6.911	6.922	6.932	6.942	6.953	6.963	6.974	6.984	6.995	1210	1560	10.796	10.808	10.819	10.831	10.843	10.854	10.866	10.877	10.889	10.901	10.913	1560
1220	6.995	7.005	7.016	7.026	7.037	7.047	7.058	7.068	7.079	7.089	7.100	1220	1570	10.913	10.924	10.936	10.948	10.959	10.971	10.983	10.994	11.006	11.018	11.029	1570
1230	7.100	7.110	7.121	7.131	7.142	7.152	7.163	7.173	7.184	7.194	7.205	1230	1580	11.029	11.041	11.053	11.064	11.076	11.088	11.099	11.111	11.123	11.134	11.146	1580
1240	7.205	7.216	7.226	7.237	7.247	7.258	7.269	7.279	7.290	7.300	7.311	1240	1590	11.146	11.158	11.169	11.181	11.193	11.205	11.216	11.228	11.240	11.251	11.263	1590
4340	7744	7 333	7 3 3 3	7 242	7.747	7 704	7.376	7 308	7 200	7 40 7	7 4 4 7	473.805	1000	44.000	44.576	44 200	44 000	** 240	44 304	** 333	11.745	** 387	44 300	44.300	1000
12:00	7.211	7.322	7.332	7.043	7.533	7.304	7.575	7.300	7.090	7.407	7.417	12:00	1000	11.200	11.270	11.200	11.290	11.310	11.321	11.333	11.343	11.337	11.300	11.300	1000
1200	7.937	7.626	7.430	7.943	7.400	7.670	7.402	7.992	7.003	7.014	7.029	1200	1010	11.300	11.392	11,403	11.410	11.427	11,400	44.607	11.402	51.979	11.400	11.497	1010
1270	7.029	7.030	7.040	7.007	7.007	7.070	7.000	7.000	7.010	7 720	7.032	1270	1020	11.497	11.009	11.320	11.002	11.044	11.000	11.007	11.079	11,001	11.002	11.014	1020
1280	7.032	7.043	7 264	7 772	7 793	7 704	7.097	7.946	7.027	7.927	7.240	1280	16.40	11.014	11.626	11.03/	11.649	11.001	11.673	11.584	11.090	11,708	11.719	11.731	16.40
12:00	7.740	1.101	1.101	1.112	1.103	1.124	1.000	1.010	1.021	1.051	1/040	1230	1040	11.101	11.745	11.7.04	11.700	11.170	11.700	11.001	11.013	11.02.0	11.030	11.0+0	1040
1300	7.848	7.859	7.870	7.881	7.892	7.903	7.914	7.924	7.935	7.946	7.957	1300	16.50	11.848	11.860	11.871	11.883	11.895	11.907	11.918	11.930	11.942	11.953	11.965	1650
1310	7.957	7.968	7.979	7.990	8.001	8.012	8.023	8.034	8.045	8.056	8.066	1310	1660	11.965	11.977	11.968	12.000	12.012	12.024	12.035	12.047	12.059	12.070	12.082	1660
1320	8.066	8.077	8.088	8.099	8.110	8.121	8.132	8.143	8.154	8.165	8.176	1320	1670	12.082	12.094	12.105	12.117	12.129	12.141	12.152	12.164	12.176	12.187	12.199	1670
1330	8.176	8.187	8.198	8.209	8 2 2 0	8.231	8.242	8.253	8.264	8.275	8.286	1330	1680	12,199	12.211	12.222	12.234	12.246	12.257	12.269	12.281	12.292	12.304	12.316	1680
1340	8.286	8.298	8.309	8.320	8.331	8.342	8.353	8.364	8.375	8.386	8.397	1340	1690	12.316	12.327	12.339	12.351	12.363	12.374	12.386	12.398	12.409	12.421	12.433	1690
1350	8.397	8.408	8.419	8.430	8.441	8.453	8,464	8.475	8.486	8.497	8,508	1350	1700	12.433	12,444	12.456	12.468	12.479	12,491	12.503	12.514	12.526	12.538	12.549	1700
1360	8 508	8.519	8 530	8.542	8 553	8.564	8.575	8 586	8 597	8 608	8.620	1360	1710	12 549	12.561	12.572	12 584	12 596	12 607	12.619	12 631	12.642	12 6 5 4	12 666	1710
1370	8.620	8.631	8.642	8.653	8 664	8.675	8.687	8.698	8 709	8.720	8,731	13.70	1720	12.666	12.677	12.689	12,701	12,712	12.724	12.736	12 747	12,759	12.770	12,782	1720
1380	8 731	8.743	8 754	8.765	8 776	8 787	8 799	8 8 10	8.821	8.832	8.844	1380	1730	12 782	12 794	12.805	12817	12 829	12 840	12 852	12.863	12 875	12 887	12 898	1730
1390	8.844	8.855	8.866	8.877	8.889	8.900	8.911	8.922	8 934	8.945	8.956	1390	1740	12.898	12.910	12.921	12.933	12.945	12.956	12.968	12.980	12.991	13.003	13.014	1740
1400	8 6 56	8 96 7	8 6 70	8 990	9.001	0.013	0.024	0.035	9.047	0.059	0.060	1400	1750	13.014	13.026	13.037	13.049	13.061	13 072	13 084	13.095	13 107	13 119	13 130	1750
1410	9.069	9.080	9.092	9 103	9 114	9 126	9 137	9 148	9 160	9 171	9 182	1410	1760	13 130	13 142	13 153	13 165	13 176	13 1RR	13 200	13 211	13 223	13 234	13 246	1760
1420	9 182	9 19.4	9 205	9 216	9 228	9 239	9 251	9 262	9 273	9.285	9.296	1420	1770	13 246	13 257	13 269	13 280	13 292	13 304	13 315	13 327	13 338	13 350	13 361	1770
1430	9 296	9 307	9 3 19	9 330	9 342	9 3 53	9 364	9.376	9 387	9 398	9410	1430	1780	13 361	13 373	13 384	13 396	13 407	13 419	13 430	13 442	13 453	13 465	13 476	1780
1440	9.410	9.421	9.433	9.444	9.456	9.467	9.478	9.490	9.501	9.513	9.524	1440	1790	13.476	13.488	13.499	13.511	13.522	13.534	13.545	13.557	13.568	13.580	13.591	1790
	0.634	0.870	0.547	0.680	0.570	0.004	0.602	0.004	0.040	0.007	0.000		1000	42.854	42.000	12014	43.030	*****	43.040	43.000	12.072	43 003	43 694	40.700	1000
14:00	9.024	9.030	9.047	9.000	9.070	9.001	9.093	9.004	9.010	9.027	9,039	14:00	1000	13.091	13.003	13.019	13.020	13.037	13.049	13.000	13.072	13.003	13.099	13.706	1000
1460	9.639	9.600	9.662	9.673	9.684	9.695	9.707	9.719	9.730	9.742	9.703	1460	1810	13.706	13./1/	13.729	13.740	13.752	13.763	13.775	13.786	13.797	13.809	13.820	1810
1470	9.733	9.760	9.776	9.788	9.799	9.811	9.022	9.834	9.040	9.807	9.008	1470													
1480	9,868	9,880	10 007	9.903	9.914	9.926	9.937	9.949	9.961	9.972 10.088	9,984	1480													
1100	0.001	0.000	10.001	10.010	10,000	10.011	10,000	10.001	10.010	10.000	10,000	1100													
1500	10.099	10.111	10.122	10.134	10.145	10.157	10.168	10.180	10.192	10.203	10.215	1500													
1510	10.215	10.226	10.238	10.249	10.261	10.273	10.284	10.296	10.307	10.319	10.331	1510													
1520	10.331	10.342	10.354	10.365	10.377	10.389	10.400	10.412	10.423	10.435	10.447	1520													
1530	10.447	10.458	10.470	10.482	10.493	10.505	10.516	10.528	10.540	10.551	10.563	1530													
1540	10.563	10.575	10.586	10.598	10.609	10.621	10.633	10.644	10.656	10.668	10.679	1540													
*C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*C	*C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	°C

Z-213

Πίνακας 6: Πίνακας αναφοράς για θερμοστοιχεία τύπου Β

MAXIMUM TEMPERATURE RANGE Thermocouple Grade - 328 to 2282°F - 200 to 1250°C									+ Thermocouple Grade									Revised Thermocouple Reference Tables									
Extension Grade 32 to 392°F 0 to 200°C LIMITS OF ERROR (whichever is greater) Standard: 2.2°C or 0.75% Above 0°C 2.2°C or 2.0% Below 0°C Special: 1.1°C or 0.4% COMMENTS, BARE WIRE ENVIRONMENT: Clean Oxidizing and Inert; Limited Use in Vacuum or Reducing; Wide Temperature Range; Most Popular Calibration TEMPERATURE IN DEGREES °C REFERENCE JUNCTION AT 0°C							Nickel-Chromium vs. Nickel-Aluminum							0+ 0-	TYPE Reference Tables N.I.S.T. Monograph 175 Revised to ITS-90							7					
										The	moel	ectric V	oltage	in Mi	llivolts	5											
•C	-10	-9	-8	-7	-6	-5	4	-3	-2	-1	0	•c	*C 250	0 10 153	1 10.194	2 10.235	3 10.276	4 10.316	5 10.357	6 10.398	7 10.439	8 10.480	9 10.520	10 10.561	*C 250		
													260	10.561	10.602	10.643	10.684	10.725	10.766	10.807	10.848	10.889	10.930	10.971	260		
										2017			270	10.971	11.012	11.053	11.094	11.135	11.176	11.217	11.259	11.300	11.341	11.382	270		
-260	-6.458	-6.457	-6.405	-6.455	-6.403	-6.452	-6.450	-6.448	-6.446	-5.444	-6.441	-260	280	11.382	11.423	11.465	11.505	11.547	11.588	11.630	11.671	11.712	11.753	11.795	280		
-250	-0.441	-0.438	-0.435	-0.432	-0.429	-0.425	-0.421	-0.417	-0.413	-0.408	-b.404	-200	290	11.790	11.836	11.877	11,919	11.960	12.001	12.043	12.084	12.126	12.167	12.209	230		
						1000											+0.000										
-240	-6.404	-6.399	-6.393	-6.388	-6.382	-6.377	-6.370	-6.364	-6.358	-6.301	-6.344	-240	300	12,209	12.250	12.291	12.333	12.374	12.416	12.457	12.499	12.540	12.582	12.624	300		
-240 -230	-6.404 -6.344	-6.399 -6.337	-6.393	-6.388 -6.322	-6.382	-6.377	-6.370	-6.364 -6.289	-6.358	-6.271	-6.262	-240	300	12.209	12.250	12.291	12.333	12.374	12.416	12.457	12.499	12.540 12.956	12.582 12.998	12.624 13.040	300 310		

-230	-0.344	-0.337	-0.329	-6.32Z	-0.314	-6.306	-6.297	-6.7.88	-6.280	-6.271	-0.202	-230	310	12.624	12.660	12.707	12.748	12.790	12.831	12.873	12.910	12.906	12.998	13.040	310
-220	-6.262	-6.252	-6.243	-6.233	-6.223	-6.213	-6.202	-6.192	-6.181	-6.170	-6.158	-220	320	13.040	13.081	13.123	13.165	13.205	13.248	13.290	13.331	13.373	13.415	13.457	320
-210	-6.158	-6.147	-6.135	-6.123	-6.111	-6.099	-6.087	-6.074	-6.061	-6.048	-6.035	-210	330	13.457	13,498	13.540	13.582	13.624	13.665	13,707	13,749	13.791	13.833	13.874	330
-200	-6.035	-6.021	-6.007	-5.994	-5.980	-5.965	-5.951	-5.936	-5.922	-5.907	-5.891	-200	340	13.874	13.916	13.958	14.000	14.042	14.084	14.126	14.167	14.209	14.251	14.293	340
-190	-5.891	-5.876	-5.861	-5.845	-5.829	-5.813	-5.797	-5.780	-5.763	-5.747	-5.730	-190	350	14,293	14.335	14.377	14.419	14.461	14.503	14.545	14.587	14.629	14.671	14,713	350
-180	-5 730	-5713	-5695	-5678	-5660	-5642	-5624	-5606	-5 588	-5 569	-5 550	-180	360	14 713	14 755	14 797	14 839	14 881	14 923	14 965	15 007	15 049	15 091	15 133	360
-170	-5.550	-5.531	-5.512	-5493	-5474	-5454	-5435	-5415	-5395	-5.374	-5354	-170	370	15 133	15.175	15217	15,259	15301	15.343	15385	15427	15.469	15.511	15 554	370
-160	-5354	-5 333	.5313	-5 292	-5271	-5.250	.5228	-5207	-5 185	-5 163	.5 141	-160	380	15 554	15 595	15638	15680	15 722	15 754	15 806	15 849	15 891	15 933	15 975	380
150	5144	5110	5 007	5 074	5.052	5 020	5.000	4 983	4.960	1 000	4 013	150	300	15 975	16 017	16.050	16 102	16 144	10.104	16 228	16 270	16 212	16 355	16 307	300
100	-0.141	-0.110	-0.001	-3.014	-0.004	-0.06.0	-5.000	-4.000	-4.000	4.000	-4.013	-1.00	330	10.070	10.011	10.000	FO. TWE	10.144	10.100	10.220	10.210	10.010	10.505	10.207	300
-140	-4.913	-4.889	-4.865	-4.841	-4.817	-4.793	-4.768	-4.744	-4.719	-4.694	-4.669	-140	400	16.397	16.439	16.482	16.524	16.566	16.608	16.651	16.693	16.735	16.778	16.820	400
-130	-4.669	-4.644	-4.618	-4.593	-4.567	-4.542	-4.516	-4.490	-4.463	-4.437	-4.411	-130	410	16.820	16.862	16.904	16.947	16.989	17.031	17.074	17.116	17.158	17.201	17.243	410
-120	-4.411	-4.384	-4.357	-4.330	-4.303	-4.276	-4.249	-4.221	-4.194	-4.166	-4.138	-120	420	17.243	17.285	17.328	17.370	17.413	17.455	17.497	17.540	17.582	17.624	17.667	420
-110	-4.138	-4.110	-4.082	-4.054	-4.025	-3.997	-3.968	-3.939	-3.911	-3.882	-3.852	-110	430	17.667	17.709	17.752	17.794	17.837	17.879	17.921	17.964	18.006	18.049	18.091	430
-100	-3.852	-3.823	-3.794	-3.764	-3.734	-3.705	-3.675	-3.645	-3.614	-3.584	-3.554	-100	440	18.091	18.134	18.176	18,218	18.261	18.303	18.346	18.388	18.431	18.473	18.516	440
-90	-3.554	-3.523	-3.492	-3.462	-3.431	-3.400	-3.368	-3.337	-3.306	-3.274	-3.243	-90	450	18.516	18.558	18.601	18.643	18.686	18.728	18.771	18.813	18.856	18.898	18.941	450
-80	-3.243	-3.211	-3.179	-3.147	-3.115	-3.083	-3.050	-3.018	-2.986	-2.953	-2.920	-80	460	18.941	18.983	19.026	19.068	19.111	19.154	19.196	19.239	19.281	19.324	19.366	460
-70	-2.920	-2.887	-2.854	-2.821	-2.788	-2.755	-2.721	-2.688	-2.654	-2.620	-2.587	-70	470	19.366	19.409	19.451	19.494	19.537	19.579	19.622	19.664	19,707	19.750	19.792	470
-60	-2.587	-2.553	-2.519	-2.485	-2.450	-2.416	-2 382	-2.347	-2.312	-2.278	-2.243	-60	480	19,792	19.835	19.877	19.920	19.962	20.005	20.048	20.090	20.133	20.175	20.218	480
-50	-2.243	-2.208	-2.173	-2.138	-2.103	-2.067	-2.032	-1.996	-1.961	-1.925	-1.889	-50	490	20.218	20.261	20.303	20.346	20.389	20.431	20.474	20.516	20.559	20.602	20.644	490
10	1 000	* 054	1 010	4 700	* 745	4 700	4.072	4 6 9 7	1000	1.62.4	4 607	10	600	20.044	20.097	20.720	20.773	20.945	20.957	20.000	20.042	20.005	24.029	24.074	500
-40	-1.009	-1.004	-1.010	-1.702	1 290	4 242	-1.073	+ 369	-1.000	-1.004	-1.027	-40	510	20.044	20.007	20.730	20.772	20.010	20.007	20.900	20.043	20.000	21.020	21.0/1	510
-30	+ 4.60	-1/490	+ 0.04	4.042	+ 000	-1.393	-1.300	-1.200	-1.231	-1,194	-1.130	-30	510	21.0/1	21.113	21.130	21.199	21.241	21.204	21.320	21.309	21.412	21.9.09	21.49/	510
-20	-1,100	-1.119	-1.001	-1.043	-1.000	-0.300	-0.930	-0.032	-0.004	-0.010	-0.770	-20	520	21.497	21.040	21,562	21.625	21.900	21.710	21.753	21.790	21.038	21.001	21.924	520
-10	-0.778	-0.739	-0.701	-0.003	-0.624	-0.300	-0.347	-0.508	-0.470	-0.431	-0.392	-10	530	21.924	21.966	22.009	22.052	22.094	22.137	22.179	22.222	22.265	22.307	22.350	530
0	-0.392	-0.303	-0.314	-0.275	-0.236	-0.197	-0.107	-0.118	-0.0/9	-0.039	0.000	0	540	22.350	22.393	22.435	22.478	22.521	22.563	22.606	22.649	22.691	22.734	22.776	540
0	0.000	0.039	0.079	0.119	0.158	0.198	0.238	0.277	0.317	0.357	0.397	0	550	22.776	22.819	22.862	22,904	22.947	22.990	23.032	23.075	23.117	23.160	23.203	550
10	0.397	0.437	0.477	0.517	0.557	0.597	0.637	0.677	0.718	0.758	0.798	10	560	23,203	23.245	23.288	23.331	23.373	23.416	23.458	23.501	23.544	23.586	23.629	560
20	0.798	0.838	0.879	0.919	0.960	1.000	1.041	1.081	1.122	1.163	1.203	20	570	23.629	23.671	23.714	23.757	23,799	23.842	23.884	23.927	23.970	24.012	24.055	570
30	1.203	1.244	1.285	1.326	1.366	1.407	1.448	1.489	1.530	1.571	1.612	30	580	24.055	24.097	24.140	24.182	24.225	24.267	24.310	24.353	24.395	24.438	24.480	580
40	1.612	1.653	1.694	1.735	1.776	1.817	1.858	1.899	1.941	1.982	2.023	40	590	24.480	24.523	24.565	24.608	24.650	24.693	24.735	24.778	24.820	24.863	24.905	590
50	2.023	2.064	2.106	2.147	2.188	2.230	2.271	2.312	2.354	2.395	2.436	50	600	24.905	24.948	24.990	25.033	25.075	25.118	25.160	25.203	25.245	25.288	25.330	600
60	2.436	2.478	2.519	2.561	2.602	2.644	2.685	2.727	2.768	2.810	2.851	60	610	25330	25.373	25.415	25.458	25.500	25.543	25.585	25.627	25670	25.712	25.755	610
70	2.851	2.893	2.934	2.976	3.017	3.059	3.100	3.142	3.184	3.225	3.267	70	620	25.755	25.797	25.840	25.882	25.924	25.967	26.009	26.052	26.094	26.136	26.179	620
80	3.267	3.308	3.350	3.391	3.433	3.474	3.516	3.557	3.599	3.640	3.682	80	630	26.179	26.221	26.263	26.306	26.348	26.390	26.433	26.475	26.517	26.560	26.602	630
90	3.682	3.723	3.765	3.806	3.848	3.889	3.931	3.972	4.013	4.055	4.095	90	640	26.602	26.644	26.687	26.729	26.771	26.814	26.856	26.898	26.940	26.983	27.025	640
100	4 006	4 120	4 170	4 220	4 262	4 202	4.244	4 2 9 5	1 427	4 46.9	4 500	100	650	27 025	27.067	27 100	27 152	27 104	27.226	27 279	27 320	27 262	27.405	27.447	650
110	4 500	4.100	4 501	4.633	4.674	4 715	4 756	4 707	4.938	4,400	4 920	110	660	27 447	27480	37 531	27.574	27616	27658	27 700	37 742	27 784	27 826	27 860	660
120	4.000	4.001	5.002	5.042	5.094	5.124	5 105	5200	5247	5 200	5 3 2 9	120	620	27.941	27.405	27.051	27.005	28.097	28.070	29.100	28 462	28 205	28.247	20.200	670
130	5328	5360	5410	5450	5.401	5 532	5.573	5613	5653	5604	5 735	120	680	28 280	28 932	28 374	28.416	28.458	28 500	28.542	28 584	28626	28668	28 710	680
140	6 726	6 776	5.015	6.050	5 000	5.002	5.077	6.047	0.000	0.004	£ 130	140	600	20,200	20.002	20.374	20,410	20.430	20.000	20.042	20.004	20.046	20.000	20.110	600
140	0.750	5.115	0.010	0.000	3.630	0.997	5.911	0.017	0.000	0.090	0.130	140	650	20.110	20.732	20.134	20.000	20.011	20.010	20.301	29.005	23.045	29.007	20.120	630
150	6.138	6.179	6.219	6.259	6.299	6.339	6.380	6.420	6.460	6.500	6.540	150	700	29.129	29.171	29.213	29.255	29.297	29.338	29.380	29.422	29.464	29.506	29.548	700
160	6.540	6.580	6.620	6.660	6.701	6.741	6.781	6.821	6.861	6.901	6.941	160	710	29.548	29.589	29.631	29.673	29,715	29.757	29.798	29.840	29.882	29.924	29.965	710
170	6.941	6.981	7.021	7.060	7.100	7.140	7.180	7.220	7.260	7.300	7.340	170	720	29.965	30.007	30.049	30.090	30.132	30.174	30.216	30.257	30.299	30.341	30.382	720
180	7.340	7.380	7.420	7.460	7.500	7.540	7.579	7.619	7.659	7.699	7.739	180	730	30.382	30.424	30.466	30.507	30.549	30.590	30.632	30.674	30.715	30.757	30.798	730
190	7.739	7.779	7.819	7.859	7.899	7.939	7.979	8.019	8.059	8.099	8.138	190	740	30.796	30.840	30.881	30.923	30.964	31.006	31.047	31.089	31.130	31.172	31.213	740
200	8.138	8.178	8.218	8258	829R	8338	8378	8.418	8.458	8.499	8 539	200	750	31.213	31,255	31 296	31.338	31.379	31.421	31 462	31.504	31.545	31.586	31.62R	750
210	8.539	8.579	8.619	8.659	8699	8.739	8.779	8.819	8.860	8.900	8.940	210	76.0	31.628	31.669	31.710	31.750	31.793	31.834	31.87%	31.917	31.95R	32 000	32.041	760
220	8 940	8 980	9.020	9.061	9 101	9141	9 181	9.222	9 262	9 302	9343	220	770	32 041	32 082	32 124	32 165	32 206	32 247	32 289	32 330	32 371	32 412	32 453	770
230	9.343	9.383	9.423	9.464	9.504	9.545	9.585	9.626	9.666	9.707	9.747	230	780	32 4 53	32.495	32 536	32.577	32.618	32.659	32,700	32,742	32 783	32 824	32.865	780
240	9 747	9 788	9 828	9.869	9 909	9.950	9 991	10 031	10 072	10 113	10 153	240	790	32 865	32 906	32 947	32 988	33 029	33 070	33 111	33 152	33 193	33 234	33 275	790
	100 B 100 B								Ro	we want the								W	V						

10 °C °C 0 Z-204 3

4 5 6 7 8 9

1 2

10 °C

9

*C 0

1 2 3

4 5

6 7 8



Thermoelectric Voltage in Millivolts

*C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*C	*C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*C
800	33.275	33.316	33.357	33.398	33.439	33.480	33.521	33.562	33.603	33,644	33.685	800	1100	45.119	45.157	45.194	45.232	45.270	45.308	45.346	45.383	45.421	45.459	45.497	1100
810	33.685	33,726	33.767	33.808	33.848	33.889	33.930	33.971	34.012	34.053	34.093	810	1110	45.497	45.534	45.572	45.610	45.647	45.685	45.723	45.760	45.798	45.836	45.873	1110
820	34.093	34.134	34.175	34,216	34.257	34,297	34.338	34.379	34.420	34.460	34,501	820	1120	45.873	45.911	45.948	45.986	46.024	46.061	46.099	46.136	46.174	46.211	46.249	1120
830	34.501	34.542	34.582	34.623	34.664	34.704	34.745	34.786	34.826	34.867	34,908	830	1130	46.249	46.286	46.324	46.361	46.398	46.436	46.473	46.511	46.548	46.585	46.623	1130
840	34.908	34.948	34.989	35.029	35.070	35.110	35.151	35.192	35.232	35.273	35.313	840	1140	46.623	46.660	46.697	46.735	46.772	46.809	46.847	46.884	46.921	46.958	46.995	1140
850	35.313	35.354	35.394	35.435	35.475	35.516	35.556	35.596	35.637	35.677	35.718	850	1150	46.995	47.033	47.070	47.107	47.144	47.181	47.218	47.256	47.293	47.330	47.367	1150
860	35.718	35.758	35.798	35.839	35.879	35.920	35.960	36.000	36.041	36.081	36.121	860	1160	47.367	47.404	47.441	47.478	47.515	47.552	47.589	47.626	47.663	47.700	47.737	1160
870	36.121	36.162	36.2.02	36.242	36.282	36.323	36.363	36.403	36.443	36.484	36.524	870	1170	47.737	47.774	47.811	47.848	47.884	47.921	47,958	47.995	48.032	48.069	48.105	1170
880	36.524	36.564	36.604	36.644	36.685	36.725	36.765	36.805	36.845	36.885	36.925	880	1180	48.105	48.142	48.179	48.216	48252	48.289	48.326	48.363	48.399	48.436	48.473	1180
890	36.925	36.965	37.005	37.046	37.086	37.126	37.166	37.206	37.246	37,286	37.326	890	1190	48.473	48.509	48,546	48.582	48.619	48.656	48.692	48.729	48.765	48.802	48.838	1190
900	37.326	37.366	37.406	37.446	37.486	37.526	37.566	37.606	37.646	37.686	37.725	900	1200	48.838	48.875	48.911	48.948	48.984	49.021	49.057	49.093	49.130	49.166	49.202	1200
910	37.725	37.765	37.805	37.845	37.885	37.925	37.965	38.005	38.044	38.084	38.124	910	1210	49.202	49.239	49.275	49.311	49.348	49.384	49.420	49.456	49.493	49.529	49.565	1210
920	38.124	38.164	38.204	38.243	38.283	38.323	38.363	38.402	38.442	38.482	38.522	920	1220	49.565	49.601	49.637	49.674	49.710	49.746	49.782	49.818	49.854	49.890	49.926	1220
930	38.522	38.561	38.601	38.641	38.680	38.720	38.760	38,799	38.839	38.878	38.918	930	1230	49.926	49.962	49.998	50.034	50.070	50.106	50.142	50.178	50.214	50.250	50.286	1230
940	38.918	38.958	38.997	39.037	39.076	39.116	39,155	39.195	39.235	39.274	39.314	940	1240	50.286	50.322	50.358	50.393	50.429	50.465	50.501	50.537	50.572	50.608	50.644	1240
950	39.314	39.353	39.393	39.432	39.471	39.511	39.550	39.590	39.629	39.669	39.708	950	1250	50.644	50.680	50.715	50.751	50.787	50.822	50.858	50.894	50.929	50.965	51.000	1250
960	39.708	39.747	39.787	39.826	39.866	39.905	39.944	39.984	40.023	40.062	40.101	960	1260	51.000	51.036	51.071	51.107	51.142	51.178	51.213	51.249	51.284	51.320	51.355	1260
970	40.101	40.141	40.180	40.219	40.259	40.298	40.337	40.376	40.415	40.455	40.494	970	1270	51.355	51.391	51.426	51.461	51.497	51.532	51.567	51.603	51.638	51.673	51.708	1270
980	40.494	40.533	40.572	40.611	40.651	40.690	40.729	40.768	40.807	40.846	40.885	980	1280	51.708	51.744	51.779	51.814	51.849	51.885	51.920	51.955	51.990	52.025	52.060	1280
990	40.885	40.924	40.963	41.002	41.042	41.081	41.120	41.159	41.198	41.237	41.276	990	1290	52.060	52.095	52.130	52.165	52.200	52 235	52.270	52.305	52.340	52.375	52.410	1290
1000	41.276	41.315	41.354	41.393	41.431	41.470	41.509	41.548	41.587	41.626	41.665	1000	1300	52.410	52.445	52.480	52.515	52.550	52.585	52.620	52.654	52.689	52.724	52.759	1300
1010	41.665	41.704	41 743	41.781	41,820	41.859	41.898	41.937	41,976	42.014	42.053	1010	1310	52.759	52.794	52.828	52.863	52.896	52,932	52.967	53.002	53.037	53.071	53.106	1310
1020	42.053	42.092	42.131	42.169	42.208	42.247	42.286	42.324	42.363	42.402	42.440	1020	1320	53.106	53.140	53.175	53,210	53.244	53.279	53.313	53.348	53.382	53.417	53.451	1320
1030	42.440	42.479	42.518	42.555	42.595	42.633	42.672	42.711	42.749	42.788	42.826	1030	1330	53.451	53,486	53.520	53.555	53.589	53.623	53.658	53.692	53.727	53.761	53.795	1330
1040	42.826	42.865	42.903	42.942	42.980	43.019	43.057	43.096	43.134	43.173	43.211	1040	1340	53.795	53.830	53.864	53.898	53.932	53.967	54.001	54.035	54.069	54.104	54.138	1340
1050	43.211	43.250	43.288	43.327	43.365	43.403	43.442	43 480	43.518	43.557	43,595	1050	1350	54.138	54.172	54.206	54.240	54.274	54.308	54.343	54.377	54.411	54.445	54.479	1350
1060	43.595	43.633	43.672	43.710	43.748	43.787	43.825	43.863	43.901	43.940	43.978	1060	1360	54.479	54.513	54.547	54.581	54.615	54.649	54.683	54.717	54.751	54.785	54.819	1360
1070	43.978	44.016	44.054	44.092	44.130	44.169	44.207	44.245	44.283	44.321	44.359	1070	1370	54.819	54.852	54.886									1370
1080	44.359	44.397	44.435	44.473	44.512	44.550	44.588	44.626	44.664	44.702	44.740	1080													
1090	44.740	44.778	44.816	44.853	44.891	44.929	44.967	45.005	45.043	45.081	45.119	1090													
*C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*C	*C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	*C

Z-205

Πίνακας 7: Πίνακας αναφοράς για θερμοστοιχεία τύπου Κ